



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 апреля 2013 г. № 359

МОСКВА

О внесении изменений в федеральную целевую программу "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы

Правительство Российской Федерации **п о с т а н о в л я е т :**

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. № 809 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 51, ст. 6361; 2009, № 9, ст. 1130; 2011, № 38, ст. 5383).

Председатель Правительства
Российской Федерации



Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 22 апреля 2013 г. № 359

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в федеральную целевую программу
"Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники"
на 2008 - 2015 годы

1. В паспорте Программы:

а) в абзаце пятом позиции, касающейся важнейших целевых индикаторов и показателей, цифры "114" заменить цифрами "112";

б) в позиции, касающейся объемов и источников финансирования Программы:

в абзаце первом цифры "179224,366" заменить цифрами "175613,905";

в абзаце втором цифры "106844,71" заменить цифрами "104663,296", цифры "63908,3" заменить цифрами "62686,506", цифры "42936,41" заменить цифрами "41976,79";

в абзаце третьем цифры "72379,656" заменить цифрами "70950,609";

в) в абзаце тринадцатом позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации Программы и показателей социально-экономической эффективности, цифры "203443,4" заменить цифрами "196247,7", цифры "131640" заменить цифрами "125754,3".

2. В абзаце четвертом подраздела, касающегося целевых индикатора и показателей реализации Программы, раздела II:

а) в предложении третьем слова "в 41 организации" заменить словами "в 43 организациях";

б) предложение пятое изложить в следующей редакции: "Также к 2015 году в 19 организациях Министерства образования и науки Российской Федерации, Федерального космического агентства и Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", производящих продукцию в интересах радиоэлектронного комплекса,

будут созданы центры проектирования, а в 15 - осуществлены реконструкция и техническое перевооружение."

3. В разделе IV:

а) в абзаце первом цифры "179224,366" заменить цифрами "175613,905";

б) в абзаце втором цифры "106844,71" заменить цифрами "104663,296";

в) в абзаце третьем цифры "63908,3" заменить цифрами "62686,506";

г) в абзаце четвертом цифры "42936,41" заменить цифрами "41976,79";

д) в абзаце пятом цифры "72379,656" заменить цифрами "70950,609";

е) в абзаце седьмом цифры "32500" заменить цифрами "32215,149".

4. В разделе VI:

а) в абзаце пятом цифры "203443,4" заменить цифрами "196247,7";

б) в абзаце шестом цифры "64554,9" заменить цифрами "66746,5";

в) в абзаце седьмом цифры "131640" заменить цифрами "125754,3";

г) в абзаце девятом цифры "1,54" заменить цифрами "1,57".

5. Приложения № 1 - 4 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к федеральной целевой программе "Развитие
электронной компонентной базы и
радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 22 апреля 2013 г. № 359)

ИНДИКАТОР И ПОКАЗАТЕЛИ

**реализации мероприятий федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы
и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы**

	Единица измерения	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Индикатор										
Достижимый технологический уровень электроники	мкм	0,18	0,18	0,13	0,13	0,09	0,09	0,09	0,09	0,045
Показатели										
Увеличение объемов продаж изделий электронной и радиоэлектронной техники	млрд. рублей	19	58	70	95	130	170	210	250	300

	Единица измерения	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Количество разработанных базовых технологий в области электронной компонентной базы и радиоэлектроники (нарастающим итогом)	-	3 - 5	16 - 20	80 - 90	125 - 135	179 - 185	210	230	250	260 - 270
Количество объектов реконструкции и технического перевооружения производств для создания базовых центров системного проектирования в организациях Минпромторга России (нарастающим итогом)	-	1	8	10	14	29	29	30	35	44
Количество объектов реконструкции и технического перевооружения производств для создания базовых центров системного проектирования в организациях Госкорпорации "Росатом", производящих продукцию в интересах радиоэлектронного комплекса (нарастающим итогом)	-	-	-	-	-	1	1	1	3	4

	Единица измерения	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Количество объектов реконструкции и технического перевооружения производств для создания базовых центров системного проектирования в организациях Роскосмоса, производящих продукцию в интересах радиоэлектронного комплекса (нарастающим итогом)	-	-	-	-	-	-	1	2	4	6
Количество объектов реконструкции и технического перевооружения производств для создания базовых центров системного проектирования в организациях Минобрнауки России, производящих продукцию в интересах радиоэлектронного комплекса (нарастающим итогом)	-	-	1	1	2	2	3	5	7	9
Количество объектов реконструкции и технического перевооружения радиоэлектронных производств в организациях Минпромторга России (нарастающим итогом)	-	-	1	5	8	18	22	34	37	96

	Единица измерения	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Количество объектов реконструкции и технического перевооружения радиоэлектронных производств в организациях ФСТЭК России (нарастающим итогом)	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
Количество объектов реконструкции и технического перевооружения радиоэлектронных производств в организациях Госкорпорации "Росатом", производящих продукцию в интересах радиоэлектронного комплекса (нарастающим итогом)	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8
Количество объектов реконструкции и технического перевооружения радиоэлектронных производств в организациях Роскосмоса, производящих продукцию в интересах радиоэлектронного комплекса (нарастающим итогом)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7

	Единица измерения	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Количество завершенных поисковых технологических научно-исследовательских работ (нарастающим итогом)	-	1	3	9	9 - 10	10 - 12	12 - 14	14 - 16	16 - 18	20 - 22
Количество реализованных мероприятий по созданию электронной компонентной базы, соответствующей мировому уровню (типов, классов новой электронной компонентной базы) (нарастающим итогом)	-	4	11 - 12	16 - 20	22 - 25	36 - 40	41 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60
Количество создаваемых рабочих мест (нарастающим итогом)	-	450	1020 - 1050	1800 - 2200	3000 - 3800	3800 - 4100	4100 - 4400	4400 - 4700	4700 - 5000	5000 - 6000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к федеральной целевой программе
"Развитие электронной компонентной базы
и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 22 апреля 2013 г. № 359)

П Е Р Е Ч Е Н Ь

**мероприятий федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники"
на 2008 - 2015 годы**

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе					Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	

I. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

Направление 1. Сверхвысокочастотная электроника

1. Разработка технологий производства мощных сверхвысокочастотных транзисторов на основе гетероструктур материалов группы АзВ5	<u>128,624</u> 84	<u>66</u> 44	<u>62,624</u> 40						создание базовой технологии производства мощных сверхвысокочастотных транзисторов на основе гетероструктур материалов группы АзВ5 для бортовой и наземной аппаратуры (2009 год),
--	----------------------	-----------------	---------------------	--	--	--	--	--	--

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	

2. Разработка базовой технологии производства монолитных сверхвысокочастотных микросхем и объемных приемопередающих сверхвысокочастотных субмодулей X-диапазона	<u>202</u> 134	<u>30,5</u> 20	<u>39,5</u> 26	<u>53,25</u> 35,5	<u>31,8</u> 21,2	<u>46,95</u> 31,3			разработка комплектов документации в стандартах единой системы конструкторской, технологической и производственной документации, ввод в эксплуатацию производственной линии
									создание базовой технологии производства монолитных сверхвысокочастотных микросхем и объемных приемопередающих сверхвысокочастотных субмодулей X-диапазона на основе гетероструктур материалов группы A ₃ B ₅ для бортовой и наземной аппаратуры радиолокации, средств связи

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	
3. Разработка базовой технологии производства мощных сверхвысоко- частотных полупроводнико- вых приборов на основе нитридных гетеро- эпитаксиальных структур	<u>212,75</u> 134,75	<u>71</u> 47							создание технологии производства мощных транзисторов сверхвысокочастот- ного диапазона на основе нитридных гетероэпитаксиаль- ных структур для техники связи, радиолокации (2009 год)
4. Разработка базовой технологии и библиотеки элементов для проектирования и производства	<u>531</u> 375	<u>20</u> 17	<u>77,5</u> 65	<u>163,5</u> 109	<u>118</u> 80	<u>152</u> 104			создание технологий производства на основе нитридных гетероэпитаксиаль- ных структур мощных

(2013 год), разработка комплектов документации в стандартах единой системы конструкторской, производственной документации, ввод в эксплуатацию производственной линии

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	
<p>монолитных интегральных схем сверхвысоко- частотного диапазона на основе нитридных гетерозитакси- альных структур</p>									сверхвысокочастот- ных монолитных интегральных схем с рабочими частотами до 20 ГГц для техники связи, радиолокации (2013 год), разработка комплектов документации в стандартах единой системы конструкторской, технологической и производственной документации, ввод в эксплуатацию производственной линии
<p>5. Разработка базовой технологии производства сверхвысоко- частотных компонентов и сложно- функциональных блоков для сверхвысоко- частотных</p>	<p>149,257 101,7</p>	<p>63,5 42</p>	<p>85,757 59,7</p>						создание базовой технологии производства компонентов для сверхвысокочастот- ных интегральных схем диапазона 2 - 12 ГГц с высокой степенью интеграции для аппаратуры радиолокации и связи

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	
интегральных схем высокой степени интеграции на основе гетероструктур "кремний - германий"									торгового и наземного применения, а также бытовой и автомобильной электроники (2009 год), разработка комплектов документации в стандартах единой системы конструкторской, технологической и производственной документации, ввод в эксплуатацию производственной линии
6. Разработка базовой технологии производства сверхвысоко- частотных интегральных схем высокой степени интеграции на основе гетероструктур "кремний - германий"	<u>248,55</u> 158,1	<u>5,6</u> 5	<u>65,8</u> 35	<u>177,15</u> 118,1					создание базовой технологии производства сверхвысокочастот- ных интегральных схем диапазона 2 - 12 ГГц с высокой степенью интеграции для аппаратуры радиолокации и связи бортового и наземного

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	

7. Разработка аттестованных библиотек сложнo-функциональных блоков для проектирования сверхвысоко-частотных и радиочастотных интегральных схем на основе гетероструктур "кремний - германий"	448,408	195,408							применения, а также бытовой и автомобильной электроники (2011 год), разработка комплектов документации в стандартах единой системы конструкторской, технологической и производственной документации, ввод в эксплуатацию производственной линии
	308,75	139,75							разработка аттестованных библиотек сложнo-функциональных блоков для проектирования широкого спектра сверхвысокочастотных интегральных схем на SiGe с рабочими частотами до 150 ГГц, разработка комплектов

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	
8. Разработка базовых технологий проектирования кремний-германиевых сверхвысокочастотных и радиочастотных интегральных схем на основе аттестованной библиотеки сложно-функциональных блоков	<u>217,44</u> 142	47 30	<u>80,09</u> 52	<u>58,95</u> 39,3	<u>17</u> 11,3	<u>14,4</u> 9,4		документации в стандартах единой системы конструкторской, технологической и производственной документации, ввод в эксплуатацию производственной линии
								создание базовых технологий проектирования на основе библиотеки сложнофункциональных блоков широкого спектра сверхвысокочастотных интегральных схем на SiGe с рабочими частотами до 150 ГГц (2013 год), разработка комплектов документации в стандартах единой системы конструкторской, технологической и производственной

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	

9. Разработка базовых технологий производства элементной базы для ряда силовых герметичных модулей высокоплотных источников вторичного электропитания вакуумных и твердотельных сверхвысоко-частотных приборов и узлов аппаратуры	<u>114,9</u> 74	<u>60</u> 40	<u>54,9</u> 34						документации, ввод в эксплуатацию производственной линии
									создание базовых технологий производства элементной базы для высокоплотных источников вторичного электропитания сверхвысоко-частотных приборов и узлов аппаратуры (2009 год), разработка комплектов документации в стандартах единой системы конструкторской и технологической и производственной документации, ввод в эксплуатацию производственной линии

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	
10. Разработка базовых технологий производства ряда силовых герметичных модулей высокоплотных источников вторичного электропитания вакуумных и твердотельных сверхвысоко-частотных приборов и узлов аппаратуры	$\frac{126,913}{73,1}$			$\frac{79,513}{41,5}$	$\frac{47,4}{31,6}$				создание базовых конструкций и технологии производства высокоэффективных, высокоплотных источников вторичного электропитания сверхвысокочастотных приборов и узлов аппаратуры на основе гибридно-плёночной технологии с применением бескорпусной элементной базы (2011 год), разработка комплектов документации в стандартах единой системы конструкторской, технологической и производственной документации, ввод в эксплуатацию производственной линии

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год		2015 год
11. Разработка базовых конструкций и технологий производства корпусов мощных сверхвысокочастотных приборов для "бесвинцовой" сборки (2009 год), разработка комплектов документации в стандартах единой системы конструкторской, технологической и производственной документации, ввод в эксплуатацию производственной линии	226 152	151,2 102	74,8 50							создание технологии массового производства ряда корпусов мощных сверхвысокочастотных приборов для "бесвинцовой" сборки (2009 год), разработка комплектов документации в стандартах единой системы конструкторской, технологической и производственной документации, ввод в эксплуатацию производственной линии
12. Разработка базовых конструкций теплопроводящих элементов систем охлаждения сверхвысокочастотных приборов X- и C-диапазонов на основе новых материалов	83,5 55	13 8	40,5 27	30 20						создание базовых конструктивных рядов элементов систем охлаждения аппаратуры X- и C-диапазонов наземных, корабельных и воздушно-космических комплексов

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	

13. Разработка базовой технологии производства теплоотводящих элементов систем охлаждения сверхвысоко-частотных приборов X- и C-диапазонов на основе новых материалов	$\frac{109}{62}$			$\frac{64}{32}$	$\frac{45}{30}$				создание технологии массового производства конструктивного ряда элементов систем охлаждения аппаратуры X- и C-диапазонов наземных, корабельных и воздушно-космических комплексов (2011 год), разработка комплектов документации в стандартах единой системы конструкторской, технологической и производственной документации, ввод в эксплуатацию производственной линии
14. Разработка базовых технологий производства суперлинейных кремниевых	$\frac{13}{8}$								создание технологии массового производства конструктивного ряда сверхвысокочастот-

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	
сверхвысоко- частотных транзисторов S- и L-диапазонов									ных транзисторов S- и L-диапазонов для техники связи, локации и контрольной аппаратуры (2009 год), разработка комплектов документации в стандартах единой системы конструкторской, технологической и производственной документации, ввод в эксплуатацию производственной линии
15. Разработка конструктивно- параметрического ряда суперлинейных кремниевых сверхвысоко- частотных транзисторов S- и L-диапазонов	<u>208,9</u> 115,9			<u>139,9</u> 69,9			<u>69</u> 46		создание конструктивно- параметрического ряда сверхвысокочастот- ных транзисторов S- и L- диапазонов для техники связи, локации и контрольной аппаратуры, разработка

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	
16. Разработка технологий измерений и базовых конструкций установок автоматизированного измерения параметров нелинейных моделей сверхвысоко-частотных полупроводниковых структур, мощных транзисторов и сверхвысоко-частотных	$\frac{32}{22}$							$\frac{14}{10}$	комплектов документации в стандартах единой системы конструкторской, технологической и производственной документации, ввод в эксплуатацию производственной линии
		$\frac{18}{12}$							разработка метрологической аппаратуры нового поколения для исследования и контроля параметров полупроводниковых структур, активных элементов и сверхвысокочастотных монолитных интегральных схем в производстве и при их использовании

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год		2015 год
МОНОЛИТНЫХ интегральных схем Х-, С-, S-, L- и Р- диапазонов для их массового производства										
17. Исследование и разработка базовых технологий для создания нового поколения мощных вакуумно- твердотельных сверхвысоко- частотных приборов и гибридных малогабаритных сверхвысоко- частотных модулей с улучшенными массогабаритными характеристиками, магнитоэлектри- ческих приборов сверхвысоко- частотного диапазона, в том числе циркуляторов и фазовращателей,	<u>149,416</u> 102	<u>64,5</u> 43								создание технологий унифицированных сверхширокополос- ных приборов среднего и большого уровня мощности сантиметрового диапазона длин волн и сверхвысокочастот- ных магнитоэлектричес- ких приборов для перспективных радиоэлектронных систем и аппаратуры связи космического базирования (2009 год), разработка комплектов документации в стандартах единой системы конструкторской, технологической и

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	
вентилей, высокодобротных резонаторов, перестраиваемых фильтров, микроволновых приборов со спиновым управлением для перспективных радиоэлектронных систем двойного назначения									производственной документации, ввод в эксплуатацию производственной линии
18. Разработка базовых конструкций и технологии производства нового поколения мощных вакуумно- твердотельных сверхвысоко- частотных приборов и гибридных малогабаритных сверхвысокочас- отных модулей с улучшенными массогабаритными характеристиками,	<u>118,45</u> 85,3			<u>77,5</u> 58	<u>40,95</u> 27,3				разработка конструктивных рядов и базовых технологий производства сверхширокополос- ных приборов среднего и большого уровня мощности сантиметрового диапазона длин волн и сверхвысокочастот- ных магнитоэлектричес- ких приборов для перспективных радиоэлектронных

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	
магнитоэлектри- ческих приборов сверхвысоко- частотного диапазона, в том числе циркуляторов и фазовращателей, вентилей, высокодобротных резонаторов, перестраиваемых фильтров, микроволновых приборов со спиновым управлением для перспективных радиоэлектронных систем двойного назначения									систем и аппаратуры связи космического базирования (2011 год), разработка комплектов документации в стандартах единой системы конструкторской, технологической и производственной документации, ввод в эксплуатацию производственной линии
19. Исследование и разработка процессов и базовых технологий нанопленочных малогабаритных сверхвысоко- частотных резисторно- индуктивно-	<u>110,5</u> 75,5	<u>65,5</u> 45,5	<u>45</u> 30						создание технологических процессов производства нанопленочных малогабаритных сверхвысокочастот- ных резисторно- индуктивно- емкостных матриц

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе								Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	

емкостных матриц
многофункциональ-
ного назначения для
печатного монтажа
и сверхбыстродей-
ствующих
(до 150 ГГц)
приборов на
наногетеро-
структурах с
квантовыми
эффектами

многофункциональ-
ного назначения для
печатного монтажа
(2008 год), создание
базовой технологии
получения
сверхбыстродейст-
вующих (до 150 ГГц)
приборов на
наногетерострук-
турах с квантовыми
эффектами
(2009 год), разработка
комплектов
документации в
стандартах единой
системы
конструкторской,
технологической и
производственной
документации,
ввод в эксплуатацию
производственной
линии

создание
конструктивных
рядов и базовых
технологий
производства
нанополеночных

20. Разработка базовых
конструкций и
технологий
производства
нанополеночных
малогабаритных

84,5
53

50
30

34,5
23

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	
сверхвысоко- частотных резисторно- индуктивно- емкостных матриц многофункциональ- ного назначения для назначения для печатного монтажа									малогабаритных сверхвысокочастот- ных резисторно- индуктивно- емкостных матриц многофункциональ- ного назначения для печатного монтажа (2011 год), разработка комплектов документации в стандартах единой системы конструкторской, технологической и производственной документации, ввод в эксплуатацию производственной линии создание базовой технологии производства элементов и специальных элементов и блоков портативной аппаратуры миллиметрового диапазона длин волн для нового поколения
21. Разработка базовой технологии сверхвысоко- частотных р-п диодов, матриц, узлов управления и портативных фазированных блоков аппаратуры миллиметрового	<u>133,314</u> 88	<u>63,447</u> 42	<u>69,867</u> 46						

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год		2015 год
диапазона длин волн на основе магнитоэлект- ронных твердотельных и высокоскоростных цифровых приборов и устройств с функциями адаптации и цифрового диаграммообра- зования										средств связи, радиолокационных станций, радионавигации, измерительной техники, автомобильных радаров, охранных и сигнальных устройств (2009 год), разработка комплектов документации в стандартах единой системы конструкторской, технологической и производственной документации, ввод в эксплуатацию производственной линии
22. Разработка базовых технологий создания мощных вакуумных сверхвысоко- частотных устройств	<u>2323,262</u> 1528,566	<u>338</u> 230	<u>295,11</u> 193,1	<u>364,823</u> 226,98	<u>380,85</u> 253,9	<u>320</u> 210	<u>189,8</u> 124,8	<u>210,129</u> 140,086	<u>224,55</u> 149,7	создание конструктивных рядов и базовых технологий проектирования и производства мощных и сверхмощных

	В том числе							Ожидаемые результаты		
	2008 - 2015 годы - всего	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год		2014 год	2015 год
										<p>вакуумных сверхвысокочастот- ных приборов для аппаратуры широкого назначения нового поколения (2009 год, 2011 год), включая разработку конструкций многолучевых электронно- оптических систем, включая автоэмиссионные катоды повышенной мощности и долговечности (2012 год), мощных широкополосных ламп бегущей волны импульсного и непрерывного действия, магнетронов, тетродов миллиметрового диапазона (2013 год), малогабаритных ускорителей электронов с</p>

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год		2015 год
23. Разработка базовых технологий создания мощных твердотельных сверхвысоко-частотных устройств на базе нитрида галлия	<u>1658,481</u> 1094,1	<u>158,001</u> 103	<u>253,012</u> 166,5	<u>296,269</u> 192,4	<u>293,55</u> 195,7	<u>287,35</u> 189,9	<u>122,05</u> 81,1	<u>109,875</u> 73,25	<u>138,374</u> 92,25	создание базовых конструкций и технологий изготовления сверхвысокочастотных мощных приборов на структурах с использованием нитрида галлия (2008 год, 2010 год), включая: создание гетеропереходных полевых транзисторов с барьером Шоттки с удельной мощностью до 3 - 4 Вт/мм и рабочими напряжениями до 30 В, исследования и разработку технологий получения

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	

гетероструктур на основе слоев нитрида галлия на изоляторе и высокоомных подложках (2013 год), разработку технологии получения интегральных схем, работающих в экстремальных условиях (2015 год)

24. Исследование перспективных типов сверхвысокочастотных приборов и структур, разработка технологических принципов их изготовления	<u>1046,46</u>				<u>160,2</u>	<u>99,5</u>	<u>274,5</u>	<u>298,88</u>	<u>213,38</u>	исследование технологических принципов формирования перспективных сверхвысокочастотных приборов и структур, включая создание наногетероструктур, использование комбинированных (электронных и оптических) методов передачи и преобразования сигналов), определение
	698,32				106,8	67,02	183	199,25	142,25	

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год		2015 год
25. Разработка перспективных методов проектирования и моделирования сложнoфункциональной сверхвысоко-частотной электронной компонентной базы	<u>1021,25</u> 684,4				49,2 32,8	<u>331,7</u> 224,7	<u>221,4</u> 147,6	<u>242,25</u> 161,5	<u>176,7</u> 117,8	перспективных методов формирования приборных структур, работающих в частотных диапазонах до 200 ГГц создание полного состава прикладных программ проектирования и оптимизации сверхвысокочастотной электронной компонентной базы, включая проектирование активных приборов, полосковых линий передачи, согласующих компонентов, формируемых в едином технологическом процессе

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год		2015 год
Всего по направлению 1	<u>9697,875</u> 6409,486	<u>1485,57</u> 993,95	<u>1392,821</u> 929,35	<u>1375,395</u> 855,78	<u>1603,5</u> 1069	<u>1205,35</u> 804,12	<u>1021,1</u> 681,2	<u>861,134</u> 574,086	<u>753,005</u> 502	

Направление 2. Радиационно стойкая электронная компонентная база

26. Разработка базовой технологии радиационно стойких сверхбольших интегральных схем уровня 0,5 мкм на структурах "кремний на сапфире" диаметром 150 мм	<u>106,65</u> 79,65	<u>46,65</u> 41,65								создание технологии изготовления микросхем на структурах "кремний на сапфире" диаметром 150 мм (2009 год), разработка правил проектирования базовых библиотек элементов и блоков цифровых и аналоговых сверхбольших интегральных схем расширенной номенклатуры для организации производства радиационно стойкой элементной базы, обеспечивающей выпуск специальной аппаратуры и систем, работающих в экстремальных условиях (атомная энергетика, космос, военная техника)
---	------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	---

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	
27. Разработка базовой технологии радиационно стойких сверхбольших интегральных схем уровня 0,35 мкм на структурах "кремний на сапфире" диаметром 150 мм	<u>286,65</u> 188,1			<u>39,2</u> 19,6	<u>170,25</u> 113,5	<u>53,2</u> 37,2	<u>24</u> 17,8		создание технологии изготовления микросхем с размерами элементов 0,35 мкм на структурах "кремний на сапфире" диаметром 150 мм (2013 год), разработка правил проектирования базовых библиотек элементов и блоков цифровых и аналоговых сверхбольших интегральных схем, обеспечивающих создание расширенной номенклатуры быстросействующей и высокоинтегрированной радиационно стойкой элементной базы
28. Разработка технологии проектирования и конструктивно-	<u>245,904</u> 164	<u>130</u> 87	<u>115,904</u> 77						создание технологического базиса (технология проектирования,

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	
технологических решений библиотеки логических и аналоговых элементов, оперативных запоминающих устройств, постоянных запоминающих устройств, сложно- функциональных радиационно стойких блоков контролеров по технологии "кремний на изоляторе" с проектными нормами до 0,25 мкм									базовые технологии), позволяющего разрабатывать радиационно стойкие сверхбольшие интегральные схемы на структурах "кремний на изоляторе" с проектной нормой до 0,25 мкм (2009 год)
29. Разработка технологии проектирования и конструктивно- технологических решений библиотеки логических и	<u>365,35</u> 235	<u>108,6</u> 54,3	<u>166,05</u> 110,7	<u>67,7</u> 52,6	<u>23</u> 17,4	создание технологического базиса (технология проектирования, базовые технологии), позволяющего разрабатывать радиационно стойкие			

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	
аналоговых элементов, оперативных запоминающих устройств, постоянных запоминающих устройств, слож- функциональных радиационно стойких блоков контроллеров по технологии "кремний на изоляторе" с проектными нормами до 0,18 мкм									сверхбольшие интегральные схемы на структурах "кремний на изоляторе" с проектной нормой до 0,18 мкм
30. Разработка базовых технологических процессов изготовления радиационно стойкой элементной базы для сверхбольших интегральных схем энергозависимой пьезоэлектри- ческой и	<u>141,75</u> 97,65	<u>92</u> 63	<u>49,75</u> 34,65						создание технологического процесса изготовления сверхбольших интегральных схем энергонезависимой, радиационно стойкой сегнетоэлектричес- кой памяти уровня 0,35 мкм и базовой технологии создания,

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год		2014 год
магниторезистив- ной памяти с проектными нормами 0,35 мкм и пассивной радиационно стойкой элементной базы									изготовления и аттестации радиационно стойкой пассивной электронной компонентной базы (2009 год)
31. Разработка базовых технологических процессов изготовления радиационно стойкой элементной базы для сверхбольших интегральных схем энергонезависимой пьезоэлектрической и магниторезистив- ной памяти с проектными нормами 0,18 мкм и пассивной радиационно стойкой элементной базы	257,45 159,2	74,6 37,3	130,35 86,9	42,3 28,2	10,2 6,8				создание технологического процесса изготовления сверхбольших интегральных схем энергонезависимой радиационно стойкой сегнетоэлектрической памяти уровня 0,18 мкм (2010 год) и создания, изготовления и аттестации радиационно стойкой пассивной электронной компонентной базы (2013 год)

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год		2015 год
32. Разработка технологий "кремний на сапфире" изготовления ряда лицензионно-независимых радиационно-стойких компонентарных полевых полупроводниковых сверхбольших интегральных схем цифровых процессоров обработки сигналов, микроконтроллеров и схем интерфейса	<u>110,736</u> 73	<u>58,609</u> 38	<u>52,127</u> 35							разработка расширенного ряда цифровых процессоров, микро-контроллеров, оперативных запоминающих программируемых и перепрограммируемых устройств, аналого-цифровых преобразователей в радиационно стойком исполнении для создания специальной аппаратуры нового поколения
33. Разработка технологий структур с ультратонким слоем кремния на сапфире	<u>370,802</u> 231,7	<u>82,952</u> 39,8	<u>190,35</u> 126,9	<u>72,6</u> 48,4	<u>24,9</u> 16,6					создание технологии проектирования и изготовления микросхем и сложнофункциональных блоков на основе ультратонких слоев на структуре "кремний на сапфире",

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Ожидаемые результаты		
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год		2014 год	2015 год
34. Разработка базовой технологии и приборно- технологического базиса производства радиационно стойких сверхбольших интегральных схем "система на кристалле", радиационно стойкой силовой электроники для аппаратуры питания и управления	<u>92,669</u> 73,15	<u>51</u> 40	<u>41,669</u> 33,15							позволяющей разрабатывать радиационно стойкие сверхбольшие интегральные схемы с высоким уровнем радиационной стойкости (2013 год)
										разработка конструкции и модели интегральных элементов и технологического маршрута изготовления радиационно стойких сверхбольших интегральных схем типа "система на кристалле" с расширенным температурным диапазоном, силовых транзисторов и модулей для бортовых и промышленных систем управления с пробивными напряжениями

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	
35. Разработка элементной базы радиационно стойких интегральных схем на основе полевых эмиссионных микронанотриодов и микронанодиодов	<u>74,471</u> 50,6	<u>36,2</u> 26,1	<u>38,271</u> 24,5						до 75 В и рабочими токами коммутации до 10 А (2009 год)
36. Создание информационной базы радиационно стойкой электронной компонентной базы, содержащей модели интегральных компонентов, функционирующих в условиях радиационных воздействий, создание математических моделей стойкости	<u>256,6</u> 167,3			<u>21,4</u> 10,7	25 16,6	<u>92,4</u> 61,6	<u>117,8</u> 78,4		создание ряда микронанотриодов и микронанодиодов с наивысшей радиационной стойкостью для долговечной аппаратуры космического базирования
									разработка комплекса моделей расчета радиационной стойкости электронной компонентной базы для определения технически обоснованных норм испытаний

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год		2015 год
электронной компонентной базы, создание методик испытаний и аттестации электронной компонентной базы										
37. Разработка библиотек стандартных элементов и сложнофункцио- нальных блоков для создания радиационно стойких сверхбольших интегральных схем	<u>866,247</u> 577,531				<u>105</u> 70	<u>184,5</u> 123	<u>251,2</u> 167,5	<u>200,297</u> 133,531	<u>125,25</u> 83,5	создание технологии проектирования и изготовления микросхем и сложнофункцио- нальных блоков на основе ультратонких слоев на структуре "кремний на сапфире", позволяющей разрабатывать радиационно стойкие сверхбольшие интегральные схемы с высоким уровнем радиационной стойкости (2012 год, 2015 год)
38. Разработка расширенного ряда радиационно	<u>939,488</u> 625,825				<u>187,5</u> 125	<u>185</u> 123	<u>141,25</u> 94	<u>230,25</u> 153,5	<u>195,488</u> 130,325	разработка расширенного ряда цифровых

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	
стойких сверхбольших интегральных схем для специальной аппаратуры связи, обработки и передачи информации, систем управления									процессоров, микро- контроллеров, оперативных запоминающих программируемых и перепрограмми- руемых устройств, аналого-цифровых преобразователей в радиационно стойком исполнении для создания специальной аппаратуры нового поколения, разработка конструкции и модели интегральных элементов и технологического маршрута изготовления радиационно стойких сверхбольших интегральных схем типа "система на кристалле" с расширенным температурным диапазоном, силовых транзисторов и

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе								Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	
39. Разработка и совершенствование методов моделирования и проектирования радиационно стойкой элементной базы	938 625				75 50	275 183	210.75 140,5	186.75 124,5	190.5 127	модулей для бортовых и промышленных систем управления с пробивными напряжениями до 75 В и рабочими токами коммутации до 10 А, создание ряда микронано- триодов и микро- диодов с наивысшей радиационной стойкостью для долговечной аппаратуры космического базирования разработка комплекса моделей расчета радиационной стойкости электронной компонентной базы для определения технически обоснованных норм испытаний

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год		2015 год
40. Разработка и совершенствование базовых технологий и конструкций радиационно стойких сверхбольших интегральных схем на структурах "кремний на сапфире" и "кремний на изоляторе" с топологическими нормами не менее 0,18 мкм	<u>964,05</u> 629,7				<u>180</u> 120	<u>191</u> 123	<u>177,5</u> 113,5	<u>209,55</u> 139,7	<u>206</u> 133,5	создание технологического базиса (технология проектирования, базовые технологии), позволяющего разрабатывать радиационно стойкие сверхбольшие интегральные схемы на структурах "кремний на сапфире" с проектной нормой не менее 0,18 мкм (2014 год), создание технологического базиса (технология проектирования, базовые технологии), позволяющего разрабатывать радиационно стойкие сверхбольшие интегральные схемы на структурах "кремний на изоляторе" с проектной нормой не менее 0,18 мкм (2015 год)

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе								Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	
Всего по направлению 2	<u>6016,817</u> <u>3977,406</u>	<u>427,809</u> <u>292,1</u>	<u>344,371</u> <u>245,95</u>	<u>326,752</u> <u>161,7</u>	<u>1229,5</u> <u>819,6</u>	<u>1163,7</u> <u>780</u>	<u>980,6</u> <u>652,5</u>	<u>826,847</u> <u>551,231</u>	<u>717,238</u> <u>474,325</u>	
41. Разработка базовых технологий микро- электромехани- ческих систем	<u>184,215</u> <u>117,9</u>	<u>165,053</u> <u>105,9</u>	<u>19,162</u> <u>12</u>							создание базовых технологий (2009 год) и комплектов технологической документации на изготовление микроэлектромеха- нических систем контроля давления, микроакселеро- метров с чувствительностью по двум и трем осям, микромеханических датчиков угловых скоростей, микроактоаторов
42. Разработка базовых конструкций микроэлектро- механических систем	<u>423,712</u> <u>263,8</u>	<u>87,239</u> <u>42,1</u>	<u>73,473</u> <u>49,7</u>	<u>108</u> <u>72</u>	<u>82,5</u> <u>55</u>	<u>72,5</u> <u>45</u>				разработка базовых конструкций и комплектов необходимой конструкторской документации на изготовление чувствительных элементов

Направление 3. Микросистемная техника

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	
43. Разработка базовых технологий микроэлектромеханических систем	<u>202,784</u> 132,15	<u>122,356</u> 78,55	<u>44,428</u> 29,6				<u>36</u> 24		и микросистем контроля давления, микроакселерометров, микромеханических датчиков угловых скоростей, микроактюаторов с напряжением управления, предназначенных для использования в транспортных средствах, оборудовании топливно-энергетического комплекса, машиностроении, медицинской технике, робототехнике, бытовой технике
									создание базовых технологий (2009 год) и комплектов необходимой технологической документации на изготовление

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	

44. Разработка базовых конструкций микро-акустоэлектромеханических систем	<u>411,574</u> 258,8	<u>52</u> 28	<u>103,825</u> 60,3	<u>88,5</u> 59	<u>167,249</u> 111,5				микроакустоэлектромеханических систем, основанных на использовании поверхностных акустических волн (диапазон частот до 2 ГГц) и объемно-акустических волн (диапазон частот до 8 ГГц), пьезокерамических элементов, совместимых с интегральной технологией микроэлектроники
									разработка базовых конструкций и комплектов необходимой конструкторской документации на изготовление пассивных датчиков физических величин микроакселерометров, микрогироскопов на поверхностных акустических волнах,

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе								Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	

датчиков давления
и температуры,
датчиков
деформации,
крутящего момента и
микроремещений,
резонаторов

45. Разработка базовых технологий микроаналитических систем	$\frac{37}{25}$									создание базовых технологий изготовления элементов микроаналитических систем, чувствительных к газовым, химическим и биологическим компонентам внешней среды, предназначенных для использования в аппаратуре жилищно-коммунального хозяйства, в медицинской и биомедицинской технике для обнаружения токсичных, горючих и взрывчатых материалов
---	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	
46. Разработка базовых конструкций микроаналити- ческих систем	134 <u>78</u>	47 <u>20</u>	60 <u>40</u>	27 <u>18</u>					создание базовых конструкций микроаналитических систем, предназначенных для аппаратуры жилищно- коммунального хозяйства, медицинской и биомедицинской техники, разработка датчиков и аналитических систем миниатюрных размеров с высокой чувствительностью к сверхмалым концентрациям химических веществ для осуществления мониторинга окружающей среды, контроля качества пищевых продуктов и контроля утечек опасных и вредных веществ в технологических процессах

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе								Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	
47. Разработка базовых технологий микро-оптоэлектронных механических систем	<u>42,444</u> 27	<u>15,358</u> 10,2	<u>27,086</u> 16,8							создание базовых технологий выпуска трехмерных оптических и акустооптических функциональных элементов, микрооптоэлектромеханических систем для коммутации и модуляции оптического излучения, акустооптических перестраиваемых фильтров, двухмерных управляемых магриц микрозеркал микропереключателей и фазовращателей (2009 год)
48. Разработка базовых конструкций микрооптоэлектронных механических систем	<u>109,278</u> 70	<u>33,95</u> 21	<u>48,328</u> 31	<u>27</u> 18						разработка базовых конструкций и комплектов конструкторской документации на изготовление микрооптоэлектро-

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год		2015 год
49. Разработка базовых технологий микросистем анализа магнитных полей	<u>55,008</u> 36	<u>55,008</u> 36								механических систем коммутации и модуляции оптического излучения
50. Разработка базовых конструкций микросистем анализа магнитных полей	<u>153,518</u> 98,018	<u>39,518</u> 22,018		<u>93</u> 62	<u>21</u> 14					создание базовых технологий изготовления микросистем анализа магнитных полей на основе анизотропного и гигантского магниторезистивного эффектов, квазимонолитных и монолитных гетеромагнитных пленочных структур (2008 год)
										разработка базовых конструкций и комплектов конструкторской документации на магниточувствительные микросистемы для применения в электронных

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Ожидаемые результаты		
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год		2014 год	2015 год
51. Разработка базовых технологий радиочастотных микроэлектромеханических систем	<u>123,525</u> 80,662	<u>43,274</u> 28,45	<u>80,251</u> 52,212							системах управления приводами, в датчиках положения и потребления, бесконтактных переключателях
52. Разработка базовых конструкций радиочастотных микроэлектромеханических систем	<u>142,577</u> 96	<u>35,6</u> 25	<u>63,477</u> 42	<u>43,5</u> 29						разработка и освоение в производстве базовых технологий изготовления радиочастотных микроэлектромеханических систем и компонентов, включающих микрореле, коммутаторы, микропереключатели (2009 год)
										разработка базовых конструкций и комплектов конструкторской документации на изготовление радиочастотных микроэлектромеханических систем и

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе								Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	
53. Разработка методов и средств обеспечения создания и производства изделий микросистемной техники	<u>38,915</u> 22,8	<u>38,915</u> 22,8								создание методов и средств контроля и измерения параметров и характеристик изделий микросистемотех- ники, разработка комплектных стандартов и нормативных документов по безопасности и экологии
54. Разработка перспективных технологий и конструкций микрооптоэлектро-	<u>1130,25</u> 753,5	<u>345</u> 230	<u>315</u> 210	<u>256,5</u> 171	<u>213,75</u> 142,5					создание базовых технологий выпуска трехмерных оптических и акустооптических

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе									Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год			
механических систем для оптической аппаратуры, систем отображения изображений, научных исследований и специальной техники												функциональных элементов, микрооптоэлектромеханических систем для коммутации и модуляции оптического излучения (2012 год), акустооптических перестраиваемых фильтров (2012 год), двухмерных управляемых матриц микросеркал микропереключа-телей и фазовращателей (2013 год), разработка базовых технологий, конструкций и комплектов конструкторской документации на изготовление микрооптоэлектромеханических систем коммутации и модуляции оптического излучения (2015 год)

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год		2015 год
55. Разработка и совершенствование методов и средств контроля, испытаний и аттестации изделий микросистемо-техники	<u>925,5</u> 617				<u>150</u> 100	<u>262,5</u> 175	<u>142,5</u> 95	<u>213,75</u> 142,5	<u>156,75</u> 104,5	создание методов и средств контроля и измерения параметров и характеристик изделий микросистемотехники, разработка комплектов стандартов и нормативных документов по безопасности и экологии
56. Разработка перспективных технологий и конструкций микро-аналитических систем для аппаратуры контроля и обнаружения токсичных, горючих, взрывчатых и наркотических веществ	<u>927</u> 618					<u>360</u> 240	<u>253,5</u> 169	<u>156,75</u> 104,5	<u>156,75</u> 104,5	создание перспективных технологий изготовления элементов микроаналитических систем, чувствительных к газовым, химическим и биологическим компонентам внешней среды, предназначенных для использования в аппаратуре жилищно-коммунального хозяйства (2012 год, 2013 год, 2014 год)

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе								Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	
Всего по направлению 3	<u>5041,3</u> 3294,63	<u>476,964</u> 306,9	<u>466,233</u> 268,73	<u>442,103</u> 285	<u>465</u> 310	<u>1050</u> 700	<u>986,75</u> 654,5	<u>627</u> 418	<u>527,25</u> 351,5	
57. Разработка технологии и развитие методологии проектирования изделий микроэлектроники: разработка и освоение современной технологии проектирования универсальных микропроцессоров, процессоров обработки сигналов, микро- контроллеров и "системы на кристалле" на основе каталогизиро- ванных сложнофункцио- нальных блоков и библиотечных элементов, в том	<u>308,667</u> 178,4	<u>89,367</u> 48,9								разработка комплекта нормативно- технической документации по проектированию изделий микроэлектроники, создание отраслевой базы данных с каталогами библиотечных элементов и сложнофункцио- нальных блоков с каталогизирован- ными результатами аттестации на физическом уровне, разработка комплекта нормативно- технической и технологической документации по взаимодействию центров проектирования в сетевом режиме
										Направление 4. Микроэлектроника

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год		2015 год
числе создание отраслевой базы данных и технологических файлов для автоматизиро- ванных систем проектирования, освоение и развитие технологии проектирования для обеспечения технологичности производства и стабильного выхода годных в целях размещения заказов на современной базе контрактного производства с технологическим уровнем до 0,13 мкм										
58. Разработка и освоение базовой технологии производства фотошаблонов с технологическим	<u>34,569</u> 22,7	<u>11,869</u> 8								разработка комплекта технологической документации и организационно- распорядительной документации по

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	

взаимодействию
центров
проектирования и
центра изготовления
фотошаблонов

уровнем
до 0,13 мкм в целях
обеспечения
информационной
защиты проектов
изделий
микроэлектроники
при использовании
контрактного
производства
(отечественного и
зарубежного)

59. Разработка
семейств и серий
изделий
микроэлектроники:
универсальных
микропроцессоров
для встроенных
применений,
универсальных
микропроцессоров
для серверов и
рабочих станций,
цифровых
процессоров
обработки
сигналов,
сверхбольших
интегральных схем,

852.723
490,2
350.836
190,1
501.887
300,1

разработка
комплектов
документации в
стандартах единой
системы
конструкторской,
технологической и
производственной
документации,
изготовление
опытных образцов
изделий и
организация
серийного
производства

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	
программ- мируемых логических интегральных схем, сверхбольших интегральных схем быстродейст- вующей динамической и статической памяти, микро- контроллеров со встроенной энергонезависимой электрически программируемой памятью, схем интерфейса дискретного ввода/вывода, схем аналогового интерфейса, цифроаналоговых и аналого-цифровых преобразователей на частотах выше 100 МГц с разрядностью более 8-12 бит, схем приемо- передатчиков									

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год		2015 год
шинных интерфейсов, изделий интеллектуальной силовой микросхемотехники для применения в аппаратуре промышленного и бытового назначения, встроенных интегральных источников питания										
60. Разработка базовых серийных технологий изделий микросхемотехники: цифроаналоговых и аналого-цифровых преобразователей на частотах выше 100 МГц с разрядностью более 14 - 16 бит, микросхемотехнических устройств различных типов, включая сенсоры с применением наноструктур	<u>2236,828</u> 1299			<u>1129,878</u> 592,3	<u>971,95</u> 616,7	<u>135</u> 90				разработка комплектов документации в стандартах единой системы конструкторской, технологической и производственной документации, изготовление опытных образцов изделий и организация серийного производства

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год		2015 год
и биосенсоров, сенсоров на основе магнито- электрических и пьезоматериалов, встроенных интегральных антенных элементов для диапазонов частот 5 ГГц, 10 - 12 ГГц, систем на кристалле, в том числе в гетероинтеграции сенсорных и исполнительных элементов методом беспроводной сборки с применением технологии матричных жестких выводов										
61. Разработка технологии и освоение производства изделий микроэлектроники с технологическим уровнем 0,13 мкм	<u>545,397</u> 308,8	<u>304,9</u> 168,3	<u>240,497</u> 140,5							разработка комплектов документации в стандартах единой системы конструкторской, технологической документации и ввод

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	
62. Разработка базовой технологии формирования многослойной разводки (7 - 8 уровней) сверхбольших интегральных схем на основе Al и Cu	<u>939,45</u> 587,3			<u>196</u> 102	<u>360</u> 240	<u>154</u> 99	<u>229,45</u> 146,3		в эксплуатацию производственной линии разработка комплектов документации в стандартах единой системы конструкторской, технологической и производственной документации, ввод в эксплуатацию производственной линии
63. Разработка технологии и организация производства многокристалльных микроэлектронных модулей для мобильных применений с использованием полимерных и металлополимер- ных микропласт и носителей	<u>519,525</u> 288,9		<u>235,513</u> 101	<u>168,512</u> 110,9	<u>115,5</u> 77			разработка комплектов документации в стандартах единой системы конструкторской, технологической и производственной документации, ввод в эксплуатацию производственной линии	

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год		2015 год
64. Разработка новых методов технологических испытаний изделий микроэлектроники, гарантирующих их повышенную надежность в процессе долговременной (более 100000 часов) эксплуатации, на основе использования типовых оценочных схем и тестовых кристаллов	133,8 133,8	67 67	66,8 66,8							разработка технологической и производственной документации, ввод в эксплуатацию специализированных участков
65. Разработка современных методов анализа отказов изделий микроэлектроники с применением ультрараз-решающих методов (ультразвуковая гигагерцовая микроскопия, сканирование	243,77 243,77	131,9 131,9	111,87 111,87							разработка комплектов документации, включая утвержденные отраслевые методики, ввод в эксплуатацию модернизированных участков и лабораторий анализа отказов

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Ожидаемые результаты			
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год		2014 год	2015 год	
синхротронным излучением, атомная и туннельная силовая микроскопия, электронно- и ионно-лучевое зондирование и другие)											
66. Разработка базовых субмикронных технологий уровней 0,065 - 0,045 мкм	<u>1170,325</u> 773,55					<u>310</u> 200	<u>354,45</u> 236,3	<u>285</u> 190	<u>220,875</u> 147,25	создание технологий сверхбольших интегральных схем, создание базовой технологии формирования многоослойной разводки сверхбольших интегральных схем топологического уровня 0,065 - 0,045 мкм (2015 год), освоение и развитие технологии проектирования и изготовления для обеспечения технологичности производства и	

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	

стабильного выхода годных изделий, а также в целях размещения заказов на современной базе контрактного производства с технологическим уровнем до 0,045 мкм, разработка комплекта технологической документации и организационно- распорядительной документации по взаимодействию центров											
67. Исследование технологических процессов и структур для субмикронных технологий уровней 0,032 мкм	<u>1372,075</u> 894,45										создание технологии сверхбольших интегральных схем технологических уровней 65 - 45 нм, организация опытного производства и исследование технологических уровней 0,032 мкм (2015 год)
					383	383,45	334,875	270,75			
				245	245,7	223,25	180,5				

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год		2015 год
68. Разработка перспективных технологий и конструкций изделий интеллектуальной силовой электроники для применения в аппаратуре бытового и промышленного назначения, на транспорте, в топливно-энергетическом комплексе и в специальных системах	<u>1403,27</u> 928,84				<u>166,05</u> 110,7	<u>402,7</u> 261,8	<u>318</u> 212	<u>295,88</u> 197,25	<u>220,64</u> 147,09	создание технологий и конструкций перспективных изделий интеллектуальной силовой электроники для применения в аппаратуре бытового назначения, создание встроенных интегральных источников питания (2013 - 2015 годы)
69. Разработка перспективных технологий сборки сверхбольших интегральных схем в многовыводные корпуса, в том числе корпуса с матричным расположением	<u>1649,14</u> 1072,36				<u>300</u> 200	<u>356,4</u> 224,2	<u>205</u> 123	<u>413,25</u> 275,5	<u>374,49</u> 249,66	разработка перспективной технологии многокристалльных микроселектронных модулей для мобильных применений с использованием полимерных и

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе								Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	

выводов и технологий многокристальной сборки, включая создание "систем в корпусе"

металлополимерных микроплат и носителей (2015 год)

Всего по	<u>11409,539</u>	<u>1096,636</u>	<u>1257,803</u>	<u>1494,39</u>	<u>1913,5</u>	<u>1741,1</u>	<u>1490,35</u>	<u>1329,005</u>	<u>1086,755</u>	
направлению 4	7222,07	701,5	777,17	805,2	1244,4	1120	963,3	886	724,5	

Направление 5. Электронные материалы и структуры

70. Разработка технологий производства новых диэлектрических материалов на основе ромбоздрической модификации нитрида бора и подложек из поликристаллического алмаза	<u>78</u>	<u>51</u>	<u>27</u>							внедрение новых диэлектрических материалов на основе ромбоздрической модификации нитрида бора и подложек из поликристаллического алмаза с повышенной теплопроводностью и электропроводностью для создания нового поколения высокоэффективных и надежных сверхвысокочастотных приборов
	49	32	17							

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	
73. Разработка технологий производства спинэлектронных магнитных материалов, радиопоглощающих и мелкодисперсных ферритовых материалов для сверхвысокочастотных приборов	<u>132,304</u> 82			<u>33,304</u> 16	<u>45</u> 30	<u>54</u> 36			создание спинэлектронных магнитных материалов и микроволновых структур со спиновым управлением для создания перспективных микроволновых сверхвысокочастотных приборов повышенного быстродействия и низкого энергопотребления
74. Разработка технологий производства высокочистых химических материалов (аммиака, арсина, фосфина, тетрахлорида кремния) для обеспечения производства полупроводниковых подложек	<u>76,4</u> 47,3		<u>26,3</u> 16,3						создание технологии массового производства высокочистых химических материалов (аммиака, арсина, фосфина, тетрахлорида кремния) для выпуска полупроводниковых подложек нитрида галлия, арсенида галлия, фосфида индия, кремния

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год		2014 год
нитрида галлия, арсенида галлия, фосфида индия, кремния и гетерозитакси- альных структур на их основе									и гетерозитаксиаль- ных структур на их основе (2009 год)
75. Разработка технологии производства поликристалли- ческих алмазов и их пленок для теплопроводных конструкций мощных выходных транзисторов и сверхвысокочас- отных приборов	<u>62,07</u> 45,38			12 12	35,07 23,38	15 10			создание технологии производства поликристаллических алмазов и его пленок для мощных сверхвысокочас- отных приборов (2012 год)
76. Исследование путей и разработка технологии изготовления новых микроволокон на основе двухмерных диэлектрических и металлодиэлект- рических микро- и наноструктур, а	<u>57</u> 38		21 14						создание технологии изготовления новых микроволокон на основе двухмерных диэлектрических и металлодиэлектри- ческих микро- и наноструктур для новых классов микроструктурных

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год		2014 год
также полупроводнико- вых нитей с наноразмерами при вытяжке стеклянного капилляра, заполненного жидкой фазой полупроводника									приборов, магниторезисторов, осцилляторов, устройств оптоэлектроники (2009 год)
77. Разработка технологии выращивания слоев пьезокерамики на кремниевых подложках для формирования комплексированных устройств микросистемной техники	<u>64,048</u> 39	<u>4,5</u> 3	<u>32,548</u> 18	<u>27</u> 18					создание базовой пленочной технологии пьезокерамических элементов, совместимой с комплементарной металлооксидной полупроводниковой технологией для разработки нового класса активных пьезокерамических устройств, интегрированных с микросистемами (2011 год)

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	
78. Разработка методологии и базовых технологий создания многослойных кремниевых структур с использованием "жертвенных" и "столпорных" диффузионных и диэлектрических слоев для производства силовых приборов и элементов микроэлектромеханических систем	<u>63.657</u> 38	<u>42.657</u> 24	<u>21</u> 14						создание технологии травления и изготовления кремниевых трехмерных базовых элементов микроэлектромеханических систем с использованием "жертвенных" и "столпорных" слоев для серийного производства элементов микроэлектромеханических систем (2009 год) кремниевых структур с использованием силикатных стекол, моно-, поликристаллического и пористого кремния и диоксида кремния
79. Разработка базовых технологий получения алмазных полупроводниковых наноструктур	<u>45.85</u> 22	<u>29.35</u> 11	<u>16.5</u> 11						создание технологии получения алмазных полупроводниковых наноструктур и наноразмерных органических

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	
и наноразмерных органических покрытий с широким диапазоном функциональных свойств									Ожидаемые результаты
80. Исследование и разработка технологии роста эпитаксиальных слоев карбида кремния, структур на основе нитридов, а также формирования изолирующих и коммутирующих слоев в приборах экстремальной электроники	<u>136,716</u> 88,55	<u>57,132</u> 38	<u>79,584</u> 50,55						создание технологии изготовления гетероструктур и эпитаксиальных структур на основе нитридов для создания радиационно стойких сверхвысокочастотных и силовых приборов нового поколения (2009 год)
81. Разработка технологии производства радиационно стойких	<u>159,831</u> 90	<u>52</u> 35	<u>107,831</u> 55						создание технологии производства структур "кремний на сапфире" диаметром до 150 мм с толщиной

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	
сверхбольших интегральных схем на ультратонких гетероэпитакси- альных структурах кремния на сапфировой подложке для производства электронной компонентной базы специального и двойного назначения									приборного слоя до 0,1 мкм и топологическими нормами до 0,18 мкм для производства электронной компонентной базы специального и двойного назначения (2009 год)
82. Разработка технологии производства высокоомного радиационно облученного кремния, слитков и пластин кремния диаметром до 150 мм для производства силовых полупроводнико- вых приборов	<u>138,549</u> 89,7	<u>54</u> 36	<u>84,549</u> 53,7						создание технологии производства радиационно облученного кремния и пластин кремния до 150 мм для выпуска мощных транзисторов и сильноточных тиристоров нового поколения (2009 год)

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	
83. Разработка и технологии производства кремниевых подложек и структур для силовых полупроводниковых приборов с глубокими высоколегированными слоями p- и n-типов проводимости и скрытыми слоями носителей с повышенной рекомбинацией	<u>90,4</u> 58,9	<u>38,5</u> 24	<u>51,9</u> 34,9						разработка и промышленное освоение получения высококачественных подложек и структур для использования в производстве силовых полупроводниковых приборов с глубокими высоколегированными слоями и скрытыми слоями носителей с повышенной рекомбинацией (2009 год)
84. Разработка технологии производства электронного кремния, кремниевых пластин диаметром до 200 мм и кремниевых эпитаксиальных структур уровня технологии 0,25 - 0,18 мкм	<u>220,764</u> 162	<u>73,964</u> 48	<u>146,8</u> 114						создание технологии производства пластин кремния диаметром до 200 мм и эпитаксиальных структур уровня 0,25 - 0,18 мкм (2009 год)

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год		2015 год
85. Разработка методологии, конструктивно-технических решений и перспективной базовой технологии корпусирования интегральных схем и полупроводниковых приборов на основе использования многослойных кремниевых структур со сквозными токопроводящими каналами	<u>266,35</u> 161			<u>81,85</u> 38	<u>124,5</u> 83	<u>30</u> 20	<u>30</u> 20	<u>30</u> 20		разработка технологий корпусирования интегральных схем и полупроводниковых приборов на основе использования многослойных кремниевых структур со сквозными токопроводящими каналами, обеспечивающей сокращение состава сборочных операций и формирование трехмерных структур (2013 год)
86. Разработка технологии производства гетероструктур SiGe для разработки сверхбольших интегральных схем с топологическими нормами 0,25 - 0,18 мкм	<u>230,141</u> 143			<u>35,141</u> 13	<u>135</u> 90	<u>30</u> 20	<u>30</u> 20	<u>30</u> 20		создание базовой технологии производства гетероструктур SiGe для выпуска быстроразрабатываемых сверхбольших интегральных схем с топологическими нормами 0,25 - 0,18 мкм (2011 год, 2013 год)

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год		2015 год
87. Разработка технологий выращивания и обработки, в том числе плазмохимической, новых пьезоэлектрических материалов для акустоэлектроники и акустооптики	<u>46,745</u> 34	<u>28,745</u> 22	<u>18</u> 12							создание технологий выращивания и обработки пьезоэлектрических материалов акустоэлектроники и акустооптики для обеспечения производства широкой номенклатуры акустоэлектронных устройств нового поколения (2009 год)
88. Разработка технологий производства соединений A_3B_5 и тройных структур для: производства сверхмощных лазерных диодов; высокоэффективных светодиодов белого, зеленого, синего и ультрафиолетового диапазонов; фотоприемников	<u>93,501</u> 58		<u>24,001</u> 12	<u>33</u> 22	<u>23</u> 15	<u>13,5</u> 9				создание технологий массового производства исходных материалов и структур для перспективных приборов лазерной и оптоэлектронной техники, в том числе: производства сверхмощных лазерных диодов (2010 год); высокоэффективных светодиодов белого, зеленого, синего и

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе					Ожидаемые результаты			
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год		2013 год	2014 год	2015 год
среднего инфракрасного диапазона										ультрафиолетового диапазонов (2011 год); фотоприемников среднего инфракрасного диапазона (2013 год)
89. Исследование и разработка технологии получения гетероструктур с вертикальными оптическими резонаторами на основе квантовых ям и квантовых точек для производства вертикально излучающих лазеров для устройств передачи информации и матриц для оптоэлектронных переключателей нового поколения	<u>45.21</u> 30	<u>30.31</u> 22	<u>14.9</u> 8							создание технологии производства принципиально новых материалов полупроводниковой электроники на основе сложных композиций для перспективных приборов лазерной и оптоэлектронной техники (2009 год)

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	
90. Разработка технологий производства современных компонентов для специализированных фотоэлектронных приборов, в том числе: катодов и газопоглотителей; электронно-оптических и отклоняющих систем; стеклооболочек и деталей из электровакуумного стекла различных марок	$\frac{32,305}{17}$			$\frac{24,805}{12}$	$\frac{7,5}{5}$				создание технологий производства компонентов для специализированных электронно-лучевых (2010 год), электронно-оптических и отклоняющих систем (2010 год), стеклооболочек и деталей из электровакуумного стекла различных марок (2011 год)
91. Разработка технологий производства особо тонких гетерированных нанопримесями полупроводниковых структур для высокоэффективных фотокаатов,	$\frac{39,505}{32}$	$\frac{27,505}{20}$	$\frac{12}{12}$						создание технологий производства особо тонких гетерированных нанопримесями полупроводниковых структур для изготовления высокоэффективных фотокаатов

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год		2015 год
электронно-оптических преобразователей и фотоэлектронных умножителей, приемников инфракрасного диапазона и солнечных элементов с высокими значениями коэффициента полезного действия										электронно-оптических преобразователей и фотоэлектронных умножителей, приемников инфракрасного диапазона, солнечных элементов и других приложений (2009 год)
92. Разработка базовой технологии производства монокристаллов AlN для изготовления изолирующих и проводящих подложек для гетероструктур	$\frac{42,013}{24}$			$\frac{24,013}{12}$	$\frac{18}{12}$					создание технологии монокристаллов AlN для изготовления изолирующих и проводящих подложек для создания полупроводниковых высокотемпературных и мощных сверхвысокочастотных приборов нового поколения (2011 год)

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	
93. Разработка базовой технологии производства наноструктурированных оксидов металлов (корунда и т.п.) для производства вакуумно-плотной нанокерамики, в том числе с заданными оптическими свойствами	<u>44,599</u> 29,2	<u>29,694</u> 19,85	<u>14,905</u> 9,35						создание базовой технологии вакуумно-плотной слецстойкой керамики из нанокристаллических порошков и нитридов металлов для промышленного освоения слецстойких приборов нового поколения (2009 год), в том числе микрочипов, сверхвысокочастотных аттенюаторов, RLC-матриц, а также особо прочной электронной компонентной базы оптоэлектроники и фотоники
94. Разработка базовой технологии производства полимерных и гибридных органических наноструктурированных защитных	<u>25,006</u> 13		<u>22,006</u> 11		<u>3</u> 2				создание технологии производства полимерных и композиционных материалов с использованием поверхностной и объемной

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год		2015 год
материалов для электронных компонентов нового поколения прецизионных и сверхвысоко- частотных резисторов, терминаторов, аттенюаторов и резисторно- индукционно- емкостных матриц, стойких к воздействию комплекса специальных внешних факторов									модификации полимеров наноструктуриро- ванными наполнителями для создания изделий с высокой механической, термической и радиационной стойкостью при работе в условиях длительной эксплуатации и воздействии комплекса специальных внешних факторов (2011 год)	
95. Исследование и разработка перспективных гетероструктурных и наноструктури- рованных материалов с экстремальными характеристиками для перспективных электронных	<u>1365,875</u> 910,25				<u>225</u> 150	<u>269</u> 179	<u>309</u> 206	<u>306,375</u> 204,25	<u>256,5</u> 171	создание базовой технологии производства гетероструктур, структур и псевдоморфных структур на подложках InP для перспективных полупроводниковых приборов и

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе								Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год		
приборов и радиоэлектронной аппаратуры специального назначения											сверхвысокочастот- ных монокристаллических интегральных схем диапазона 60 - 90 ГГц (2012 год), создание технологии получения алмазных полупроводниковых наноструктур и наноразмерных органических покрытий (2013 год), алмазных полупроводящих пленок для конкурентоспособ- ных высокотемпе- ратурных и радиационно стойких устройств и приборов двойного назначения, создание технологии изготовления гетероструктур и эпитаксиальных структур на основе нитридов (2015 год)
96. Исследование и разработка экологически	<u>1283,625</u> 855,75	<u>435</u> 290	<u>300</u> 200	<u>263,625</u> 175,75	<u>285</u> 190						создание нового класса конструкционных и

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год		2015 год
чистых материалов и методов их использования в производстве электронной компонентной базы и радиоаппаратуры, включая бессвинцовые композиции для сборки									технологических материалов для уровней технологии 0,065 - 0,032 мкм и обеспечения высокого процента выхода годных изделий, экологических требований по международным стандартам (2012 год, 2015 год)	
97. Разработка перспективных технологий получения ленточных материалов (полимерные, металлические, плакированные и другие) для радиоэлектронной аппаратуры и сборочных операций электронной компонентной базы	<u>1333,625</u> 889,75					<u>404</u> 270	<u>352,5</u> 235	<u>292,125</u> 194,75	<u>285</u> 190	создание перспективных технологий производства компонентов для специализированных электронно-лучевых, электронно- оптических и отклоняющих систем, стеклооболочек и деталей из электровакуумного стекла различных марок (2013 год), создание технологии производства

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе									Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год		

полимерных и композиционных материалов с использованием поверхностной и объемной модификации полимеров наноструктурированными наполнителями (2015 год)

Всего по направлению 5	<u>6345,799</u>	<u>621,754</u>	<u>658,169</u>	<u>365,251</u>	<u>717</u>	<u>1260</u>	<u>1035</u>	<u>862,125</u>	<u>826,5</u>
	4150,82	407,85	431,6	177,62	478	840	690	574,75	551

Направление 6. Группы пассивной электронной компонентной базы

98. Разработка технологий выпуска прецизионных температуростабильных высокочастотных до 1,5 - 2 ГГц резонаторов на поверхностно акустических волнах до 1,5 ГГц с полосой до 70 процентов	<u>30,928</u>	<u>18</u>	<u>12,928</u>						
	20	12	8						

разработка расширенного ряда резонаторов с повышенной кратковременной и долговременной стабильностью для создания контрольной аппаратуры и техники связи двойного назначения

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Ожидаемые результаты				
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год		2014 год	2015 год		
и длительностью сжатого сигнала до 2 - 5 нс												
99. Разработка в лицензируемых и нелицензируемых международных частотных диапазонах 860 МГц и 2,45 ГГц ряда радиочастотных пассивных и активных акустоэлектронных меток- транспондеров, в том числе работающих в реальной помеховой обстановке, для систем радиочастотной идентификации и систем управления Доступом	<u>78,5</u> 45	<u>32</u> 14	<u>33</u> 22	<u>13,5</u> 9								создание технологии и конструкции акустоэлектронных пассивных и активных меток- транспондеров для применения в логистических приложениях на транспорте, в торговле и промышленности (2010 год, 2011 год)

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	
100. Разработка базовой конструкции и промышленной технологии производства пьезокерамических фильтров в корпусах для поверхностного монтажа	<u>30,5</u> 19,5	<u>17</u> 11	<u>13,5</u> 8,5						создание технологии проектирования и базовых конструкций пьезоэлектрических фильтров в малогабаритных корпусах для поверхностного монтажа при изготовлении техники связи массового применения (2009 год)
101. Разработка технологии проектирования, базовой технологии производства и конструирования акустоэлектронных устройств нового поколения и фильтров промежуточной частоты с высокими характеристиками для современных систем связи, включая высокоизбирательные	<u>37,73</u> 23	<u>37,73</u> 23							создание базовой технологии акустоэлектронных приборов для перспективных систем связи, измерительной и навигационной аппаратуры нового поколения - подвижных, спутниковых, тропосферных и радиорелейных линий связи, цифрового интерактивного телевидения, радиоизмерительной

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	
высокочастотные устройства частотной селекции на поверхностных и приповерхностных волнах и волнах Гуляева-Блюштейна с предельно низким уровнем вносимого затухания для частотного диапазона до 5 ГГц									аппаратуры, радиолокационных станций, спутниковых навигационных систем (2008 год)
102. Разработка технологии проектирования и базовой технологии производства функциональных законченных устройств стабилизации, селекции частоты и обработки сигналов типа "система в корпусе"	<u>97,416</u> 60,9	<u>35,001</u> 22	<u>62,415</u> 38,9						создание технологии производства высокоинтегриро- ванной электронной компонентной базы типа "система в корпусе" для вновь разрабатываемых и модернизируемых сложных радиоэлектронных систем и комплексов (2010 год)
103. Разработка базовой конструкции и технологии изготовления	<u>63</u> 42	<u>21</u> 14	<u>21</u> 14	<u>21</u> 14	<u>21</u> 14	<u>21</u> 14	<u>21</u> 14		создание базовой технологии (2013 год) и базовой конструкции

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	
высокочастотных резонаторов и фильтров на объемных акустических волнах для телекоммуника- ционных и навигационных систем									микроминиатюрных высокочастотных фильтров для малогабаритной и носимой аппаратуры навигации и связи
104. Разработка технологий и базовой конструкции фоточувстви- тельных приборов с матричными приемниками высокого разрешения для видимого и ближнего инфракрасного диапазона для аппаратуры контроля изображений	<u>35</u> 23								создание нового поколения оптоэлектронных приборов для обеспечения задач предотвращения аварий и контроля

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	
105. Разработка базовой технологии унифицированных электронно-оптических преобразователей, микроканальных пластин, пирозлектрических матриц и камер на их основе с чувствительностью до 0,1 К и широкого инфракрасного диапазона	<u>35.309</u> 21,9	<u>16.009</u> 10	<u>19,3</u> 11,9						создание базовой технологии нового поколения приборов контроля тепловых полей для задач теплоэнергетики, медицины, поисковой и контрольной аппаратуры на транспорте, продуктопроводах и в охранных системах (2009 год)
106. Разработка базовой технологии создания интегрированных гибридных фотоэлектронных высокочувствительных и высокоразрешающих приборов и усилителей для задач космического мониторинга и специальных систем наблюдения,	<u>82</u> 53	<u>45</u> 30	<u>37</u> 23						создание базовой технологии (2008 год) и конструкции новых типов приборов, сочетающих фотоэлектронные и твердотельные технологии, с целью получения экстремально достижимых характеристик для задач контроля и наблюдения в системах двойного назначения

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	
научной и метрологической аппаратуры									
107. Разработка базовых технологий мощных полупроводнико- вых лазерных диодов (непрерывного и импульсного излучения), специализиро- ванных лазерных полупроводнико- вых диодов, фотодиодов и лазерных волоконно- оптических модулей для создания аппаратуры и систем нового поколения	<u>96,537</u> 64	<u>48,136</u> 30	<u>48,401</u> 34						создание базовой технологии (2008 год) и конструкций принципиально новых мощных диодных лазеров, предназначенных для широкого применения в изделиях двойного назначения, медицины, полиграфического оборудования и системах открытой оптической связи
108. Разработка и освоение базовых технологий для лазерных	<u>56,5</u> 37	<u>16</u> 10	<u>30</u> 20	<u>10,5</u> 7					разработка базового комплекта основных оптоэлектронных компонентов для

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	
навигационных приборов, включая интегральный оптический модуль лазерного гироскопа на базе сверхмалогабаритных кольцевых полупроводниковых лазеров инфракрасного диапазона, оптоэлектронные компоненты для широкого класса инерциальных лазерных систем управления движением гражданских и специальных средств транспорта									лазерных гироскопов широкого применения (2010 год), создание комплекса технологий обработки и формирования структурных и приборных элементов, оборудования контроля и аттестации, обеспечивающих новый уровень технико-экономических показателей производства
109. Разработка базовых конструкций и технологий создания квантово-электронных приемопередающих модулей для	<u>22</u> 15	<u>22</u> 15							создание базовой технологии твердотельных чип-лазеров для лазерных дальномеров, твердотельных лазеров с

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	

малогабаритных
 лазерных
 дальномеров нового
 поколения на
 основе
 твердотельных
 чип-лазеров с
 полупроводниковой
 накачкой,
 технологических
 лазерных установок
 широкого
 спектрального
 диапазона

пикосекундными
 длительностями
 импульсов для
 установок по
 прецизионной
 обработке
 композитных
 материалов, для
 создания элементов и
 изделий
 микромашино-
 строения и в
 производстве
 электронной
 компонентной базы
 нового поколения,
 мощных лазеров для
 применения в
 машиностроении,
 авиастроении,
 автомобилестроении,
 судостроении, в
 составе
 промышленных
 технологических
 установок обработки
 и сборки, систем
 экологического
 мониторинга
 окружающей среды,
 контроля выбросов

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	

пагогенных веществ,
контроля утечек в
продуктопроводах
(2008 год, 2009 год)

110. Разработка базовых технологий формирования конструктивных узлов и блоков для лазеров нового поколения и технологии создания полного комплекта электронной компонентной базы для производства лазерного устройства определения наличия опасных, взрывчатых, отравляющих и наркотических веществ в контролируемом пространстве	<u>66,305</u> 43	<u>56,27</u> 37	<u>10,035</u> 6						создание технологии получения широкоапертурных элементов на основе аллюмоиттриевой легированной керамики композитных составов для лазеров с диодной накачкой (2008 год), высокоэффективных преобразователей частоты лазерного излучения, организация промышленного выпуска оптических изделий и лазерных элементов широкой номенклатуры
---	---------------------	--------------------	--------------------	--	--	--	--	--	---

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	
111. Разработка базовых технологий, базовой конструкции и организации производства интегрированных катодоллюминесцентных и других дисплеев двойного назначения со встроенным микроэлектронным управлением	<u>35</u> 35	<u>17</u> 17	<u>18</u> 18						разработка расширенной серии низковольтных катодоллюминесцентных и других дисплеев с широким диапазоном эргономических характеристик и свойств по условиям применения для информационных и контрольных систем
112. Разработка технологий и базовых конструкций высокояркостных светодиодов и индикаторов основных цветов свечения для систем подсветки в приборах нового поколения	<u>38,354</u> 29	<u>23,73</u> 16	<u>14,624</u> 13						создание ряда принципиально новых светоизлучающих приборов с минимальными геометрическими размерами, высокой надежностью и устойчивостью к механическим и климатическим воздействиям, обеспечение за счет замены ламп

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	
113. Разработка базовой технологии и конструкции оптоэлектронных приборов (оптроны, опгореле, светодиоды) в миниатюрных корпусах для поверхностного монтажа	<u>100.604</u> 59	<u>21.554</u> 10	<u>61.05</u> 37	<u>18</u> 12				накапливания в системах подветки аппаратуры и освещения
								создание базовой технологии производства нового поколения оптоэлектронной высокоэффективной и надежной электронной компонентной базы для промышленного оборудования и систем связи (2010 год, 2011 год)
114. Разработка схемотехнических решений и унифицированных базовых конструкций и технологий формирования твердотельных видеомодулей на полупроводниковых светоизлучающих структурах для	<u>51.527</u> 33,5	<u>27.527</u> 17,5	<u>24</u> 16					создание технологии новых классов носимой и стационарной аппаратуры, экранов отображения информации коллективного пользования повышенной емкости и формата (2009 год)

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год		2015 год
носимой аппаратуры, экранов индивидуального и коллективного пользования с беспроводной стыковкой										
115. Разработка базовой технологии изготовления высокоэффек- тивных солнечных элементов на базе использования кремния, полученного по "бесхлоридной" технологии и технологии "литого" кремния прямоугольного сечения	<u>57,304</u> 37	<u>31,723</u> 20	<u>25,581</u> 17							создание технологии массового производства солнечных элементов для индивидуального и коллективного использования в труднодоступных районах, развития солнечной энергетики в жилищно- коммунальном хозяйстве для обеспечения задач энергосбережения (2009 год)
116. Разработка базовой технологии и освоение производства оптоэлектронных	<u>32</u> 19	<u>18</u> 12	<u>14</u> 7							создание технологии массового производства нового класса оптоэлектронных

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год		2014 год
реле с повышенными техническими характеристиками для поверхностного монтажа									приборов для широкого применения в радиоэлектронной аппаратуре (2009 год)
117. Комплексное исследование и разработка технологий получения новых классов органических (полимерных) люминофоров, пленочных транзисторов на основе "прозрачных" материалов, полимерной пленочной основы и технологий изготовления крупноформатных гибких и особо плоских экранов, в том числе на базе высокоразреша- ющих процессов	<u>136,7</u> 71,8	<u>50</u> 22	<u>63</u> 34	<u>23,7</u> 15,8					создание базовой технологии массового производства экранов с предельно низкой удельной стоимостью для информационных и обучающих систем (2010 год, 2011 год)

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Ожидаемые результаты					
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год		2014 год	2015 год			
струйной печати и непрерывного процесса изготовления типа "с катушки на катушку"													
118. Разработка базовых конструкций и технологии активных матриц и драйверов плоских экранов на основе аморфных, поликристалли- ческих и кристаллических кремниевых интегральных структур на различных подложках и создание на их основе перспективных видеомодулей, включая органические электрoлюми- несцентные, жидкокристал-	<u>145.651</u> 100,5	<u>13.526</u> 8,5	<u>87.125</u> 62										создание технологии и конструкции активно-матричных органических электрoлюми- несцентных, жидкокристалли- ческих и катоdолюми- несцентных дисплеев, стойких к внешним специальным и климатическим воздействиям (2010 год)

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	
личные и катодолюминес- центные, создание базовой технологии серийного производства монокристаллических модулей двойного назначения	<u>85.004</u> 46		<u>41.004</u> 10	<u>20</u> 20	<u>24</u> 16				создание технологии и базовых конструкций полноцветных газоразрядных видеомодулей специального и двойного назначения для наборных экранов коллективного пользования (2010 год)
119. Разработка базовой конструкции и технологии крупноформатных полноцветных газоразрядных видеомодулей									
120. Разработка технологии сверхпрецизионных резисторов и гибридных интегральных схем цифроаналоговых и аналого-цифровых	<u>63.249</u> 42	<u>24.013</u> 16	<u>18.027</u> 12	<u>21.209</u> 14					разработка расширенного ряда сверхпрецизионных резисторов, гибридных интегральных схем цифроаналоговых и аналого-цифровых преобразователей с

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	
преобразователей на их основе в металлокерами- ческих корпусах для аппаратуры двойного назначения									параметрами, превышающими уровень существующих отечественных и зарубежных изделий, для аппаратуры связи, диагностического контроля, медицинского оборудования, авиастроения, станкостроения, измерительной техники (2010 год)
121. Разработка базовой технологии особо стабильных и особо точных резисторов широкого диапазона номиналов, прецизионных датчиков тока для измерительной и контрольной аппаратуры и освоение их производства	$\frac{72}{48}$				$\frac{30}{20}$	$\frac{30}{20}$	$\frac{12}{8}$		разработка расширенного ряда сверхпрецизионных резисторов с повышенной удельной мощностью рассеяния, высоковольтных, высокоомных резисторов для измерительной техники, приборов ночного видения и аппаратуры контроля (2013 год)

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	
122. Разработка технологий и базовых конструкций резисторов и резистивных структур нового поколения для поверхностного монтажа, в том числе резисторов с повышенными характеристиками, ультранизкоомных резисторов, малогабаритных подстроечных резисторов, интегральных сборок серии нелинейных полупроводниковых резисторов в многослойном исполнении чип-конструкции	<u>149,019</u> 100	<u>10,5</u> 7	<u>18,519</u> 13	<u>24,75</u> 16,5	<u>45</u> 30	<u>50,25</u> 33,5			создание базовой технологии и конструкции резисторов с повышенными значениями стабильности, удельной мощности в чип-исполнении на основе многослойных монокристаллических структур (2010 год, 2013 год)
123. Разработка технологий формирования интегрированных	<u>46,93</u> 30,95	<u>10,929</u> 6,95	<u>36,001</u> 24						создание базовой технологии производства датчиков на

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе					Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	

резистивных структур с повышенными технико-эксплуатационными характеристиками на основе микроструктурированных материалов и методов групповой сборки										резистивной основе с высокими техническими характеристиками и надежностью (2009 год)
124. Создание групповой технологии автоматизированного производства толстоленочных чип- и микрочип-резисторов	<u>59,011</u> 39	<u>30,006</u> 20	<u>29,005</u> 19							создание технологии автоматизированного производства чип- и микрочип-резисторов (в габаритах 0402, 0201 и менее) для применения в массовой аппаратуре (2009 год)
125. Разработка новых базовых технологий и конструктивных решений изготовления танталовых оксидно-полупроводниковых и оксидно-	<u>126</u> 83	<u>24</u> 16	<u>27</u> 17	<u>75</u> 50						создание базовой технологии производства конденсаторов с качественно улучшенными характеристиками с электродами из неблагородных

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	

электролитических конденсаторов и чип-конденсаторов и организация производства конденсаторов с повышенным удельным зарядом, сверхнизким значением внутреннего сопротивления и улучшенными потребительскими характеристиками

металлов при сохранении высокого уровня надежности (2010 год)

126. Разработка комплексной базовой технологии и организация производства конденсаторов с органическим диэлектриком и повышенными удельными характеристиками и ионисторов с повышенным током разряда	<u>29,801</u> 18	<u>22,277</u> 13	<u>7,524</u> 5						создание базовых технологий конденсаторов и ионисторов на основе полимерных материалов с повышенным удельным зарядом и энергоемких накопительных конденсаторов с повышенной удельной энергией (2009 год)
--	---------------------	---------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	
127. Разработка технологий, базовых конструкций высоковольтных (быстродействующих, мощных) вакуумных выключателей нового поколения с предельными характеристиками для радиотехнической аппаратуры с высокими сроками службы	<u>94,006</u> 62	<u>23,5</u> 15	<u>39,006</u> 26	<u>31,5</u> 21					создание технологий и базовых конструкций нового поколения выключателей для радиоэлектронной аппаратуры с повышенными тактико-техническими характеристиками и надежностью (2011 год)
128. Разработка технологий создания газонаполненных высоковольтных высокочастотных коммутирующих устройств для токовой коммутации целей с повышенной техничностью характеристиками	<u>50,599</u> 33,5	<u>24,803</u> 16,5	<u>25,796</u> 17						создание технологий изготовления коммутирующих устройств для токовой коммутации цепей в широком диапазоне напряжений и токов для радиоэлектронных и электротехнических систем (2009 год)

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	
129. Разработка полного комплекта электронной компонентной базы для создания модульного устройства грозозащиты зданий и сооружений с обеспечением требований по международным стандартам	<u>26,5</u> 17,5	<u>26,5</u> 17,5							создание технологии выпуска устройств грозозащиты в индивидуальном, промышленном и гражданском строительстве, строительстве пожароопасных объектов (2008 год)
130. Разработка базовых конструкций и технологий изготовления малогабаритных переключателей с повышенными сроками службы для печатного монтажа	<u>55</u> 37	<u>46</u> 31	<u>9</u> 6						создание базовой технологии формирования высококачественных гальванических покрытий, технологии прецизионного формирования изделий для автоматизированных систем изготовления коммутационных устройств широкого назначения (2009 год)

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе								Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	
131. Комплексное исследование и разработка пленочных технологий изготовления высокоэкономичных крупноформатных гибких и особо плоских экранов	<u>741,505</u> 494,67				<u>80,55</u> 53,7	<u>181</u> 121	<u>172,5</u> 115	<u>172,08</u> 114,72	<u>135,375</u> 90,25	комплексное исследование и разработка технологий получения новых классов органических светоизлучающих диодов (ОСИД), полимерной пленочной основы и технологий изготовления гибких ОСИД-экранов, в том числе на базе высокоразрешающих процессов струйной печати, процессов нанопринта и рулонной технологии изготовления
132. Исследование перспективных конструкций и технологических принципов формирования оптоэлектронных и квантовых структур и приборов нового поколения	<u>754,875</u> 503,25				<u>75</u> 50	<u>217,5</u> 145	<u>156,75</u> 104,5	<u>177,75</u> 118,5	<u>127,875</u> 85,25	создание технологии формирования нового поколения оптоэлектронных комплексированных приборов, обеспечивающих создание "системы на кристалле" с

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе									Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год		
133. Разработка перспективных технологий промышленного изготовления солнечных высокоэффективных элементов	<u>796,05</u> 530,7					<u>255</u> 170	<u>247,5</u> 165	<u>171</u> 114	<u>122,55</u> 81,7		оптическими входами-выходами (2014 год, 2015 год) создание перспективной технологии массового производства солнечных элементов для индивидуального и коллективного использования (2015 год)
Всего по направлению 6	<u>4478,414</u> 2937,67	<u>688,198</u> 456	<u>611,262</u> 365,35	<u>510,324</u> 336,9	<u>352,5</u> 235	<u>749,5</u> 500	<u>660</u> 440	<u>520,83</u> 347,22	<u>385,8</u> 257,2		
Направление 7. Унифицированные электронные модули и базовые несущие конструкции											
134. Разработка базовых технологий создания рядов приемопередающих унифицированных электронных модулей для аппаратуры связи, радиолокации, телекоммуникаций,	<u>4155,333</u> 2729,15	<u>130,715</u> 90,1	<u>167,733</u> 113,6	<u>127,015</u> 87,7	<u>630</u> 420	<u>1058</u> 691	<u>707,55</u> 471,7	<u>671,2</u> 440,8	<u>663,12</u> 414,25		создание на основе современной и перспективной отечественной электронной компонентной элементной базы и последних достижений в разработке алгоритмов сжатия

	В том числе										Ожидаемые результаты
	2008 - 2015 годы - всего	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год		

бортовых
радиотехнических
средств

видеоизображений
приемо-передающих
унифицированных
электронных модулей
аппаратуры связи,
телекоммуникаций,
цифрового
телевидения,
бортовых
радиотехнических
средств, активных
фазированных
антенных решеток
с параметрами:
диапазон частот
до 100 ГГц;
скорость передачи
информации
до 100 Гбит/с;
создание базовых
технологий и
конструкций для
создания
унифицированных
рядов приемо-
передающих
унифицированных
электронных модулей
аппаратуры
волоконно-
оптических линий

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год		2015 год
135. Разработка базовых технологий создания нового класса унифицированных электронных модулей для обработки аналоговых и цифровых сигналов на основе устройств функциональной электроники, приборов обработки сигналов аналого-цифровых и цифроаналоговых	<u>2971,904</u> 1971,1	<u>91,404</u> 61,1	<u>159,155</u> 104,9	<u>101,29</u> 56,4	<u>465</u> 310	<u>797</u> 540	<u>706,8</u> 471,2	<u>307,83</u> 198,55	<u>343,425</u> 228,95	связи когерентных, высокоскоростных каналов со спектральным уплотнением, телекоммуникаций, цифрового телевидения, обеспечивающих импортозамещение в этой области; разработка новых технологий
										создание на основе базовых технологий и современной отечественной твердотельной компонентной электронной базы унифицированных электронных модулей нового поколения для обработки аналоговых и цифровых сигналов РЛС и других радиотехнических систем в высокочастотных,

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год		2015 год
преобразователей, сенсоров и преобразователей									ПЧ и сверхвысокочастот- ных диапазонах, освоение производства нового класса многофункциональ- ных радиоэлектронных устройств, разработка унифицированных электронных модулей преобразователей физических и химических величин для измерения и контроля широкой номенклатуры параметров микромеханических систем	
136. Разработка базовых технологий создания рядов унифицированных электронных модулей для систем телеметрии, управления, навигации (угловых и линейных	<u>1616,67</u> 1080,4	<u>47,185</u> 32,5	<u>77,477</u> 42,2	<u>63,783</u> 45,55	<u>285</u> 190	<u>453</u> 313	<u>247,5</u> 162	<u>207,45</u> 138,3	<u>235,275</u> 156,85	создание рядов унифицированных электронных модулей для систем телеметрии, управления, радиолокационных, робототехнических, телекоммуникаци- онных систем и

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе								Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год		
перемещений, ориентации, стабилизации, позиционирования, наведения, радиопеленгации, единого времени)											навигации (ориентации, стабилизации, позиционирования, наведения, радиопеленгации, единого времени), позволяющих резко снизить стоимость и организовать крупносерийное производство радиоэлектронных средств широкого применения
137. Разработка базовых технологий создания рядов унифицированных электронных модулей процессоров, скоростного и сверхскоростного ввода-вывода данных, шифрования и дешифрования данных, интерфейсов	<u>3031,173</u> 2012,89	<u>60,024</u> 40	<u>89,053</u> 53,5	<u>63,082</u> 42,04	<u>540</u> 360	<u>977</u> 658	<u>447</u> 296	<u>440,35</u> 286,9	<u>414,664</u> 276,45		создание на основе современной и перспективной отечественной электронной компонентной базы унифицированных электронных модулей широкой номенклатуры для применения в различных информационных системах, в том числе унифицированных

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	

обмена, систем
сбора и хранения
информации,
периферийных
устройств, систем
идентификации и
управления
доступом,
конверторов,
информационно-
вычислительных
систем

электронных модулей
шифрования и
дешифрования
данных;
разработка базовых
технологий и
конструкций
унифицированных
электронных модулей
на поверхностных
акустических волнах
систем
радиочастотной и
биометрической
идентификации,
систем
идентификации
личности,
транспортных
средств,
электронных
паспортов, логистики,
контроля доступа на
объекты повышенной
безопасности,
объектов атомной
энергетики.
В создаваемых
унифицированных
электронных модулях
будет обеспечена

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год		2015 год
138. Разработка базовых технологий создания рядов унифицированных электронных цифровых модулей для перспективных магистрально-модульных архитектур	<u>1823,4</u> 1215,25	<u>49,076</u> 32,7	<u>64,824</u> 43,2	<u>81,236</u> 46,5	<u>270</u> 180	<u>437</u> 303	<u>500,9</u> 329,6	<u>212,314</u> 141,55	<u>208,05</u> 138,7	скорость обмена и передачи информации до 30 Гб/с разработка на основе перспективных отечественных сверхбольших интегральных схем типа "система на кристалле" базового ряда электронных модулей для создания перспективных магистрально-модульных архитектур, обеспечивающих создание защищенных средств вычислительной техники нового поколения (автоматизированные рабочие места, серверы, средства высокоскоростных линий волоконной связи), функционирующих

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	

139. Разработка базовых технологий создания ряда унифицированных электронных модулей для контрольно-измерительной, метрологической и поверочной аппаратуры, аппаратуры тестового контроля, диагностики блоков радиоэлектронной аппаратуры, для стандартных и встроенных систем контроля и измерений	<u>2048,692</u> 1359,844	<u>72,091</u> 35,5	<u>92,753</u> 61,9	<u>61,381</u> 40,8	<u>330</u> 220	<u>536</u> 364	<u>312,9</u> 208,6	<u>328,079</u> 218,719	<u>315,488</u> 210,325	с использованием современных высокоскоростных последовательных и параллельных системных интерфейсов создание на основе современной и перспективной отечественной электронной компонентной базы рядов унифицированных электронных модулей, обеспечивающих возможность создания по модульному принципу контрольно-измерительной, метрологической и поверочной аппаратуры, аппаратуры тестового контроля и диагностики на
---	-----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------	---------------------------	---

	В том числе										Ожидаемые результаты
	2008 - 2015 годы - всего	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год		

основе базовых несущих конструкций; создание комплекта сложнофункциональных блоков, определяющих ядро измерительных приборов, систем и комплексов, разработка законченных функциональных модулей, предназначенных для выполнения процессорных и интерфейсных функций поверки и диагностики сверхбольших интегральных схем типа "система на кристалле" для систем управления, а также систем проектирования и изготовления модулей систем управления и бортовых

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год		2015 год
140. Разработка базовых технологий создания нового поколения унифицированных рядов средств электропитания и преобразователей электроэнергии для радиоэлектронных систем и аппаратуры гражданского и двойного назначения	<u>2932,565</u> 1943,75	<u>58,5</u> 41	<u>95,178</u> 62	<u>91,262</u> 55	<u>480</u> 320	<u>860</u> 574	<u>421,05</u> 280,7	<u>523,45</u> 342,3	<u>403,125</u> 268,75	электронно-вычислительных машин, систем обработки информации и вычислений разработка базовых технологий создания системообразующих унифицированных рядов средств (систем, источников, сервисных устройств) и преобразователей электроэнергии нового поколения межведомственного применения, в том числе средств электропитания с высокой плотностью упаковки элементов с применением бескорпусных изделий, плоских моточных изделий пленочной технологии, новых методов

	В том числе								Ожидаемые результаты	
	2008 - 2015 годы - всего	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год		2015 год
										<p>экранирования, отвода и рассеяния тепла, основанных на применении наноразмерных материалов с высокой анизотропной теплопроводностью. Будут разработаны базовые технологии создания: унифицированных рядов источников электропитания; преобразователей электрической энергии; источников и систем бесперебойного электропитания; фильтров сетевых модулей автоматического переключения каналов; модулей защиты от сетевых помех; адаптеров</p>

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год		2015 год
141. Разработка оптимизированной системы базовых несущих конструкций первого, второго и третьего уровней для наземной, морской, авиационной и космической радиоэлектронной аппаратуры специального и двойного назначения, предназначенной для жестких условий эксплуатации, в том числе работающей в негерметизированном отсеке с использованием прогрессивных технологий	<u>2924,13</u> 1955,1	<u>43</u> 28	<u>84,225</u> 54,5	<u>90</u> 57	<u>525</u> 350	<u>920</u> 612	<u>424</u> 295	<u>431,775</u> 287,85	<u>406,13</u> 270,75	разработка системы базовых несущих конструкций, изготавливаемых на основе прогрессивных технологий и обеспечивающих техническую совместимость со всеми видами современных объектов с использованием новых полимерных материалов. Применение оптимизированных базовых несущих конструкций позволит сократить сроки разработки радиоэлектронной аппаратуры в 1,2 раза, снизить трудоемкость изготовления базовых несущих конструкций в 1,5 - 2 раза, на 25 процентов уменьшить материалоёмкость

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе								Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	

142. Разработка базовых технологий комплексно - интегрированных базовых несущих конструкций с функциями контроля, диагностики, индикации функционирования	<u>2345.464</u> 1566,73	<u>46.16</u> 33	<u>66.651</u> 45,3	<u>60.078</u> 41,38	<u>285</u> 190	<u>482</u> 320	<u>403.8</u> 269,2	<u>511,575</u> 341,05	<u>490.2</u> 326,8	и сократить затраты на производство радиоэлектронной аппаратуры в 1,2 - 1,3 раза, обеспечить эффективное импортозамещение
										разработка базовых несущих конструкций с функциями контроля, в том числе контроля температуры, влажности, задымления в корпусах радиоэлектронной аппаратуры, уровня вибрации, контроля параметров составных частей радиоэлектронной аппаратуры - унифицированных электронных модулей, индикации рабочих режимов и аварийных сигналов для идентификации контролируемых

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе								Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	
143. Разработка базовых технологий создания облегченных	<u>1206,093</u> 801,05	<u>30,618</u> 20	<u>34,2</u> 22,2	<u>38</u> 24	<u>210</u> 140	<u>362</u> 240	<u>185</u> 124	<u>171</u> 114	<u>175,275</u> 116,85	параметров, разработка герметичных и перфорированных базовых несущих конструкций, обеспечивающих нормальный тепловой режим радиоэлектронной аппаратуры и выполняющих функции измерения и регулирования в требуемом диапазоне температуры и влажности воздуха внутри герметичных и перфорированных базовых несущих конструкций. Это позволит в 1,5 - 2 раза повысить надежность радиоэлектронной аппаратуры
										обеспечение улучшения массогабаритных характеристик

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год		2015 год
паяных базовых несущих конструкций для радиоэлектронной аппаратуры авиационного и космического базирования на основе существующих и перспективных алюминиевых сплавов повышенной прочности, обеспечивающих отвод тепла по элементам конструкции									бортвой аппаратуры на 30 процентов и повышение прочности при внешних воздействиях в 1,5 - 2 раза	
144. Разработка контейнерных базовых несущих конструкций с унифицированными интерфейсными средствами для комплексирования бортовых и наземных систем	<u>965,425</u> 637,75	<u>21</u> 14	<u>32,4</u> 20,4	<u>38</u> 24	<u>180</u> 120	<u>275</u> 180	<u>144</u> 96	<u>139,65</u> 93,1	<u>135,375</u> 90,25	повышение уровня системной интеграции и комплексирования средств и систем, повышение конкурентоспособ- ности не менее чем в 2 раза, обеспечение функциональности

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	

и комплексов различного назначения
 аппаратуры в условиях внешних жестких воздействий

Всего по направлению 7 26020,849 649,773 963,649 815,127 4200 7157 4500,5 3944,673 3790,127
17273,014 427,9 623,7 520,37 2800 4795 3004 2603,119 2498,925

Направление 8. Типовые базовые технологические процессы

145. Разработка технологий изготовления высокоплотных теплонагруженных и сильноточных печатных плат
2826,375 45 75,057 66,568 555 848 407,4 434,625 394,725
1893,5 30 50 44 370 575 271,6 289,75 263,15
 обеспечение разработки технологий:
 производства печатных плат 5-го и выше классов точности, включая платы со встроенными пассивными элементами; создания межслойных соединений с переходными сопротивлениями до 1 мОм для силовых цепей
 электропитания; формирования слоев меди (в том числе с толщиной до 200 - 400 мкм),

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год		2015 год
146. Разработка технологии изготовления прецизионных коммутационных плат на основе керамики (в том числе низкотемпера-	<u>1829,852</u> 1221,5	<u>35,733</u> 25	<u>52,195</u> 35	<u>49,124</u> 33,3	<u>360</u> 240	<u>545</u> 363	<u>271,95</u> 181,3	<u>260,775</u> 173,85	<u>255,075</u> 170,05	серебра, никеля с высокими показателями проводимости; формирования финишных покрытий для бессвинцовой технологии производства изделий; производства многослойных печатных плат под высокие температуры пайки; лазерных процессов изготовления печатных плат, прямой металлизации сквозных и глухих отверстий обеспечение разработки технологий: изготовления коммутационных плат для жестких условий эксплуатации и широкого диапазона

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	

турной), металла,
углепластика и
других
функциональных
материалов

частот;
получения
коммутационных
плат с
температурным
коэффициентом
расширения,
соответствующим
тепловым
характеристикам
многовыводных
корпусов (в том числе
керамических)
современных
приборов;
обеспечения
предельно
минимального
газовыделения в
замкнутом
пространстве
герметичных
модулей; снижения
энергоёмкости
технологических
процессов за счет
применения
прогрессивных
материалов и методов
обработки, в том
числе

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе								Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	
147. Разработка технологий сборки, монтажа электронных модулей, многокристалльных модулей и микросборок на основе новой компонентной базы,	3385,67 2247,95	65,121 43	107,805 63	67,219 44,6	615 410	1033 689	547,05 364,7	503,025 335,35	447,45 298,3	низкотемпературной керамики; интеграции в коммутационную плату теплостокосов и низкоомных проводников, пассивных элементов; прогрессивных методов формообразования элементов коммутационных плат; обеспечения совмещенного монтажа компонентов методами пайки и сварки на одной плате
										обеспечение разработки технологий: новых методов присоединения, сварки, пайки, в том числе с применением бесвишневых припоев; высокоточного

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	

перспективных
технологических и
конструкционных
материалов

дозирования
материалов,
применяемых при
сборке (флюсы,
припой и припойные
пасты, клеи, лаки,
компаунды и т.п.);
новых методов
сборки и пайки
корпусов типа BGA,
CSP, Flip-chip и
других на различные
коммутационные
платы;
монтажа новой
электронной
компонентной базы,
в том числе
бескорпусных
кристаллов силовых
ключей на токовые
шины; сборки и
монтажа
низкопрофильных
магнитных
компонентов;
настройки и ремонта
сложных модулей,
в том числе
демонтажа и
повторного монтажа

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год		2015 год
148. Разработка технологий создания межблочных соединений для коммутации сигналов в широком диапазоне частот и мощностей	<u>1295,545</u> 863,03	<u>29</u> 19	<u>36,5</u> 24	<u>36,5</u> 24	<u>225</u> 150	<u>382</u> 255	<u>206,07</u> 137,38	<u>198,075</u> 132,05	<u>182,4</u> 121,6	обеспечение разработки технологий: изготовления антенно-фидерных устройств, в том числе гибких волноводов, вращающихся сочленений с различными видами охлаждения; оптоволоконной коммутации, устойчивой к воздействию жестких условий эксплуатации для различных условий применения, в том числе для систем дистанционного управления и мониторинга; изготовления устройств

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год		2015 год
149. Разработка методов, средств и технологии автоматизиро- ванного контроля коммутационных плат, узлов, электронных модулей и приборов специального и общего применения на этапах разработки и производства	<u>2125,767</u> 1417,15	<u>35,154</u> 23	<u>61,38</u> 41	<u>47,258</u> 31,5	<u>225</u> 150	<u>382</u> 255	<u>379,05</u> 252,7	<u>472,875</u> 315,25	<u>523,05</u> 348,7	повышение процента выхода годных изделий, снижение потерь на 15 - 30 процентов; обеспечение разработки: неразрушающих методов контроля качества монтажных соединений и многослойных структур за счет использования различного излучения и цифровой обработки информации; методов выявления

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год		2015 год
150. Разработка технологий производства специальных технологических и конструктивных материалов и базовой технологии защиты электронных модулей от воздействия в жестких условиях эксплуатации	<u>3359,151</u> 2196,17	<u>57,178</u> 36	<u>81,504</u> 53,15	<u>73,524</u> 48,97	<u>600</u> 400	<u>1037</u> 658	<u>535,35</u> 356,9	<u>511,47</u> 334,4	<u>463,125</u> 308,75	напряженных состояний элементов конструкции и потенциальных неисправностей изделий; унифицированных методов и средств тестового и функционального контроля изделий различного назначения импортозамещение специальных конструктивных и технологических материалов, обеспечивающих процессы бесвинтовой и комбинированной пайки, изготовления коммутационных плат, разработка влагозащитных электроизоляционных покрытий с минимальным

	В том числе							Ожидаемые результаты
	2008 - 2015 годы - всего	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	

газовыделением со сроком эксплуатации 25 и более лет, разработка быстросотверждающихся, эластичных, с низким газовыделением в вакууме клеев, компаундов, разработка материалов и технологии их применения для формирования теплосточков в высокоплотной аппаратуре, разработка высокоэффективных ферритов для планарных трансформаторов повышенной мощности, обеспечение разработки технологий: локальной защиты чувствительных компонентов, общей

	В том числе										Ожидаемые результаты
	2008 - 2015 годы - всего	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год		

защиты модулей органическими материалами, в том числе наноструктурированными; вакуумно-плотной герметизации узлов и блоков со свободным внутренним объемом до 5 - 10 л методами пайки и сварки; изготовления вакуумно-плотных корпусов многокристалльных модулей и микросборок под поверхностный монтаж на платы; формирования покрытий, обеспечивающих длительную защиту от дестабилизирующих факторов внешней среды, включая ионизирующие излучения, нанесения локальных

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе								Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	

покрытий с
заданными
свойствами на
элементы
конструкции модулей

Всего по
направлению 8 14822,36 267,186 414,441 340,193 2580 4227 2346,87 2380,845 2265,825
9839,3 176 266,15 226,37 1720 2795 1564,58 1580,65 1510,55

Направление 9. Развитие технологий создания радиоэлектронных систем и комплексов

151. Разработка технологий создания систем и оборудования автоматизации проектирования радиоэлектронных систем и комплексов 2578,29 60,032 89,083 81,4 435 887 348,9 342 334,875
1714,85 40 59 52 290 590 232,6 228 223,25

создание технологий отечественного программно-аппаратного обеспечения и средств разработки для автоматизированного проектирования радиоэлектронного оборудования с использованием различных технологических процессов, повышение качества и сокращение сроков разработки радиоэлектронной продукции, создание технологий

	В том числе								Ожидаемые результаты
	2008 - 2015 годы - всего	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	

обеспечения
 информационной
 безопасности
 функционирования
 информационно-
 управляющих систем,
 существенное
 повышение уровня
 защиты информации
 в информационно-
 управляющих
 системах, создание
 базовых
 универсальных
 функциональных
 модулей защиты
 информации от
 несанкционирован-
 ного доступа,
 вирусных атак,
 средств разведки и
 считывания
 информации,
 криптозащиты
 каналов систем,
 реализация полного
 технологического
 цикла
 проектирования,
 испытаний и
 производства

	В том числе							Ожидаемые результаты		
	2008 - 2015 годы - всего	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год		2014 год	2015 год
152. Разработка технологий моделирования сложных информационно-управляющих систем, в том числе систем реального времени	<u>3056,819</u> 2026,45	<u>75,3</u> 49,8	<u>138,5</u> 80	<u>80,194</u> 53,1	<u>525</u> 350	<u>1055</u> 705	<u>429</u> 286	<u>384,75</u> 256,5	<u>369,075</u> 246,05	создание новых способов моделирования: комбинированного способа моделирования, позволяющего существенным образом повысить быстродействие вычислений при сохранении точности расчета выходных показателей эффективности; способа операционно-динамического моделирования; снижение сроков разработки и испытаний радиоэлектронной продукции; повышение достоверности

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год		2015 год
153. Разработка технологий полунатурных и стендовых испытаний сложных информационно- управляющих систем	<u>2397,233</u> 1596,65	<u>45,054</u> 30	<u>70,65</u> 45,65	<u>75,029</u> 50	<u>405</u> 270	<u>975</u> 650	<u>285</u> 190	<u>270,75</u> 180,5	<u>270,75</u> 180,5	математического и имитационного моделирования радиоэлектронных систем и комплексов, обеспечение максимальной сходимости результатов с результатами натурных испытаний и экспериментов
										создание метрологически аттестованной унифицированной стендовой испытательной базы для проведения научно- исследовательских и опытно- конструкторских работ; снижение сроков разработки и стоимости испытаний радиоэлектронной продукции; существенное повышение

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе								Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	
154. Разработка технологий конструирования и производства, а также аппаратно-программного обеспечения метрологических систем различного назначения для создания нового поколения отечественного парка измерительной аппаратуры	<u>2231,71</u> 1485,31	<u>45,05</u> 30	<u>73,65</u> 48,65	<u>68,96</u> 43,96	<u>375</u> 250	<u>907</u> 605	<u>269</u> 179	<u>256,5</u> 171	<u>236,55</u> 157,7	<p>достоверности полунатурного моделирования радиоэлектронных систем и комплексов, обеспечение максимальной схожимости результатов с результатами натурных испытаний</p> <p>разработка базовых технологий, элементов и конструкций для создания парка измерительных систем и приборов, необходимых для разработки и испытаний радиотехнических информационно-управляющих систем, систем связи и телекоммуникаций</p>

	2008 - 2015 годы -		В том числе								Ожидаемые результаты
	2008 - 2015 годы - всего	год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	
Всего по направлению 9	<u>10264,052</u> 6823,26		<u>225,436</u> 149,8	<u>371,883</u> 233,3	<u>305,583</u> 199,06	<u>1740</u> 1160	<u>3824</u> 2550	<u>1331,9</u> 887,6	<u>1254</u> 836	<u>1211,25</u> 807,5	
Направление 10. Обеспечивающие работы											
155. Разработка организационных принципов и научно-технической базы обеспечения проектирования и производства электронной компонентной базы в соответствии с требованиями Всемирной торговой организации	<u>90,6</u> 87,6		<u>9</u> 6	<u>6</u> 6	<u>7</u> 7	<u>10</u> 10	<u>18</u> 18	<u>14</u> 14	<u>13,3</u> 13,3	<u>13,3</u> 13,3	разработка комплекта методической и научно-технической документации для обеспечения функционирования систем проектирования и производства электронной компонентной базы в соответствии с требованиями Всемирной торговой организации
156. Создание и обеспечение функционирования системы испытаний электронной компонентной базы, обеспечивающей поставку изделий с гарантированной надежностью для комплектации	<u>123,9</u> 120,6		<u>16,3</u> 13	<u>20</u> 20	<u>13</u> 13	<u>19</u> 19	<u>18</u> 18	<u>11</u> 11	<u>13,3</u> 13,3	<u>13,3</u> 13,3	разработка новых и совершенствование существующих методов испытаний электронной компонентной базы, разработка методов отбраковочных испытаний перспективной электронной

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год		2015 год
систем специального и двойного назначения									компонентной базы, обеспечение поставки изделий с гарантированной надежностью для комплектации систем специального назначения (атомная энергетика, космические программы, транспорт, системы двойного назначения)	
157. Разработка и совершенствование методов, обеспечивающих качество и надежность сложнофункцио- нальной электронной компонентной базы на этапах опытно- конструкторских работ, освоения и производства	<u>94,55</u> 93,05	<u>8,5</u> 7	<u>12</u> 12	<u>9</u> 9	<u>11</u> 11	<u>18</u> 18	<u>10,4</u> 10,4	<u>13,3</u> 13,3	<u>12,35</u> 12,35	разработка и систематизация методов расчетно- экспериментальной оценки показателей надежности электронной компонентной базы, разрешенной для применения в аппаратуре, функционирующей в специальных условиях и с длительными сроками активного существования

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год		2015 год
158. Создание и внедрение основополагающих документов по обеспечению жизненного цикла изделия на этапах проектирования, производства, применения и утилизации электронной компонентной базы	<u>93,15</u> 84,65	<u>10</u> 7	<u>14,5</u> 9	<u>15</u> 15	<u>10</u> 10	<u>18</u> 18	<u>15</u> 15	<u>13,3</u> 13,3	<u>12,35</u> 12,35	разработка системы технологий обеспечения жизненного цикла изделия при создании широкой номенклатуры электронной компонентной базы
159. Научное сопровождение Программы, в том числе определение технологического и технического уровня развития отечественной и импортной электронной компонентной базы на основе их рубежных технико-экономических показателей, разработка "маршрутных карт"	<u>131,65</u> 120,65	<u>19</u> 13	<u>25</u> 20	<u>15</u> 15	<u>19</u> 19	<u>18</u> 18	<u>10</u> 10	<u>13,3</u> 13,3	<u>12,35</u> 12,35	оптимизация состава выполняемых комплексов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по развитию электронной компонентной базы в рамках Программы и определение перспективных направлений создания новых классов электронной компонентной базы с установлением

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год		2015 год
развития групп электронной компонентной базы										системы технико- экономических и рубежных технологических показателей, разработка "маршрутных карт" развития по направлениям электронной компонентной базы
160. Создание интегрированной информационно- аналитической автоматизиро- ванной системы по развитию электронной компонентной базы, охватывающей деятельность заказчика- координатора, заказчика и организаций, участвующих в выполнении комплекса программных	<u>101,15</u> 94,65	<u>11</u> 7	<u>14,5</u> .12	9 9	<u>10</u> 10	<u>18</u> 18	<u>13</u> 13	<u>13,3</u> 13,3	<u>12,35</u> 12,35	проведение технико- экономической оптимизации выполнения комплексных годовых мероприятий подпрограммы, создание системы действенного финансового и технического контроля выполнения Программы

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год		2015 год
мероприятий, с целью оптимизации состава участников, финансовых средств, перечисляемой государству прибыли и достижения заданных технико- экономических показателей разрабатываемой электронной компонентной базы										
161. Определение перспектив развития российской электронной компонентной базы на основе анализа динамики сегментов мирового и отечественного рынков радиоэлектронной продукции и действующей	<u>96,65</u> 89,65	<u>11</u> 7	<u>13</u> 10	<u>8</u> 8	<u>8</u> 8	<u>18</u> 18	<u>13</u> 13	<u>13,3</u> 13,3	<u>12,35</u> 12,35	формирование системно- ориентированных материалов по экономике, технологиям проектирования и производству электронной компонентной базы, обобщение и анализ мирового опыта для выработки технически и

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	
производственно- технологической базы									экономически обоснованных решений развития электронной компонентной базы
162. Системный анализ результатов выполнения комплекса мероприятий Программы на основе создания отраслевой системы планирования и учета развития разработки, производства и применения электронной компонентной базы по основным технико- экономическим показателям	<u>73</u> 68	<u>11</u> 8	<u>13</u> 11	<u>8</u> 8	<u>7</u> 7	<u>14</u> 14	<u>6,7</u> 6,7	<u>6,65</u> 6,65	создание отраслевой системы учета и планирования развития разработки, производства и применения электронной компонентной базы
Всего по направлению 10	<u>804,65</u> 758,85	<u>95,8</u> 68	<u>118</u> 100	<u>69</u> 69	<u>94</u> 94	<u>140</u> 140	<u>93,1</u> 93,1	<u>99,75</u> 99,75	<u>95</u> 95
Итого по разделу I	<u>94901,655</u> 62686,506	<u>6035,127</u> 3980	<u>6598,632</u> 4241,3	<u>6044,117</u> 3637	<u>14895</u> 9930	<u>22517,65</u> 15024,12	<u>14446,17</u> 9630,78	<u>12706,209</u> 8470,806	<u>11658,75</u> 7772,5

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			

II. Капитальные вложения

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России)

1. Реконструкция и техническое перевооружение действующих радиоэлектронных производств

163. Реконструкция и техническое перевооружение производства сверхвысоко-частотной техники федерального государственного унитарного предприятия "Научно-производственное предприятие "Исток", г. Фрязино, Московская область	<u>744,5</u> 696,5	<u>357</u> 315	<u>191,5</u> 191,5	<u>196</u> 190					2008 - 2010	5293	создание производ- ственно- технологиче- ского комплекса по выпуску твердотельных сверхвысоко- частотных субмодулей мощностью 100 тыс. штук в год
164. Реконструкция и техническое перевооружение федерального государственного	<u>815,5</u> 580,5	<u>124,5</u> 110	<u>170,5</u> 170,5	<u>100,5</u> 90	<u>420</u> 210				2008 - 2011	3424,4	создание производст- венной технологиче- ской линии

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			
унигарного предприятия "Научно- производственное предприятие "Пульсар", г. Москва											по выпуску сверхвысоко- частотных приборов и модулей на широкозонных полупроводни- ках мощностью 360 тыс. штук в год
165. Реконструкция и техническое переворужение федерального государственного унигарного предприятия "Научно- производственное предприятие "Салют", г. Нижний Новгород	<u>233</u> 140*			<u>53</u> 50	<u>180</u> 90				2010 - 2011	3380	расширение мощностей по производству активных элементов и сверхвысоко- частотных монокристаллических интегральных схем с повышенной радиационной стойкостью с 15 до 35 тыс. штук в год**

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			
166. Техническое перевооружение федерального государственного унитарного предприятия "Научно-производственное предприятие "Алмаз", г. Саратов	<u>193,6</u> 140*		<u>93,6</u> 90		<u>100</u> 50				2010- 2011	3058,73	ввод новых мощностей по производству новейших образцов ламп бегущей волны и других сверхвысоко-частотных приборов, в том числе в миллиметровом диапазоне **
167. Реконструкция и техническое перевооружение федерального государственного унитарного предприятия "Научно-производственное предприятие "Торий", г. Москва	<u>348,8</u> 200*		<u>78,8</u> 65		<u>270</u> 135				2010 - 2011	1438	реконструкция производственной линии по выпуску новых сверхмощных сверхвысоко-частотных приборов с повышенным уровнем технических параметров, надежности и долговечности мощностью ** 88 штук в год

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год			
168. Техническое первооружение федерального государственного унитарного предприятия "Новосибирский завод полупроводни- ковых приборов с ОКБ", г. Новосибирск	$\frac{100}{60}$ *			$\frac{40}{30}$	$\frac{60}{30}$			2010 - 2011	1380	реконструкция производст- венной линии для выпуска новых изделий радиационно стойкой электронной компонентной базы, необходимой для организаций Госкорпорации "Росатом" и Роскосмоса
169. Техническое первооружение федерального государственного унитарного предприятия "Научно- производственное	$\frac{133}{90}$ *			$\frac{53}{50}$	$\frac{80}{40}$			2010 - 2011	1973	создание производст- венных мощностей по выпуску радиационно стойкой электронной компонентной базы в количестве 80 - 100 тыс. шт. в год для комплектова- ния

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год				2015 год
предприятия "Восток", г. Новосибирск											важнейших специальных систем**	
170. Техническое переворужение открытого акционерного общества "НИИ молекулярной электроники и завод "Микрон", г. Москва, г. Зеленоград	<u>1520</u> 760*					<u>500</u> 250	<u>380</u> 190	<u>320</u> 160	<u>320</u> 160	2012 - 2015	5240	техническое переворуже- ние завода для выпуска сверхбольших интегральных схем с топологичес- кими нормами 0,18 мкм**
171. Техническое переворужение федерального государственного унитарного предприятия "Научно- исследователь- ский институт "Полус" им. М.Ф.Стедь- маха, г. Москва	<u>240</u> 120*			<u>49,2</u> 24,6	<u>190,8</u> 95,4					2010 - 2011	2411	организация участка прецизионной оптической и механической обработки деталей для лазерных излучателей, твердотельных лазеров и бескарданных лазерных гироскопов нового поколения

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			
172. Техническое перевооружение с целью создания современного малотоннажного производства специальных конструкционных материалов и сплавов для изделий полупроводниковой и электровакуумной СВЧ-электроники на федеральном государственном унитарном предприятии "Научно-производственное предприятие "Исток", г. Фрязино, Московская область	420 210*								2014- 2015	1000 ^{***}	мощностью 442 штуки в год современный технологический комплекс малотоннажного производства специальных конструкционных материалов и сплавов для изделий СВЧ-электроники (сплавы и псевдосплавы меди, молибдена, вольфрама, специальные термостойкие клеи, компаунды, ферритовые материалы, припой на основе олова,
								315 157,5	105 52,5		

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			
173. Реконструкция и техническое переворужение централизован- ного производства базовых несущих конструкций на федеральном государственном унитарном предприятии "Производствен- ное объединение "Квант", г. Великий Новгород	$\frac{166,2}{150}$ *	$\frac{166,2}{150}$							2009	7630,4	обеспечение потребности в базовых несущих конструкциях, в том числе импорто- замещающих, предприятий приборострое- ния, машинострое- ния, судостроения и других отраслей промышлен- ности**
174. Техническое переворужение федерального государственного унитарного предприятия "Научно- исследователь-	$\frac{62}{60}$ *	$\frac{62}{60}$							2009	2404,6	техническое переворуже- ние действующего производства электронной компонентной базы и

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			
ский институт электронно- механических приборов", г. Пенза											микросистемно- техники для создания новых рядов конкуренто- способных изделий электронной техники**
175. Техническое переворужение федерального государственного унитарного предприятия "Научно- исследователь- ский институт электронной техники", г. Воронеж	$\frac{60,1}{30}$	$\frac{60,1}{30}$							2008	120	техническое переворуже- ние действующих производст- венных мощностей по выпуску сверхбольших интегральных схем и мощных сверхвысоко- частотных транзисторов с объемом выпуска сверхбольших интегральных схем 50 тыс. штук в год,

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			
176. Техническое переворужение федерального государственного унигарного предприятия "Научно- исследователь- ский институт физических проблем им. Ф.В.Лукина", г. Москва	$\frac{160}{80^*}$					$\frac{160}{80}$			2012	700	мощных сверхвысоко- частотных транзисторов 10 тыс. штук ** в год организация серийного производства параметри- ческих рядов мембранных датчиков мощностью 10 млн. штук в год и чувствитель- ных элементов для сканирующей зондовой микроскопии мощностью 0,3 млн. штук ** в год
177. Реконструкция и техническое переворужение производства	$\frac{793,22}{396,61^*}$	64	180	490	59,22	29,61			2010 - 2013	12900	расширение производства перспективных тонкостенных

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты		
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год				2015 год	
перспективных тонкостенных антенно- фидерных устройств и волноводных трактов сверхвысоко- частотного диапазона в открытом акционерном обществе "Рыбинский завод приборо- строения", г. Рыбинск, Ярославская область											антенно- фидерных устройств и волноводных трактов сверхвысоко- частотного диапазона, увеличение выпуска в 1,5 раза ** мощностью 44,76 тыс. штук в год		
178. Техническое переворужение в целях создания отраслевого информационно- аналитического центра в открытом акционерном обществе "Центральный	$\frac{120}{60^*}$									40 20	2013 - 2014	900 ^{***}	информа- ционно- аналитическое обеспечение деятельности организаций радио- электронной промышлен- ности **

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год			
научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника", г. Москва										
179. Техническое перевооружение и реконструкция производства и лабораторной базы для разработки и производства перспективных радиоэлектронных модулей, изделий в открытом акционерном обществе "Концерн радиостроения "Вега", г. Москва	<u>1663,86</u> 831,93*					<u>1460</u> 730	<u>203,86</u> 101,93	2012 - 2013	2226	повышение эффективности, надежности и конкурентоспособности отечественных радиоэлектронных модулей, изделий, комплексов и систем открытого акционерного общества "Концерн радиостроения "Вега"***
180. Техническое перевооружение в целях создания	<u>540</u> 270						<u>200</u> 100	2013 - 2014	3000*** 340 170	разработка и внедрение современных

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			
отраслевого информационно- аналитического центра по проектированию радиоэлектронных производств в открытом акционерном обществе "Мосэлектрон- проект", г. Москва											технологий проектирования радиоэлек- тронных производств на базе прогрессивных аппаратно- программных средств автома- тизированного проектиро- вания, в основе которых лежит информа- ционное моделирование зданий
181. Техническое перевооружение для создания производства нового поколения радиоэлектронных модулей в открытом акционерном обществе "Научно-	297,66 148,66*	47,66 23,66	110 55	140 70					2009 - 2011	2456,4	создание комплексного испытательного стенда для исследования образцов техники мощностью 800 штук в год**

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			
производственное предприятие "Рубин", г. Пенза											
182. Техническое первооружение производственно- технологической, контрольно- испытательной базы в открытом акционерном обществе "Инженерно- маркетинговый центр Концерн "Вега", г. Москва	379,9 200*	25,9 23	70 35	80 40	60 30	72 36	72 36	2010 - 2015	996,3	производство систем радиочастотной идентифи- ** кации	
183. Строительство лабораторно- производственного комплекса по выпуску перспективных многофункциональ- ных электронных модулей в открытом акционерном	3200 1600*					1080 540	1060 530	2013 - 2015	15000***	создание нового высо- котехноло- гичного лабораторно- производст- венного комплекса для выпуска многофунк- циональных радиоэлек-	

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			

обществе
"Концерн
радиостроения
"Вега", г. Москва

тронных
узлов, блоков
и приборов на
основе СпК,
МИС,
встраиваемых
пассивных
компонентов
и технологий
высокоплот-
ного монтажа.
Обеспечение
разработки и
выпуска
конкуренто-
способных
изделий,
комплексов
и систем
следующего
поколения
на основе
перспективных
производст-
венных
технологий,
в том числе
модулей для
обработки и
передачи
сигналов

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год				2015 год
г. Ижевск, Удмуртская Республика												
185. Техническое первооружение и реконструкция специализи- рованного производства унифицированных низкочастотных типовых элементов замены и модулей активных фазированных антенных решеток в открытом акционерном обществе "Марийский машиностроитель- ный завод", г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл	<u>1220</u> 610*					380	360	240	240	2012 - 2015	4287	изготовление унифициро- ванных твердотельных низкочастот- ных типовых элементов замены для информацион- ных средств и модулей активных фазированных антенных решеток для локационных систем различного применения, перспективных средств связи и управления воздушным движением**

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			
186. Реконструкция и техническое первооружение производства унифицированных электронных модулей межвидового применения на открытом акционерном обществе "Федеральный научно- производственный центр "Нижегородский научно- исследовательский институт радиотехники", г. Нижний Новгород	<u>699,82</u> 349,91*	<u>140</u> 70			<u>140</u> 70	<u>380</u> 190	<u>179,82</u> 89,91		2011 - 2013	9582	организация производства и внедрение современной технологии с соответствующим персона- жем высокопроизво- дительным оборудованием, увеличение объема ежегодного производства продукции с 2370 млн. рублей в 2007 году до 5028 млн. рублей в ** 2015 году
187. Техническое первооружение специализиро- ванного производства твердотельных передающих и	<u>970</u> 485*	<u>240</u> 120			<u>240</u> 120	<u>277,62</u> 138,81	<u>106,19</u> 53,095	<u>106,19</u> 53,095	2011 - 2015	8442,7	увеличение объемов производства, повышение качества и надежности твердотельных

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			
приемных систем, приемо- передающих модулей активных фазированных антенных решеток в открытом акционерном обществе "Научно- производственное объединение "Правдинский радиозавод", г. Балахна, Нижегородская область											передающих и приемных систем, приемо- передающих модулей активных фазированных антенных решеток L-диапазона для перспективных средств связи и управления воздушным движением **
188. Техническое переворужение и реконструкция специализиро- ванного производства твердотельных передающих и приемных систем, приемо-переда- ющих модулей	$\frac{1230}{615^*}$					$\frac{360}{180}$	$\frac{330}{165}$	$\frac{270}{135}$	$\frac{270}{135}$	$\frac{270}{135}$	увеличение объемов производства, повышение качества и надежности твердотельных передающих и приемных систем, приемо-

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			
активных фазированных антенных решеток в откры- том акционерном обществе "Научно- производственное объединение "Лянозовский электромехани- ческий завод", г. Москва											передающих модулей активных фазированных антенных решеток С- и S-диапазонов волн для перспективных средств связи и управления воздушным движением**
189. Техническое первооружение и реконструкция специализиро- ванного производства унифицированных высокочастотных типовых элементов замены в открытом акционерном обществе завод "Красное знамя", г. Рязань	<u>800</u> 400					<u>240</u> 120	<u>200</u> 100	<u>180</u> 90	<u>180</u> 90	<u>2012 -</u> 2015	изготовление унифициро- ванных твердотельных высокочастот- ных типовых элементов замены для локационных систем различного применения, перспективных средств связи и управления воздушным движением,

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			
190. Техническое перевооружение и реконструкция специализированного производства унифицированных рабочих мест операторов информационных систем в открытом акционерном обществе "Уральское производственное предприятие "Вектор", г. Екатеринбург	960 480*					260 130	240 120	230 115	2012 - 2015	3300	увеличение объема производства типовых элементов замены на ** 50 процентов увеличение выпуска унифицированных автоматизированных рабочих мест операторов информационных и специального назначения управляющих систем в ** 1,7 раза
191. Реконструкция и техническое перевооружение для создания регионального	883,70 441,85*					797,62 398,81	86,08 43,04		2012 - 2013	1290	внедрение современных технологий с соответствующим пере

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			
контрактного производства унифицированных электронных модулей в открытом акционерном обществе "Концерн "Созвездие", г. Воронеж											оснащением высокопроиз- водительным оборудованием для организации контрактного производства**
192. Создание лабораторной, технологической и производ- ственной базы для обеспечения разработки, производства и испытаний нового поколения телекоммуникаци онных систем и комплексов в открытом акционерном обществе "Концерн "Созвездие", г. Воронеж	2060 1030*					640 320	560 280	430 215	430 215	2012 - 2015	создание конкуренто- способной продукции мирового уровня, освоение технологий двойного назначения, увеличение объема выпуска изделий до 2 - 2,5 млрд. рублей в год**

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			
193. Открытое акционерное общество "Калужский электромеханичес- кий завод", г. Калуга											
Реконструкция и техническое первооружение производственно- технологической и лабораторно- испытательной базы на федеральном государственном унитарном предприятии "Калужский электромехани- ческий завод", г. Калуга	<u>194,6</u> 97,3*					<u>194,6</u> 97,3			2012	620	создание мощностей по изготовлению спецтехники нового поколения, обеспечива- ющей защиту специальной информации в информа- ционно- коммуника- ционных ** системах
194. Техническое первооружение производства перспективных коротковолновых радиостанций	<u>570</u> 285*				<u>110</u> 55	<u>460</u> 230			2011 - 2012	3156	увеличение объема выпуска продукции в 1,3 - 1,5 раза, повышение

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год				2015 год
в открытом акционерном обществе "Тамбовский завод "Октябрь", г. Тамбов											качества и конкуренто- способности продукции**	
195. Реконструкция и техническое первооружение производства наземной аппаратуры подвижной связи в открытом акционерном обществе "Тамбовский завод	<u>350</u> 175*					<u>90</u> 45	<u>80</u> 40	<u>90</u> 45	<u>90</u> 45	2012 - 2015	1390	модернизация производства и внедрение современной технологии с соответству- ющим пере- оснащением высокопроиз- водительного оборудования
"Революционный труд", г. Тамбов												
196. Техническое первооружение производственно- технологической и лабораторно- испытательной базы в открытом акционерном обществе	<u>573,08</u> 286,54*				<u>200</u> 100	<u>280</u> 140	<u>93,08</u> 46,54			2011 - 2013	2332,2	ускорение и повышение качества разработки мультисервис- ных сетей ведомственной и профессио- нальной связи,

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			
"Воронежский научно- исследовательский институт "Вега", г. Воронеж											ожидаемый экономический эффект 3 млрд. рублей**
197. Техническое переворужение лабораторной и производственно- технологической базы нового поколения узлов связи в открытом акционерном обществе "Тамбовский научно- исследовательский институт радиотехники "Эфир", г. Тамбов	$\frac{220}{110}^*$				$\frac{220}{110}$				2011	7500	ускорение и повышение качества разработки перспективных программно реализуемых сетей радиосвязи и серии унифициро- ванных электронных модулей для построения указанных сетей**
198. Техническое переворужение производства открытого акционерного общества "Российская электроника", г. Москва	$\frac{915,4}{457,7}^*$				$\frac{325}{162,5}$	$\frac{360}{180}$	$\frac{124,32}{62,16}$	$\frac{106,08}{53,04}$	2012 - 2015	1511,3	создание новых произ- водственных мощностей для выпуска перспективной номенклатуры резисторов, в том числе чип-

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			
199. Техническое переворужение с целью создания промышленного производства сложнофунк- циональных сверхвысоко- частотных комплексиро- ванных устройств, электронных модулей и блоков бортовой аппаратуры на федеральном государственном унигарном предприятии "Научно- производственное предприятие "Исток", г. Фрязино, Московская область	<u>720</u> 360*								720 360*	2015 1000***	резисторов в объеме 1 млрд. рублей в год производ- ственный комплекс по серийному выпуску сложнофунк- циональных сверхвысоко- частотных комплексиро- ванных устройств, электронных модулей и блоков бортовой аппаратуры, включая синтезаторы частот, приемо- передающие моноблоки, комплексиро- ванные приемно- усилительные,

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			
200. Техническое перевооружение с целью создания производства новых электровакуумных приборов в открытом акционерном обществе "Научно-производственное предприятие "Контакт", г. Саратов	$\frac{161,5}{136,5^*}$	$\frac{91,5}{76,5}$	$\frac{70}{60}$						2009 - 2010	2786	увеличение объемов производства в 1,5 раза мощностью 4327 штук в год
201. Техническое перевооружение и реконструкция производства по выпуску	$\frac{178,375}{150^*}$	$\frac{50,200}{50}$	$\frac{70,675}{50}$	$\frac{57,5}{50}$					2008 - 2010	2015	обеспечение увеличения объема выпуска продукции до

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			
электровакуумных приборов сверхвысоко- частотного диапазона и специального технологического оборудования в открытом акционерном обществе "Владьинский механический завод", г. Москва											0,8 - 1,2 млрд. рублей в год, увеличения ресурса изделий, создания новых приборов мощностью 706 штук в год
202. Техническое перевооружение для создания сборочного производства электронных модулей с использованием новейшей электронной базы на федеральном государственном унитарном предприятии "Электромеха- нический завод	<u>778,62</u> 389,31*					<u>662,38</u> 331,19	<u>116,24</u> 58,12		2012 - 2013	3081,3	создание сборочного производства с использованием микромини- агурной элементной базы, в том числе микропро- цессоров и матриц BGA**

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год				2015 год
"Звезда", г. Сергиев Посад, Московская область												
203. Открытое акционерное общество "Калужский завод телеграфной аппаратуры", г. Калуга												
Реконструкция и техническое первооружение с целью создания контрактного производства электронных модулей на федеральном государственном унитарном предприятии "Калужский завод телеграфной аппаратуры", г. Калуга	$\frac{420}{210^*}$				$\frac{140}{70}$	$\frac{100}{50}$	$\frac{90}{45}$	$\frac{90}{45}$	2012 - 2015	2156	увеличение объема выпуска продукции до 520 млн. рублей в год	**

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе								Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015			
		год	год	год	год	год	год	год	год			
204. Открытое акционерное общество "Таганрогский научно- исследователь- ский институт связи", г. Таганрог, Ростовская область												
Техническое переворужение и реконструкция производства и приборно- измерительной базы на федеральном государственном унитарном предприятии "Таганрогский научно-исследо- вательский институт связи", г. Таганрог, Ростовская область	<u>302</u> 151*				<u>80</u> 40	<u>70</u> 35	<u>76</u> 38	<u>76</u> 38	<u>76</u> 38	2012 - 2015	1560	внедрение современных технологий, создание комплекса для проведения контроля технологиче- ских параметров и испытаний. Увеличение объема выпуска продукции в 1,5 раза

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			
205. Техническое перевооружение и реконструкция производства испытательной базы нового поколения пьезоэлектрических генераторов, фильтров, резонаторов в открытом акционерном обществе "Завод "Метеор", г. Волжский, Волгоградская область	280,24 140,12*					155 77,5	125,24 62,62		2012 - 2013	3086	производство полного функционального ряда массовых отечественных микроминиатюрных пьезоэлектрических генераторов, фильтров, резонаторов. Увеличение объема выпуска продукции до 230 - 250 млн. ^{**} рублей в год
206. Реконструкция и техническое перевооружение научно-производственной и лабораторной базы в открытом акционерном обществе "Научно-производственное	400 200*					120 60	120 60	80 40	2012 - 2015	2080,5	расширение производственных площадей выпуска приемопередающих модулей на 2080,5 кв.м ^{**}

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год				2015 год
объединение "Радиоэлектроника" имени В.И.Шимко", г. Казань, Республика Татарстан												
207. Открытое акционерное общество "Нижегородское научно-производственное объединение имени М.В.Фрунзе", г. Нижний Новгород	400 200*					120 60	120 60	80 40	80 40	2012 - 2015	1927	организация контрактной сборки массовой продукции, увеличение объема производства контрактной продукции в 1,8 раза

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			
предприятия "Нижегородское научно- производственное объединение имени М.В.Фрунзе", г. Нижний Новгород											
208. Техническое переворужение с целью создания контрактного производства унифицированных электронных модулей на федеральном государственном унитарном предприятии "Омское производственное объединение "Иртыш", г. Омск	<u>214,453</u> 150*	<u>79</u> 60	<u>135,453</u> 90						2008 - 2009	2300	организация контрактной сборки массовой продукции, увеличение объема производства контрактной продукции** в 2,5 раза
209. Техническое переворужение с целью создания промышленного	<u>300</u> 150*	<u>90,24</u> 45,12	<u>134,76</u> 67,38	<u>75</u> 37,5					2013 - 2015	1100***	производствен- ный комплекс по серийному выпуску

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			
<p>производства многоканальных высоковольтных и низковольтных сильноточных источников вторичного электропитания и модуляторов СВЧ сигналов с высокой плотно- стью компоновки электронных компонентов для бортовой аппаратуры на федеральном государственном унитарном пред- приятии "Научно- производственное предприятие "Исток", г. Фрязино, Московская область</p>											<p>многоканаль- ных высоко- вольтных (ВВИП), низковольтных (НВИП) сильноточных источников вторичного электропитания и модуляторов СВЧ сигналов с высокой плотностью компоновки электронных компонентов для бортовой аппаратуры с объемом производства до 500 комплектов блоков в год</p>

210. Открытое
акционерное
общество
"Пензенское

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год				2015 год
производственное объединение "Электроприбор", г. Пенза												
Техническое переворужение с целью создания контрактного производства по изготовлению печатных плат выше 5-го класса точности и унифицированных электронных модулей на федеральном государственном унитарном предприятии "Пензенское производственное объединение "Электроприбор", г. Пенза	<u>1000</u> 500*					<u>380,52</u> 190,26	<u>280</u> 140	<u>169,74</u> 84,87	<u>169,74</u> 84,87	2012 - 2015	5990	обеспечение изготовления печатных плат с новыми финишными покрытиями до 2000 кв. м в год; обеспечение изготовления унифициро- ванных электронных модулей на печатных платах в количестве до 400 тыс. штук в год**

211. Открытое
акционерное
общество
"Федеральный

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			
научно-производ- ственный центр "Нижегородский научно- исследовательский приборостроитель- ный институт "Кварц" имени А.П.Горшкова", г. Нижний Новгород	594,16 297,08*					280 140	74,16 37,08	120 60	2012 - 2015	2731,3	внедрение современной технологии с соответствующим переездом высокопроиз- водительным оборудованием. Увеличение объема выпуска продукции в 1,5 раза**
Техническое переворужение и реконструкция производства электронных сверхвысоко- частотных модулей на федеральном государственном унитарном предприятии "Нижегородский научно- исследовательский приборостроитель ный институт "Кварц", г. Нижний Новгород											

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год				2015 год
212. Открытое акционерное общество "Концерн "Автоматика", г. Москва												
Техническое переворужение и реконструкция производства систем, комплексов и средств защиты информации на федеральном государственном унитарном предприятии "Научно- исследовательский институт автоматики", г. Москва	<u>510</u> 255*					210 105	<u>160</u> 80	70 35	70 35	2012 - 2015	1963,26	обеспечение разработки, производства и аттестации средств комплексов и систем защиты информации. Увеличение объема выпуска продукции до 0,8 - 1,2 млрд. рублей**
213. Открытое акционерное общество "Всероссийский научно- исследовательский												

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год				2015 год
институт "Градиент", г. Ростов-на-Дону												
Техническое переворужение и реконструкция регионального производства базовых несущих конструкций (БНК) на федеральном государственном унитарном предприятии "Всероссийский научно- исследовательский институт "Градиент", г. Ростов-на-Дону	300 150*					80 40	70 35	75 37,5	75 37,5	2012 - 2015	909	обеспечение потребности организаций в базовых несущих конструкциях для всех видов радиоэлектрон- ной аппаратуры. Увеличение объема выпуска продукции в 2 раза**
214. Открытое акционерное общество "Ордена Трудового Красного Знамени научно- исследовательский институт												

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе								Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год			
автоматической аппаратуры им. академика В.С.Семеновича", г. Москва												
Реконструкция и техническое переворужение производственно- технологической и лабораторно- испытательной базы для создания комплексов средств автоматизации информационно- управляющих систем на федеральном государственном университетском предприятии "Орден Трудового Красного Знамени научно- исследовательский институт автоматической аппаратуры	<u>360</u> 180*					<u>90</u> 45	<u>90</u> 45	<u>90</u> 45	<u>90</u> 45	2012 - 2015	1060	обеспечение разработки, производства и аттестации комплексов средств автоматизации информацион- но-управляю- щих систем. Увеличение объема выпуска продукции до 0,52 млрд. рублей

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год				2015 год
им. академика В.С.Семенихина", г. Москва												
215. Открытое акционерное общество "Калугаприбор", г. Калуга	<u>300</u> 150*					<u>80</u> 40	<u>70</u> 35	<u>75</u> 37,5	<u>75</u> 37,5	2012 - 2015	5400	организация контрактной сборки массовой продукции, увеличение объема производства контрактной продукции в 1,8 раза
216. Техническое переворужение с целью создания контрактного производства унифицированных	<u>300</u> 150*					<u>80</u> 40	<u>70</u> 35	<u>75</u> 37,5	<u>75</u> 37,5	2012 - 2015	1100	организация контрактной сборки массовой продукции, увеличение

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год				2015 год
электронных модулей на федеральном государственном университетском предприятии "Ростовский-на- Дону научно- исследовательский институт радиосвязи", г. Ростов-на-Дону											объема производства контрактной продукции в 1,7 раза	
217. Открытое акционерное общество "Ордена Трудового Красного Знамени научно- исследовательский институт автоматической аппаратуры им. академика В.С.Семенихина", г. Москва	300 150*											
Техническое перевооружение с целью создания контрактного						80	70	75	75	2012 - 2015	1060	организация контрактной сборки массовой

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год				2015 год
производства унифицированных электронных модулей на федеральном государственном унигарном предприятии "Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследова- тельский институт автоматической аппаратуры им. академика В.С.Семенихина", г. Москва											производства контрактной продукции в 2,5 раза увеличение объема	
218. Техническое переворужение с целью создания контрактного производства унифицированных электронных модулей в открытом акционерном обществе "Курский завод "Маяк", г. Курск	$\frac{300}{150}^*$					$\frac{70}{35}$	$\frac{90}{45}$	$\frac{70}{35}$	$\frac{70}{35}$	2012 - 2015	2490,5	организация контрактной сборки массовой продукции, увеличение объема производства контрактной продукции в 2,5 раза

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			
219. Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Полус" им. М.Ф.Стельмаха", г. Москва	400 200*					100 50	200 100	50 25	2012 - 2015	2411	организация контрактной сборки массовой продукции, увеличение объема производства контрактной продукции в 1,8 раза**
220. Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт телевидения", г. Санкт-Петербург											

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			
Техническое перевооружение с целью создания контрактного производства унифицированных электронных модулей на федеральном государственном унитарном предприятии "Научно-исследовательский институт телевидения", г. Санкт-Петербург	<u>300</u> 150*					<u>100</u> 50	<u>100</u> 50	<u>50</u> 25	2012 - 2015	1210	организация контрактной сборки массовой продукции, увеличение объема производства контрактной продукции** в 1,7 раза
221. Техническое перевооружение с целью создания мощностей по выпуску источников вторичного электропитания в открытом акционерном обществе "Специальное конструкторско-	<u>224,2</u> 112,1*					<u>120</u> 60	<u>104,2</u> 52,1		2012 - 2013	1282	увеличение объема производства** в 1,5 раза

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе								Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год			
технологическое бюро по релейной технике", г. Великий Новгород												
222. Открытое акционерное общество "Брянский электромехани- ческий завод", г. Брянск												
Реконструкция и техническое переворужение производства и испытательной базы широкополосных сверхвысоко- частотных устройств на федеральном государственном унитарном предприятии "Брянский электромехани- ческий завод", г. Брянск	<u>400</u> 200*				<u>100</u> 50	<u>140</u> 70	<u>80</u> 40	<u>80</u> 40	<u>80</u> 40	2012 - 2015	9586,6	увеличение объема производства радиоэлектрон- ных изделий на 170 млн. рублей**

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год			
223. Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро по радиоконтролю систем управления, навигации и связи", г. Ростов-на-Дону										
Техническое первооружение и реконструкция производственно- испытательных мощностей на федеральном государственном унитарном предприятии "Государственное конструкторское бюро аппаратно- программных средств "Связь", г. Ростов-на-Дону	$\frac{100}{50}^*$					$\frac{100}{50}$	2012	1035	увеличение объема выпуска продукции на 100 млн. рублей, освоение серийного производства изделий "Орион-3М", "Орион-3СМ", "Анализ", "Страж-ПМ" и других	

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты			
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год				2015 год		
224. Техническое перевооружение научно-технического и производственного комплексов по выпуску электровакуумных приборов сверхвысоко-частотного диапазона в открытом акционерном обществе "Российская электроника", г. Москва	<u>800</u> 400*								240 120	380 190	180 90	2013 - 2015	2285***	увеличение объема выпуска продукции до 1,6 млрд. рублей в год в открытом акционерном обществе "Владькинский механический завод", снижение себестоимости** продукции
225. Техническое перевооружение и реконструкция регионального производства базовых несущих конструкций на федеральном государственном унитарном предприятии "Научно-	<u>178,61</u> 169,8*	<u>102,6</u> 100	<u>76,01</u> 69,8									2008 - 2009	2010	увеличение объема выпуска продукции** в 2 раза

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год				2015 год
производственное предприятие "Полет", г. Нижний Новгород												
226. Техническое переворужение производственной и лабораторно- испытательной базы для выпуска нового поколения электрических соединителей в открытом акционерном обществе "Карачевский завод "Электродеталь", г. Карачев, Брянская область	$\frac{480}{240^*}$						$\frac{380}{190}$	$\frac{50}{25}$	$\frac{50}{25}$	2013 - 2015	2628,6 ^{***}	обеспечение выпуска конкуренто- способных высокотехно- логических электрических соединителей нового поколения. Увеличение объемов производства соединителей общепро- мышленного назначения в натуральном выражении до 2000000 штук ^{**} в год
227. Техническое переворужение испытательного	$\frac{373,66}{186,83^*}$					$\frac{200}{100}$	$\frac{173,66}{86,83}$			2012 - 2013	1145	увеличение объема производства

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			
центра для обеспечения комплекса работ по корпусирова- нию и испытаниям сложно- функциональных интегральных схем в открытом акционерном обществе "Российский научно- исследовательский институт "Электрон- стандарт", г. Санкт- Петербург											изделий до 1,9 млн. штук и 650 млн. рублей**
228. Реконструкция и техническое первооружение научно- технического комплекса по разработке и производству ВЧ и СВЧ акустоэлектронных и пьезокварцевых	<u>700</u> 350*					<u>220</u> 110	<u>240</u> 120	<u>240</u> 120	2013 - 2015	550***	увеличение объема выпуска продукции на 2 млрд. рублей**

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			
устройств в открытом акционерном обществе "Омский научно- исследовательский институт приборостроения", г. Омск											
229. Реконструкция и техническое переворужение производственно- технологической и лабораторно- испытательной базы на федеральном государственном унитарном предприятии "Научно-исследо- вательский институт "Экран", г. Самара	<u>557,6</u> 403*	<u>113,5</u> 110	<u>108,4</u> 88	<u>115,7</u> 95	<u>220</u> 110				2008 - 2011	879	создание конкуренто- способных изделий мирового уровня. Разработка технологий двойного назначения. Увеличение объема производства в 1,5 раза**
230. Открытое акционерное общество "Омский научно-											

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год				2015 год
исследовательский институт приборостроения", г. Омск												
Реконструкция и техническое перевооружение производственно-технологической и лабораторной базы для комплексов специальной радиосвязи и управления на федеральном государственном унитарном предприятии "Омский научно-исследовательский институт приборостроения", г. Омск	<u>694,52</u> 349,91*			<u>15,5</u> 10,4	<u>79,2</u> 39,6	<u>300</u> 150	<u>119,82</u> 59,91	<u>90</u> 45	<u>90</u> 45	2010 - 2015	1300	создание комплексов конкуренто-способной аппаратуры специальной радиосвязи и управления. Увеличение объема выпуска продукции в 1,5 раза
231. Техническое перевооружение предприятия для создания производства перспективного вакуумного	<u>280</u> 140*						<u>140</u> 70	<u>70</u> 35	<u>70</u> 35	2013- 2015	900***	создание производства перспективного вакуумного оборудования

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			
базы по созданию модернизированной идентификации на федеральном государственном унитарном предприятии "Пензенское производственное объединение электронной вычислительной техники", г. Пенза	594,16 297,08*					280	74,16	120	2012 - 2015	1365,3	создание метрологичес- кой, испытательной базы для разработки и производства контрольно- измерительной аппаратуры миллиметро- вого диапазона длин волн. Увеличение объема производства
233. Открытое акционерное общество "Федеральный научно- производствен- ный центр "Нижегородский научно- исследователь- ский приборо- строительный институт "Кварц" имени А.П.Горшкова", г. Нижний						140	37,08	60			

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			
Новгород Техническое переворужение и реконструкция метрологической, испытательной базы и производства оптических изделий на федеральном государственном унитарном предприятии "Нижегородский научно- исследователь- ский приборо- строительный институт "Кварц", г. Нижний Новгород											квантовых рубидиевых стандартов частоты в *** 3 раза
234. Техническое переворужение и реконструкция стендовой и испытательной базы сложных радио- электронных	190 95*					100 50****	90 45		2012 - 2013	362	создание сверхшироко- полосных измерительных комплексов для измерения параметров одиночных

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			
систем и комплексов в открытом акционерном обществе "Производственное объединение "Азимут", г. Махачкала, Республика Дагестан											антенн и линейных, плоских и объемных решеток систем навигации, посадки и радиолокации в ближней и дальней зонах (до 1000 м) и модернизация существующей в организации испытательной базы для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
235. Техническое перевооружение производственно-технологической и лабораторно-испытательной базы в открытом акционерном	570 285*					210 105	120 60	120 60	2012 - 2015	2000	увеличение объема выпуска продукции до 3 - 3,5 млрд. ** рублей в год

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			
обществе "Научно-исследо- вательский институт полупроводни- ковых приборов", г. Томск											
236. Открытое акционерное общество "Научно- производственное предприятие "Салют", г. Нижний Новгород											
Техническое первооружение и реконструкция производства сверхвысокочас- отной техники на федеральном государственном унитарном предприятии "Научно- производственное предприятие	<u>1014,14</u> <u>507,07*</u>					<u>640</u> 320	<u>374,14</u> <u>187,07</u>		2012 - 2013	2087,41	увеличение объема производства монолитно- интегральных и гибридно- монолитных приборов и электронных компонентов (в том числе импорто- замещающих)

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			
"Салют", г. Нижний Новгород											до 250 тыс. штук в год, электро- вакуумных и вакуумно- твердотельных модулей (в том числе на основе микроминиа- тюрных ламп бегущей волны) до 1 тыс. шт. в год, унифициро- ванных приемо- передающих модулей (в диапазоне частот 20 - 150 ГГц) до 1,5 тыс. штук в год
237. Реконструкция и техническое первооружение для выпуска теплоотводящих	$\frac{224}{112}^*$					$\frac{120}{60}^{***}$	$\frac{104}{52}$		2012 - 2013	2752	увеличение объема выпуска продукции до 761,5 млн.

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			
керамических подложек для твердотельных сверхвысокочас- тотных устройств и IGBT-модулей в открытом акционерном обществе "Холдингвая компания "Новосибирский электровакуум- ный завод - Союз", г. Новосибирск											рублей в год. Серийный выпуск электронных компонентов, керамических подложек, керамических корпусов, обеспечи- вающих увеличение объемов производства в различных отраслях промышлен- ности, сверхвысоко- частотной техники и силовой полупровод- никовой электроники**
238. Техническое переворужение и реконструкция опытного приборного производства в	<u>610,50</u> 305,25*					<u>400</u> 200	<u>90,5</u> 45,25	<u>120</u> 60	2012 - 2014	2032,5	реконструкция опытного производства с учетом реализации новых

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			
открытом акционерном обществе "Концерн "Океанприбор", г. Санкт- Петербург											технологий по изготовлению интегральных сборок, датчиков на пьезоопленках и других
239. Реконструкция и техническое первооружение организации для совершенствования судовой электротехнической продукции в Федеральном научно- производственном центре открытом акционерном обществе "Научно- производственное объединение "Марс", г. Ульяновск	832 416*					200 100	240 120	196 98	196 98	2012 - 2015	комплексное дооснащение базовых технологий производства электронных средств вычислитель- ной техники с целью импорто- замещения и повышения конкурентоспо- собности; создание эксперимен- тально- лабораторного комплекса для проведения контроля технологии-

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе								Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год			
240. Реконструкция и техническое первооружение опытно- эксперименталь- ного производства модулей функциональной микроэлектро- ники в открытом акционерном обществе "Концерн "Гранит- Электрон", г. Санкт- Петербург	240 120*					80 40	60 30	50 25	50 25	2012 - 2015	800	ческих параметров** и испытаний техническое первооруже- ние обеспечит: внедрение современных технологий производства модулей функциональ- ной микроэлектро- ники; рост объема производства функциональ- ных модулей в 2 - 2,5 раза; расширение номенклатуры без существенных зазрат на подготовку производства; промышленное освоение технологий

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год				2015 год
241. Создание производствен- ного комплекса для массового производства компонентов инерциальных микромеханичес- ких датчиков двойного назначения в открытом акционерном обществе "Концерн "Центральный научно- исследователь- ский институт "Электроприбор", г. Санкт- Петербург	<u>1100</u> 550*					<u>280</u> 140	<u>270</u> 135	<u>275</u> 137,5	<u>275</u> 137,5	2012 - 2015	3250	влагозащиты и электро- изоляции модулей** создание участков по производству кремниевых датчиков, многослойных плат, сборке и корпуси- рованию инерциальных микромехани- ческих** изделий
242. Реконструкция инженерно- испытательного	<u>620</u> 310*					<u>160</u> 80	<u>260</u> 130	<u>100</u> 50	<u>100</u> 50	2012 - 2015	2065	внедрение современных базовых

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе								Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год			
корпуса в открытом акционерном обществе "Концерн "Гранит- Электрон", г. Санкт- Петербург												технологий производства электронных модулей цифровой и цифроаналого- вой вычислитель- ной техники; обеспечение разработки и производства базовых унифициро- ванных электронных модулей. Увеличение объема поставок до 10000 штук в ** год
243. Техническое перевооружение производственно- технологического комплекса по созданию оптико- электронной компонентной	460 230*					80 40	70 35	155 77,5	155 77,5	2012- 2015	3272	создание новой оптической элементной базы перспективных оптико- электронных систем,

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты				
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год				2015 год			
унитарного предприятия "Научно- производственная корпорация "Государствен- ный оптический институт имени С.И.Вавилова", г. Санкт- Петербург											новых видов оптико- электронных систем, обеспечиваю- щих предельно возможные технические параметры изделий				
245. Открытое акционерное общество "НПО "Орион", г. Москва															
Реконструкция корпуса 2Ж для создания лабораторно- аналитического центра инфракрасной фото- и оптоэлектроники на федеральном государственном унитарном предприятии "НПО "Орион", г. Москва	<u>700</u> 350*								<u>180</u> 90	<u>160</u> 80	<u>180</u> 90	<u>180</u> 90	2012- 2015	900	создание единого аналитичес- кого центра по исследованиям и сертификации важнейших материалов и компонентов инфракрасной фотоэлектро- ники

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе								Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год			
246. Открытое акционерное общество "НПО "Орион", г. Москва												
Техническое переворужение производственно- технологического комплекса по созданию оптоэлектронной компонентной базы на федеральном государственном унитарном предприятии "НПО "Орион", г. Москва	<u>3681</u> 1840,5*					<u>1280</u> 640	<u>261</u> 130,5	<u>930</u> 465	<u>1210</u> 605	2012 - 2015	8960	создание производст- венно-техноло- гического комплекса, который обеспечит промышлен- ный выпуск изделий компонентной базы 2-го и 3-го поколений и оптико- электронных систем на их основе с пара- метрами, пре- вышающими современный, и прогнозиру- емый мировой уровень**

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе								Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год				
247. Реконструкция и техническое первооружение стендово- эксперименталь- ной базы в открытом акционерном обществе "Научно- исследователь- ский институт авиационного оборудования", г. Жуковский, Московская область	$\frac{420}{210^*}$					$\frac{70}{35}$	$\frac{60}{30}$	$\frac{145}{72,5}$	$\frac{145}{72,5}$	$\frac{145}{72,5}$	2012- 2015	1500	обеспечение возможности проведения испытаний опытных образцов источников электро- энергии, статических преобразова- телей и аппаратуры защиты и коммутации для проекта "Долностью электрический самолет"***
248. Реконструкция и техническое первооружение производственной базы, освоение инновационных технологий для изготовления радиоэлектрон- ных изделий авиационной	$\frac{520}{260^*}$							$\frac{164}{82}$	$\frac{130}{65}$	$\frac{226}{113}$	2013- 2015	9000***	изготовление конкуренто- способных изделий авиационной техники, соответст- вующих современным и перспектив- ным

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год				2015 год
техники с использованием новых уровней технологий в открытом акционерном обществе "Научно-исследовательский институт авиационного оборудования", г. Жуковский, Московская область											международным стандартам	
249. Реконструкция и техническое перевооружение экспериментально-технологической базы для производства микроэлектронных изделий в открытом акционерном обществе "Казанское приборостроительное	370,08 185,04*					100 50	54,08 27,04	123 61,5	93 46,5	2012 - 2015	1556,8	создание производственных мощностей по производству современной микро-электронной аппаратуры

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год				2015 год
конструкторское бюро", г. Казань, Республика Татарстан												
250. Реконструкция и техническое переворужение цеха по производству первичных преобразователей и вторичной аппаратуры в открытом акционерном обществе "Казанское приборо- строительное конструкторское бюро", г. Казань, Республика Татарстан	$\frac{222,12}{111,06^*}$					$\frac{100}{50}$	$\frac{42,12}{21,06}$	$\frac{60}{30}$	$\frac{20}{10}$	2012 - 2015	2040,8	производство конкуренто- способной продукции, обладающей современными показателями по надежности, быстро- действию и массогабарит- ным характеристи- кам
251. Реконструкция и техническое переворужение производства электронных систем	$\frac{458}{229^*}$						$\frac{150}{75}$	$\frac{154}{77}$	$\frac{154}{77}$	2013 - 2015	1350 ^{***}	серийное производство широкой номенклатуры статических преобразова-

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			
самолетного энергоснабжения в открытом акционерном обществе "Агрегатное конструкторское бюро "Якорь", г. Москва											телей напряжения авиационных перспективных объектов (проект "полностью электрический самолет", истребитель 5-го поколения, программа развития гражданской авиационной техники)**
252. Реконструкция и техническое переворужение для создания электронного полигона по исследованиям, отработке и сертификации бортового авиационного радиоэлектрон- ного	$\frac{1070}{535^*}$	$\frac{260}{130}$	$\frac{265}{132,5}$	$\frac{545}{272,5}$	2013 - 2015	2700***	полигон позволит проводить работы с радио- электронной аппаратурой в условиях реального полета с учетом информацион- ного взаимо-				

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты			
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год				2015 год		
оборудования в открытом акционерном обществе "Летно- исследователь- ский институт имени М.М.Громова", г. Жуковский, Московская область											действия с наземными и самолетными системами обеспечения воздушного движения в реальных условиях естественных и промышлен- ных помех			
253. Техническое переворужение с целью создания производствен- ного участка настройки быстродействи- ющих бортовых цифровых устройств с тактовой частотой более 500 МГц в открытом акционерном обществе "Ставропольский радиозавод "Сигнал", г. Ставрополь	<u>300</u> 150*								<u>100</u> 50	<u>100</u> 50	<u>100</u> 50	2013 - 2015	1300 ***	создание производст- венного участка настройки быстро- действующих бортовых цифровых устройств с тактовой частотой более 500 МГц

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе								Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год			
254. Техническое переворужение с целью создания лабораторно- испытательной базы для изготовления и испытаний сверхшироко- полосных СВЧ- устройств сантиметрового диапазона с перекрытием по частоте более 3 октав в открытом акционерном обществе "Ставропольский радиозавод "Сигнал", г. Ставрополь	$\frac{380}{190^*}$					$\frac{150}{75}$	$\frac{115}{57,5}$	$\frac{115}{57,5}$	$\frac{115}{57,5}$	2013 - 2015	1785 ^{***}	создание лабораторно- испытательной базы для изготовления и испытаний сверхшироко- полосных СВЧ-устройств сантиметро- вого диапазона с перекрытием по частоте более 3 октав ^{**}
255. Реконструкция и техническое переворужение производства специализирован- ных цифровых вычислительных	$\frac{1040}{520^*}$					$\frac{240}{120}$	$\frac{270}{135}$	$\frac{270}{135}$	$\frac{530}{265}$	2013 - 2015	5000 ^{***}	освоение технологии производства перспективных многопроцес- сорных специализиро-

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			
машин в открытом акционерном обществе "Государствен- ный Рязанский приборный завод", г. Рязань											ванных цифровых вычислитель- ных машин, построенных на основе архитектуры единой коммутируе- мой вычислитель- ной среды, с использовани- ем принципов Интегральной Модульной Авионики (ИМА) второго поколения, ориентирован- ных на обеспечение принципиаль- но нового уровня надежности и универсаль- ности комплекса аппаратуры ^{**} авионики

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год				2015 год
256. Реконструкция и техническое переворужение участков монтажа электронных систем и электронно- оптических модулей на федеральном государственном унитарном предприятии "Санкт- Петербургское опытно- конструкторское бюро "Электро- автоматика" имени П.А.Ефимова", г. Санкт- Петербург	$\frac{296}{148}^*$						$\frac{160}{80}$	$\frac{68}{34}$	$\frac{68}{34}$	2013 - 2015	800 ^{***}	ввод в эксплуатацию производст- венных линий с высокой степенью автоматизации производства современной авиационной радио- электронной и оптико- электронной аппаратуры для коммерческой и военной ^{**} авиации
257. Техническое переворужение с целью создания производства цифровых плоскопанельных телевизионных	$\frac{258}{129}^*$						$\frac{100}{50}$	$\frac{33}{16,5}$	$\frac{125}{62,5}$	2013 - 2015	4700 ^{***}	выпуск цифровых плоско- панельных телевизион- ных приемников и

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты		
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год				2015 год	
приемников и цифровых телевизионных приставок в открытом акционерном обществе "Электросигнал", г. Дербент, Республика Дагестан											цифровых телевизион- ных приставок		
258. Техническое первооружение участка микро- электроники в открытом акционерном обществе "Научно- производственное предприятие "Радиосвязь", г. Красноярс	<u>320</u> 160								140 70	<u>90</u> 45	2013 - 2015	588***	увеличение объемов производства сверхвысоко- частотной электронной компонентной базы на основе перспектив- ных технологий низко- температур- ной керамики**

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			

2. Реконструкция и техническое перевооружение для создания базовых центров системного проектирования

259. Техническое перевооружение федерального государственного унитарного предприятия "Научно-производственное предприятие "Пульсар", г. Москва, для создания базового центра системного проектирования	$\frac{100}{50^*}$				$\frac{100}{50}$				2011	135,1	создание межотраслевого центра системного проектирования**
260. Реконструкция и техническое перевооружение открытого акционерного общества "Информационные телекоммуникационные технологии", г. Санкт-Петербург, для	$\frac{119,873}{60}$					$\frac{119,873}{60}$			2008	1911	создание базового центра системного проектирования производственнойностью 40 аппаратных программных комплексов в год**

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			
создания базового центра полного цикла проектирования и производства аппаратно- программных комплексов											
261. Техническое перевооружение для создания базового центра системного проектирования микроэлектрон- ных модулей нового поколения на основе технологии "систем в модуле" двойного и специального применения на открытом акционерном обществе "Научно- исследователь- ский институт	<u>120</u> 60*				<u>120</u> 60				2011	1324	обеспечение проектирова- ния, производства, испытаний, контроля, тестирования и сертификации перспективных изделий, включая климатичес- кие, механические, надежностные и другие специализиро- ванные испытания, а также сертификации

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			
"Вектор", г. Санкт- Петербург											выпускаемых изделий по требованиям различных категорий заказчиков и производств**
262. Техническое первооружение открытого акционерного общества "Всероссийский научно- исследователь- ский институт радиотехники", г. Москва, для создания базового центра проектирования	$\frac{50}{25}^*$				$\frac{50}{25}$				2011	422,8	создание базового центра системного проектирова- ния**
263. Техническое первооружение открытого акционерного общества "НИИ молекулярной электроники и завод "Микрон",	$\frac{540}{270}^*$		$\frac{80}{40}$		$\frac{460}{230}$				2010 - 2011	151,3	создание базового центра системного проектирова- ния**

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			
г. Москва, для создания базового центра проектирования											
264. Реконструкция и техническое переворужение федерального государственного унитарного предприятия "Научно- исследователь- ский институт автоматики", г. Москва, для создания базового центра проектирования	$\frac{35,37}{30}$ *	$\frac{35,37}{30}$							2009	493	создание базового центра системного проектирова- ния**
265. Техническое переворужение федерального государственного унитарного предприятия "Научно- производственное предприятие "Восток",	$\frac{140}{70}$ *	$\frac{140}{70}$							2011	599,85	создание базового центра системного проектирова- ния**

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			
г. Новосибирск, для создания базового центра проектирования											
266. Техническое переворужение открытого акционерного общества "Концерн "Созвездие", г. Воронеж, для создания базового центра проектирования	$\frac{182,3}{100^*}$			$\frac{62,3}{40}$	$\frac{120}{60}$				2010 - 2011	700	создание базового центра системного проектирова- ния**
267. Техническое переворужение открытого акционерного общества "Концерн радиостроения "Вега", г. Москва, для создания базового центра проектирования	$\frac{130}{100^*}$			$\frac{130}{100}$					2010	998	создание базового центра системного проектирова- ния площадью 998 кв. м**

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			
268. Реконструкция и техническое первооружение федерального государственного унитарного предприятия "Ростовский-на- Дону научно- исследователь- ский институт радиосвязи", г. Ростов-на- Дону, для создания базового центра проектирования	$\frac{120,6}{60^*}$			$\frac{120,6}{60}$					2010	500	создание базового центра системного проектирова- ния площадью ** 500 кв. м
269. Реконструкция и техническое первооружение действующего предприятия федеральное государственное унитарное предприятие "Омский научно- исследователь- ский институт приборо-	$\frac{17}{17^*}$									500	создание базового центра системного проектирова- ния площадью ** 500 кв. м

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			
строения", г. Омск (развитие базового центра системного проектирования СБИС)											
270. Техническое переворужение открытого акционерного общества "Российский институт радионавигации и времени", г. Санкт- Петербург, для создания базового центра проектирования	$\frac{120}{60}^*$				$\frac{120}{60}$				2011	490	создание базового центра системного проектирова- ния площадью ** 490 кв. м
271. Техническое переворужение с целью создания базового центра проектирования сложно- функциональных	$\frac{232}{116}^*$								2014	$\frac{232}{116}$ 300	базовый центр проектирова- ния сложно- функциональ- ных комплексно- рованных

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			
комплексирован- ных СВЧ- устройств на федеральном государственном университетском предприятии "Научно- производственное предприятие "Исток", г. Фрязино, Московская область											СВЧ-устройств площадью 300 кв. м**
272. Реконструкция и техническое переворужение открытого акционерного общества "Центральный научно-исследо- вательский инсти- тут "Циклон", г. Москва, для создания базового центра проекти- рования	$\frac{80}{80}$ ****			$\frac{80}{80}$ ****						2010	создание базового центра системного проектирова- ния площадью 800 кв. м**

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			
272.1. Техническое перевооружение федерального государственного унитарного предприятия "Государственный завод "Пульсар", г. Москва, для создания базового центра проектирования	<u>200</u> 100				<u>200</u> 100				2011	648	создание базового центра системного проектирования площадью ^{**} 648 кв. м мощностью 360 тыс. штук
273. Реконструкция и техническое перевооружение федерального государственного унитарного предприятия "Научно-исследовательский институт "Аргон", г. Москва, для создания базового центра проектирования	<u>68,9</u> 60*	<u>68,9</u> 60							2008	532	создание базового центра системного проектирования ^{**}

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			
274. Реконструкция и техническое первооружение федерального государственного унитарного предприятия "НПО "Орион", г. Москва, для создания базового центра проектирования	$\frac{30}{15^*}$						$\frac{15}{7,5}$	$\frac{15}{7,5}$	2014 - 2015	500	создание базового центра системного проектирова- ния площадью 500 кв. м**
275. Реконструкция и техническое первооружение федерального государственного унитарного предприятия "Новосибирский завод полупроводнико- вых приборов с ОКБ", г. Новосибирск, для создания базового центра проектирования	$\frac{83,62}{60^*}$	$\frac{83,62}{60}$							2009	500	создание базового центра системного проектирова- ния площадью 500 кв. м**

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			
276. Реконструкция и техническое переворужение федерального государственного унитарного предприятия "Научно- исследователь- ский институт телевидения", г. Санкт- Петербург, для создания базового центра проектирования	$\frac{101,54}{80^*}$							$\frac{101,54}{80}$	2008	600	создание базового центра системного проектирова- ния площадью ** 600 кв. м
277. Техническое переворужение открытого акционерного общества "Концерн "Океанприбор", г. Санкт- Петербург, для создания базового центра проектирования	$\frac{140}{70^*}$							$\frac{140}{70}$	2011	600	создание базового центра системного проектирова- ния площадью ** 600 кв. м

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			
278. Реконструкция и техническое переворужение федерального государственного университета предприятия "Нижегородский научно- исследователь- ский прибор- строительный институт "Кварц", г. Нижний Новгород, для создания базового центра проектирования	<u>75,4</u> 72,7*	<u>75,4</u> 72,7							2008	1097,8	создание базового центра системного проектирова- ния**
279. Техническое переворужение и реконструкция открытого акционерного общества "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение", г. Королев, Московская	<u>104</u> 80*	<u>104</u> 80							2008	650	создание базового центра системного проектирова- ния площадью 650 кв. м**

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			
область, для создания базового центра системного проектирования											
280. Техническое переворужение федерального государственного университетского предприятия "Научно- исследователь- ский институт "Экран", г. Самара, для создания базового центра проектирования	$\frac{240}{120}^*$				$\frac{240}{120}$				2011	1134,5	создание базового центра системного проектирова- ния площадью 1134,5 кв. м мощностью 2000 штук
281. Открытое акционерное общество "Государственный оптический инсти- тут им. С.И.Вави- лова", г. Санкт- Петербург											

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			
Создание базового центра проектирования на базе федерального государственного университетского предприятия "Научно- производственная корпорация "Государствен- ный оптический институт имени С.И.Вавилова", г. Санкт- Петербург	<u>500</u> 250*					<u>290</u> 145	<u>160</u> 80*****	<u>50</u> 25	2012 - 2014	2000	создание базового центра по проектирова- нию, моделирова- нию, изготовлению, тестированию и сертификации перспективных оптических систем и оптико- электронного оборудова- ния
282. Реконструкция и техническое переворужение открытого акционерного общества "Концерн ПВО "Алмаз-Антей", г. Москва, для создания базового центра проектирования	<u>2200</u> 1100*					<u>590</u> 295	<u>520</u> 260	<u>545</u> 272,5	2012- 2015	6800	повышение качества и надежности систем цифровой обработки, систем твердотельных передающих и приемных систем, приемо-

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год				2015 год
систем цифровой обработки, твердотельных передающих и приемных систем, приемо- передающих модулей											передающих модулей активных фазированных системных решеток С-диапазона для перспективных средств связи, управления воздушным движением и формирования сигналов на кристалле для радиолокаци- онных станций различного применения **	
283. Реконструкция и техническое переворужение для создания базового центра проектирования в открытом акционерном обществе	<u>500</u> 250*					<u>192,38</u> 96,19	<u>120</u> 60	<u>93,81</u> 46,905	<u>93,81</u> 46,905	2012- 2015	865,5	создание базового центра проектирова- ния сложных функциональ- ных блоков и сверхбольших интегральных

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			
"Концерн "Созвездие", г. Воронеж											схем типа "система на кристалле" для нового поколения аппаратуры и мобильных телекоммуника- ционных систем; создание конкуренто- способных изделий для нового поколения мобильных телеком- муникацион- ных систем гражданского и двойного назначения
284. Техническое перевооружение для создания базового центра системного проектирования (дизайн-центра)	<u>440</u> 220*										обеспечение производства комплексных средств автоматизации для управления
					<u>440</u> 220				2011	1852	

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			
радиоэлектрон- ных модулей и узлов											автомобиль- ным и
стационарных и мобильных средств											железно- дорожным
автоматизации в открытом											транспортом, объектами
акционерном обществе											топливно- энергетичес-
"Научно- производственное предприятие "Рубин", г. Пенза											кого комплекса **
285. Создание базового центра системного проектирования унифицирован- ных электронных модулей на основе современной электронной компонентной базы в открытом акционерном обществе "Челябинский	200 100*			90 45	110 55					2010 - 2011	обеспечение возможности изготовления разработанных электронных модулей по современным технологиям; повышение надежности и качества и ускорение разработки конкурентосло- собных

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			
радиозавод "Полет", г. Челябинск											изделий мирового уровня; разработка технологий двойного ** назначения
286. Создание базового центра системного проектирования унифицирован- ных электронных модулей на основе современной электронной компонентной базы в открытом акционерном обществе	$\frac{119.7}{100}^*$			$\frac{119.7}{100}$					2010	750	обеспечение возможности изготовления разработанных электронных модулей по современным технологиям; разработка технологий двойного ** назначения мощностью 5 модулей в год
287. Техническое переворужение для создания	$\frac{180}{90}^*$				$\frac{180}{90}$				2011	640	обеспечение проектирова- ния,

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			
ных модулей нового поколения на основе технологии "систем в модуле" двойного и специального применения в открытом акционерном обществе "Московский научно- исследователь- ский институт связи", г. Москва											контроля, тестирования и сертификации перспективных изделий, включая климатичес- кие, механические, надежные и другие специализиро- ванные испытания, а также сертификации выпускаемых изделий по требованиям различных категорий заказчиков и производств
289. Расширение базового центра системного проектирования по проектированию радиоэлектронной	<u>317,56</u> 158,78*					<u>141,4</u> 70,7	<u>100</u> 50	<u>76,16</u> 38,08	2012- 2014	881	расширение возможностей и объемов базового центра системного проектирова-

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			
аппаратуры на базе сверхбольших интегральных схем "система на кристалле" в открытом акционерном обществе "Концерн радиостроения "Вега", г. Москва											ния за счет использования передовых технологий разработки радио- электронных изделий. Ускорение процесса получения готовых проектов не менее чем в 2 раза
290. Техническое перевооружение для создания базового центра системного проектирования высокоплотных электронных узлов на основе технологии многокристал- льных модулей в открытом акционерном обществе	<u>210</u> 105*								<u>210</u> 105	2011	773,5 обеспечение проектирова- ния, производства высоко- плотных электронных узлов на основе технологии много- кристалльных модулей как ключевой технологии

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			
"Научно-исследовательский институт "Кулон", г. Москва											достижения высоких технических характеристик разрабатываемых и производимых изделий. Планируемый объем выпуска многокристалльных модулей до 3,5 тыс. ** штук в год
291. Создание базового центра системного проектирования высокоплотных электронных узлов на основе технологии многокристалльных модулей в открытом акционерном обществе "Конструкторское бюро "Луч",	<u>165,6</u> 105*			<u>45,6</u> 45	<u>120</u> 60				2010 - 2011	350	обеспечение проектирования, производства высокоплотных электронных узлов на основе технологии многокристалльных модулей как ключевой технологии

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год				2015 год
г. Рыбинск, Ярославская область											достижения высоких технических характеристик разрабатываемых и производимых изделий. Планируемый объем выпуска много- кристалльных модулей до ** 3,5 тыс. штук	
292. Техническое первооружение для обеспечения интеграции базовых центров системного проектирования в сквозную корпоративную систему разработки радиоэлектрон- ных комплексов в открытом акционерном обществе	<u>500</u> 250*							<u>210,7</u> 105,35	<u>289,3</u> 144,65	2014- 2015	1650 ***	создание базового центра проектирова- ния и расширение возможностей и объемов разрабатывае- мой номенклатуры изделий за счет тесной интеграции разно- дисциплинар-

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе								Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год			
"Концерн радиостроения "Вега", г. Москва												ных базовых центров системного проектирова- ния радио- электронных изделий, существенное снижение времени и себестоимости комплексных разработок высоко- производи- тельных СБИС, микропроцес- сорной техники, матричных корпусов, в том числе для СБИС с большим количеством выводов, контроллеров перспективных периферийных интерфейсов

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			
293. Техническое перевооружение для создания базового центра проектирования универсальных микропроцес- соров, систем на кристалле, цифровых приборов обработки	450 265*	80 80****	90 45	140 70	140 70	2010- 2014	1530	создание базового центра разработки высоко- производи- тельной микропроцес- сорной техники двойного назначения,	для разработки на их базе перспективных сложно- функциональ- ных блоков, радио- электронной аппаратуры, универсальных цифровых устройств, комплексов, систем и средств связи двойного и гражданского назначения**		

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			
сигналов и других цифровых устройств, комплексов и систем на базе современных лицензионных систем автоматизирован- ного проектирования и технических средств открытого акционерного общества "Институт электронных управляющих машин" им. И.С.Брука, г. Москва											оснащенного современной технологией разработки многоядерных систем на кристалле, матричных корпусов для сверхбольших интегральных схем с большим количеством выводов, контроллеров перспективных периферийных интерфейсов для разработки на их базе высоко- производитель- ных вычислитель- ных систем широкого применения**

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты		
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год				2015 год	
294. Техническое перевооружение и реконструкция базового регионального научно-технологического центра по микро-системотехнике открытого акционерного общества "Омский научный исследовательский институт приборостроения", г. Омск	$\frac{835,62}{417,81^*}$					$\frac{280}{140}$	$\frac{235,62}{117,81}$	$\frac{160}{80}$	$\frac{160}{80}$	$\frac{160}{80}$	2012 - 2015	414,5	ускорение проектирования и отработки технологий производства перспективных устройств микросистемотехники для комплектования аппаратуры управления, средств телекоммуникации и связи, высокопоточного оружия, робототехнических комплексов, мониторинга окружающей среды, зданий и сооружений, систем трубопроводов, водо- и газоснабжения,

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе								Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год			
295. Реконструкция и техническое переворужение центра системного проектирования и производства радиоэлектрон- ных средств спутниковой связи открытого акционерного	<u>490</u> 245*					<u>120</u> 60	<u>160</u> 80	<u>105</u> 52,5	<u>105</u> 52,5	2012 - 2015	1701,8	создание конкуренто- способных изделий мирового уровня двойного назначения для комплексов аппаратуры спутниковой связи

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год			
общества "Научно- производствен- ный центр "Вигстар", г. Москва										
296. Открытое акционерное общество "Научно- производственное предприятие "Алмаз", г. Саратов										
Реконструкция и техническое первооружение на федеральном государственном унитарном предприятии "Научно- производственное предприятие "Алмаз", г. Саратов, с целью создания дизайн-центра и производства	<u>1000,12</u> 500,06*					<u>670</u> 335	<u>330,12</u> 165,06	2012 - 2013	3221,35	создание дизайн-центра площадью 3221,35 кв. м и увеличение выпуска продукции на 500 млн. рублей в год **

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			
сверхвысоко- частотных и силовых устройств											
297. Техническое первооружение для создания центра проектирования перспективной электронной компонентной базы на федеральном государственном университетском предприятии "Научно- исследователь- ский институт электронной техники", г. Воронеж	$\frac{89,1}{45}^*$	$\frac{89,1}{45}$							2008	189	создание конкуренто- способной технологии автоматизиро- ванного проектирова- ния кристаллов сверхбольших интегральных схем и систем на кристалле с проектными нормами 0,18 - 0,13 мкм и степенью интеграции до 100 млн. вентилей на кристалле, что позволит обеспечить ускоренную разработку

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе								Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015			
		год	год	год	год	год	год	год	год			
научно-исследовательский институт "Электронприбор", г. Санкт-Петербург												акустического давления; датчиков угловых перемещений** и других
299. Создание отраслевого центра проектирования сложных функциональных блоков и сверхбольших интегральных схем типа "система на кристалле" в открытом акционерном обществе "Концерн "Моринформ-система-Агат", г. Москва	$\frac{360}{180^*}$					$\frac{90}{45}$	$\frac{135}{67,5}$	$\frac{135}{67,5}$	$\frac{135}{67,5}$	2012 - 2015	609	создание отраслевого центра проектирования (дизайн-центра) сложных функциональных блоков и сверхбольших интегральных схем типа "система на кристалле" для обеспечения новейшей цифровой техникой приборостроительных организаций судостроительной отрасли**

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			
300. Техническое перевооружение базового центра проектирования и производства специальных многокристалльных микросистем и микромодулей с использованием технологии 3D TSV в открытом акционерном обществе "Российская электроника", г. Москва	300 150*					200	100	100	2013 - 2014	600***	создание базового центра проектирования площадью** 600 кв. м
301. Реконструкция и техническое перевооружение для создания базового центра проектирования составных частей, компонентов и приемопередающих модулей РЛС с АФАР в	844 422							280 140	2014 - 2015	6000***	создание базового центра проектирования площадью** 6000 кв. м

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			
открытом акционерном обществе "Корпорация "Фазотрон - Научно- исследователь- ский институт радиостроения", г. Москва											
3. Реконструкция и техническое перевооружение (включая приобретение программно-технических средств) для создания межотраслевого центра проектирования, каталогизации и изготовления фотошаблонов											
302. Реконструкция и техническое перевооружение открытого акционерного общества "Российская электроника", г. Москва (включая приобретение программно- технических средств), с целью создания межотраслевого центра	<u>724,95</u> 590,75*	<u>156</u> 78	<u>404,55</u> 352,75	<u>164,4</u> 160					2008 - 2010	375,5	создание межотраслево- го центра проектирова- ния, каталогизации и изготовления фотошаблонов с объемом производства не менее 1200 штук в год**

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе								Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год			

проектирования,
каталогизации и
изготовления
фотошаблонов

Итого по	<u>70680,25</u>	<u>1618,71</u>	<u>1643,48</u>	<u>2125,3</u>	<u>5740</u>	<u>18466,52</u>	<u>15026,44</u>	<u>12807,68</u>	<u>13252,12</u>			
Минпромторгу России	37021,79	1267,7	1412,71	1695	2870	9233,26	7513,22	6403,84	6626,06			

Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом")

1. Реконструкция и техническое перевооружение действующих радиоэлектронных производств

303. Техническое перевооружение федерального государственного унитарного предприятия федеральный научно- производствен- ный центр "Научно- исследователь- ский институт измерительных систем им. Ю.Е.Седакова", г. Нижний Новгород	<u>196</u> 98*	<u>40</u> 20	<u>48</u> 24	<u>48</u> 24	<u>48</u> 24	<u>60</u> 30	<u>60</u> 30	<u>2010 -</u> 2013	267	создание технологичес- кого комплекса для производства сверхвысоко- частотных монокристаллических интегральных схем на широкозонных полупроводнико- вых материалах**
---	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------------	-----	---

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе								Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год				
304. Техническое переворужение производства сильноточных электронных коммутирующих элементов на федеральном государственном унитарном предприятии "Всероссийский научно- исследователь- ский институт автоматики им. Н.Л.Духова", г. Москва	$\frac{160}{80^*}$						$\frac{60}{30}$	$\frac{50}{25}$	$\frac{50}{25}$	$\frac{50}{25}$	2013 - 2015	616,7***	техническое переворуже- ние произ- водства сильно- точных электронных коммутирую- щих элементов**
305. Техническое переворужение для организации высоко- технологичного производства металлокерами- ческих корпусов микросборок и микросхем на федеральном государственном	$\frac{214}{107^*}$						$\frac{102}{51}$	$\frac{94}{47}$	$\frac{18}{9}$	$\frac{18}{9}$	2013 - 2015	850***	техническое переворуже- ние производства металлокера- мических корпусов микросборок и микросхем

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты			
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год				2015 год		
унитарном предприятии федеральном научно- производствен- ном центре "Производствен- ное объединение "Старт" имени М.В.Проценко", г. Заречный, Пензенская область														
306. Техническое первооружение участков производства коммутирующих элементов нового поколения с лазерным поджигом на федеральном государственном унитарном предприятии "Всероссийский научно- исследователь- ский институт	<u>130</u> <u>65*</u>									<u>50</u> <u>25</u>	<u>80</u> <u>40</u>	2014- 2015	509,3 ^{***}	техническое первооруже- ние участков производства коммутирую- щих элементов нового поколения с лазерным поджигом ^{**}

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			
автоматики им. Н.Л.Духова", г. Москва											
307. Техническое переворужение с целью производства радиационно стойких изделий микроэлектроник и с применением методов нанотехнологий на федеральном государственном унитарном предприятии "Всероссийский научно- исследователь- ский институт автоматики им. Н.Л.Духова", г. Москва	400 200*	<u>100</u> 50	<u>100</u> 50	<u>100</u> 50	<u>100</u> 50	<u>100</u> 50	<u>100</u> 50	<u>100</u> 50	2012- 2015	2148,1	создание производст- венно- технологиче- ского участка изготовления изделий микро- электроники для систем автоматики специзделий**
308. Техническое переворужение с целью производства быстродействующую	<u>350</u> 175*	<u>134</u> 67	<u>104</u> 52	<u>112</u> 56	<u>2013 -</u> 2015	<u>2500</u> ***					создание производст- венно- технологиче- ского участка в

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты				
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год				2015 год			
щих радиационно стойких монолитных интегральных схем на федеральном государственном унитарном предприятии федеральный научно- производствен- ный центр "Научно- исследователь- ский институт измерительных систем им. Ю.Е.Седакова", г. Нижний Новгород											межведомст- венном центре по разработке и производству радиационно стойкой электронной компонентной базы**				
309. Техническое переворужение с целью производства радиационно стойких изделий микро- системотехники на федеральном	<u>536</u> 268*									<u>204</u> 102	<u>158</u> 79	<u>174</u> 87	2013 - 2015	1100***	создание производст- венно- технологичес- кого участка в межведомствен- ном центре по разработке и производству

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			
государственном унитарном предприятии федеральный научно- производствен- ный центр "Научно- исследователь- ский институт измерительных систем им. Ю.Е.Седакова", г. Нижний Новгород										радиационно стойкой электронной компонентной базы**	
310. Техническое первооружение с целью производства радиационно стойких изделий микроэлектро- ники на федеральном государственном унитарном предприятии "Российский федеральный ядерный центр -	1780 890*					232	724	524	2012- 2015	3287	техническое первооруже- ние технологи- ческих участков по изготовлению радиационно стойких изделий микро- электроники в РФЯЦ ВНИИЭФ обеспечит создание

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			
Всероссийский научно- исследователь- ский институт эксперименталь- ной физики", г. Саров, Нижегородская область											"чистых" помещений с высоко- технологич- ным оборудова- нием, что позволит внедрить в производство более 120 новых технологи- ческих процессов по изготовлению принципаль- но новых радиационно стойких высоко- функциональ- ных МЭМС и МСТ приборов автоматики
2. Реконструкция и техническое перевооружение для создания базовых центров системного проектирования											
311. Реконструкция дизайн-центра радиационно- стойкой	200 100*	80 40	68 34	52 26	2976	2008 - 2011	2976			реконструкция дизайн- центра мощностью	

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			
электронной компонентной базы на федеральном государственном унигарном предприятии федеральный научно- производствен- ный центр "Научно- исследователь- ский институт измерительных систем им. Ю.Е.Седакова", г. Нижний Новгород											1 млн. транзисторов в год
312. Техническое первооружение дизайн-центра радиационно стойкой электронной компонентной базы на федеральном государственном унигарном	<u>240</u> 120*					<u>100</u> 50	<u>120</u> 60	<u>20</u> 10	2012 - 2014	506	техническое первооруже- ние дизайн- центра радиационно стойкой электронной компонентной базы позволит обеспечить разработку и

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе								Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год			
<p>предприятия "Всероссийский научно- исследователь- ский институт автоматики им. Н.Л.Духова", г. Москва</p>												<p>автоматизи- рованную верификацию ПЛИС - прототипов разрабатыва- емых СБИС объемом до нескольких десятков тысяч логических элементов, а также верификацию в составе аппаратуры разработанных СБИС объемом от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов эквивалентных вентилей</p>
<p>313. Техническое переворужение дизайн-центра радиационно стойкой</p>	$\frac{120}{60^*}$					$\frac{20}{10}$	$\frac{80}{40}$	$\frac{20}{10}$	2012 - 2014	330	<p>техническое переворуже- ние дизайн- центра позволит</p>	

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе								Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год			
электронной компонентной базы на федеральном государственном унитарном предприятии "Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно- исследователь- ский институт эксперименталь- ной физики", г. Саров, Нижегородская область												создать высоко- технологич- ный кластер по разработке принципиаль- но новых радиационно стойких электронных схем и СБИС на основе современных БМК, АЦ БМК, ПЛИС и ПЗУ большой емкости, что позволит выполнять до 500 логичес- ких проектов в год: а) радиационно- стойких СБИС на основе полузаказных микросхем; б) сложной- функциональ- ных блоков

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год				2015 год
314. Техническое переворужение дизайн-центра радиационно стойкой электронной компонентной базы на федеральном государственном унитарном предприятии "Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно- исследователь- ский институт технической физики имени академика	180 90*					40 20	40 20	40 20	60 30	2012 - 2015	877,32	для СБИС типа "Система на кристалле"; в) микросхем для технологий КМОП и КМОП-КНД** техническое переворуже- ние дизайн- центра позволит создать сквозную систему автоматизи- рованного проектирова- ния модулей типа "система в корпусе" (SIP-модулей) с сокращением на 30% продолжи- тельности цикла разработки,

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе								Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год			
Е.И. Забахина", г. Снежинск, Челябинская область												испытаний и изготовления SIP-модулей, расширить номенклатуру разрабатывае- мых приборов с использо- ванием указанной технологии до 12 наименова- ний и моделировать тепловые и механические процессы, происходящие в SIP-модулях, с учетом внешних воздействую- щих факторов **
Итого по Госкорпорации "Росатом"	<u>4506</u> 2253	<u>80</u> 40	<u>68</u> 34	<u>40</u> 20	<u>100</u> 50	<u>540</u> 270	<u>1200</u> 600	<u>1360</u> 680	<u>1118</u> 559			

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			

Федеральное космическое агентство (Роскосмос)

1. Реконструкция и техническое перевооружение действующих радиоэлектронных производств

315. Реконструкция и техническое перевооружение открытого акционерного общества "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем", г. Москва, в целях создания производства многокристалльных систем в корпусе, микро- и радиоэлектронных модулей, в том числе на основе устройств микро-системной техники; оснащенное отраслевое автоматизи-рованное хранение производимых и приобретае-мых элементов	$\frac{320}{160^*}$					<u>110</u>	<u>105</u>	<u>105</u>	<u>105</u>	2013- 2015	1230 ***	переоснащен- ное производство много- кристалльных систем в корпусе, микро- и радио- электронных модулей, в том числе на основе устройств микро- системной техники; оснащенное отраслевое автоматизи- рованное хранение производимых и приобретае- мых элементов
---	---------------------	--	--	--	--	------------	------------	------------	------------	---------------	-------------	--

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе					Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты		
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год				2013 год	2014 год
316. Реконструкция и техническое первооружение открытого акционерного общества "Научно- исследователь- ский институт точных приборов", г. Москва, для создания производства модулей сверхвысоко- частотных устройств для особо жестких условий эксплуатации	<u>320</u> 160*					<u>200</u> 100	<u>60</u> 30	<u>60</u> 30	2013 - 2015	1120***	переоснащение производства по выпуску: параметричес- кого ряда модулей сверхвысоко- частотных устройств; узлов и крупно- блочных радио- электронных функциональ- ных модулей приемо- передающей аппаратуры. Реализация указанных мероприятий обеспечивает:
											со встроенной системой мониторинга и прогнозирована состояния хранимой ** продукции

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год				2015 год
317. Реконструкция и техническое переворужение открытого акционерного общества "Информацион- ные спутниковые системы" имени академика М.Ф.Решетнёва", г. Железнодорожск, Красноярский край, с целью создания производственной	$\frac{160}{80^*}$										сокращение сроков изготовления изделий радио- локационной техники и техники связи в 2 - 3 раза; расширение номенклатуры сверхвысоко- частотных изделий в 1,5 раза	
									$\frac{60}{30}$	$\frac{50}{25}$	$\frac{50}{25}$	переснащение производст- венной линии для выпуска облегченных сверхвысоко- частотных волноводов; увеличение производства сверхвысоко- частотных волноводов с низким уровнем потерь и

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			
линии для изготовления облегченных сверхвысокочас- тотных волноводов миллиметрового диапазона											улучшенными массовыми характеристи- ками; оснащение отраслевого автоматизи- рованного хранилища для модулей радио- электронных и навигацион- ных систем со встроенной системой мониторинга и прогнозирована ния состояния хранимой ** продукции
318. Реконструкция и техническое переворужение федерального государственного унитарного предприятия "Научно- производственное	<u>200</u> 100*										дооснащение производства электро- механических и радио- электронных компонентов для микромодуль-
										<u>80</u> 40	
										<u>60</u> 30	
										<u>60</u> 30	
										2013 - 2015	
										<u>60</u> 30	
										<u>60</u> 30	
										665***	

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе								Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год			
объединение автоматики имени академика Н.А.Семихатова", г. Екатеринбург, для создания производства электромехани- ческих и радиоэлектрон- ных компонентов микромодульных средств автономного управления и контроля												ных средств автономного управления и контроля; увеличение производства изделий торговой и промышлен- ной радио- электроники на 35 процентов и более; оснащение отраслевого автоматизи- рованного хранилища для радио- электронных модулей со встроенной системой мониторинга и прогнозирована стояния хранимой ** продукции

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе								Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год			
319. Реконструкция и техническое переворужение открытого акционерного общества "Научно- исследователь- ский институт космического приборостроения", г. Москва, для создания отраслевой лаборатории контроля стойкости электронной компонентной базы радиоэлектронной аппаратуры к дестабилизи- рующим факторам космического пространства	$\frac{200}{100}^*$						$\frac{80}{40}$	$\frac{60}{30}$	$\frac{60}{30}$	2013 - 2015	690 ^{***}	создание межотраслевой лаборатории контроля стойкости электронной компонентной базы для специальной радио- электронной аппаратуры в условиях космического пространства, что обеспечит внедрение технологичес- ких процессов прямого (в том числе неразруша- ющего) контроля стойкости электронной компонентной базы и эксперимен- тально- аналитичес-

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			
<p>ный центр "Полос", г. Томск, для технического переворужения действующего производства</p>											<p>пассивных радио- элементов для систем торговой и промышлен- ной радио- электроники и вторичных источников питания с совмещенными линиями передачи данных и электро- питания, расширение номенклатуры и увеличение производства встроенных вторичных источников питания с совмещен- ными линиями передачи данных и электро- питания для</p>

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты			
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год				2015 год		
321. Реконструкция и техническое первооружение федерального государственного унитарного предприятия "Научно- исследова- тельский институт микро- приборов - К", г. Москва, для создания матричных оптико- электронных модулей на основе кремниевых мембран и гетеропереходов	$\frac{200}{100}^*$								$\frac{80}{40}$	$\frac{60}{30}$	$\frac{60}{30}$	2013 - 2015	770 ^{***}	переоснащение производства матричных оптико- электронных модулей для работы в составе оптико- электронных преобразова- телей высокого разрешения и матричных сверхвысоко- частотных приборов для модулей фазированных антенных решеток, что позволит

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			

на основе
арсенида
галлия и нитрида
галлия

расширить
номенклатуру
выпускаемой
мелкосерийной
продукции в
2 раза,
увеличить
объем
выпускаемых
дискретных и
модульных
элементов в
10 раз**

2. Реконструкция и техническое перевооружение для создания базовых центров системного проектирования

322. Реконструкция и техническое перевооружение открытого акционерного общества "Российская корпорация ракетно- космического приборостроения и информационных систем", г. Москва, для	<u>726</u> 363*	<u>486</u> 243	<u>240</u> 120	2012 - 2013	570	создание базового центра системного проектирова- ния площадью 570 кв. м
---	--------------------	-------------------	-------------------	----------------	-----	---

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			
создания базового центра проектирования											
323. Реконструкция и техническое переворужение для создания отраслевого центра автоматизирован- ного проектирования в открытом акционерном обществе "Научно- исследователь- ский институт точных приборов", г. Москва	$\frac{914}{461^*}$	$\frac{120}{60}$	$\frac{28}{18}$	$\frac{160}{80}$	$\frac{486}{243}$				2008 - 2012	500	создание отраслевого центра автоматизиро- ванного проектирова- ния и функциональ- ной поддержки процессов изготовления и эксплуатации параметричес- ких рядов сверхвысоко- частотных модулей унифициро- ванных сверхвысоко- частотных трактов, базовых несущих конструкций активных фазированных

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе								Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год			
324. Реконструкция и техническое первооружение для создания центра проектирования унифицирован- ных микроэлектрон- ных датчиков для работы в особо жестких условиях эксплуатации в открытом акционерном обществе "Научно- исследователь- ский институт физических измерений", г. Пенза	<u>280</u> 140*						<u>100</u> 50	<u>90</u> 45	<u>90</u> 45	2013 - 2015	380 ***	антенных решеток, радио- локационных и связных модульных приборов площадью 500 кв. м создание центра проектирова- ния унифициро- ванных микро- электронных датчиков площадью 380 кв. м для проектирова- ния унифициро- ванных полупровод- никовых микродатчиков и преобразова- телей физических величин в системах

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе								Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год			
325. Реконструкция и техническое переворужение для создания базового центра системного проектирования интегральных микроэлектрон- ных датчиков и датчиков- преобразующей аппаратуры в открытом акционерном обществе "Научно- производственное объединение измерительной техники", г. Королев, Московская область	140 70*						80 40	60 30		2013 - 2014	350 ***	управления, контроля и диагностики динамических объектов создание базового центра площадью 350 кв. м для системного проектирова- ния с полным циклом проектирова- ния и производства параметричес- кого ряда интегральных микро- электронных датчиков и нанодатчиков для контрольной аппаратуры на основе специализи- рованных

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			
326. Реконструкция и техническое первооружение для создания центра проектирования матричных преобразователей и микроэлектрон- ных сигнальных процессоров на федеральном государственном унитарном предприятии "Научно- производствен- ный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А.Пилюгина", г. Москва	$\frac{200}{100}^*$						$\frac{160}{80}$	$\frac{40}{20}$	2013 - 2014	220 ^{***}	создание центра системного проектирова- ния матричных преобразовате- лей и микро- электронных сигнальных процессоров высокооточных навигацион- ных приборов бортового и промышлен- ного назначения с использова- нием прецизионного высоко- технологич-

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			
327. Реконструкция и техническое переворужение для создания базового центра системного проектирования и технического переворужения	$\frac{148}{74}^*$										создание базового центра сквозного системного проектирова- ния и функциональ- ной поддержки
									$\frac{80}{40}$	2013 - 2015	300 ^{***}
									$\frac{34}{17}$		
									$\frac{34}{17}$		

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			
действующего производства в открытом акционерном обществе "Информацион- ные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва", г. Железнодорожск, Красноярский край		120	120	28	160	972	1350	679	579		в процессе эксплуатации аппаратуры модульных средств связи и навигации для бортовых и промышлен- ных систем площадью 300 кв. м**
Итого по Роскосмосу	4008 2008	120 60	120 60	28 18	160 80	972 486	1350 675	679 339,5	579 289,5		
Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)											
Реконструкция и техническое перевооружение для создания базовых центров системного проектирования											
328. Техническое перевооружение государственного образовательного учреждения высшего профессиональ- ного образования "Московский государственный	78 54*	48	24	30	30					2009 - 2010	создание базового центра системного проектирова- ния площадью 515,1 кв. м**

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год				2015 год
институт электронной техники" (технический университет), г. Москва, для создания базового центра проектирования												
329. Реконструкция и техническое первооружение государственного образовательного учреждения высшего профессиональ- ного образования "Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики" (технический университет), г. Москва, для создания базового центра проектирования	<u>50</u> 25								<u>50</u> 25	2008	500	создание базового центра системного проекти- рования площадью 500 кв. м

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			
330. Техническое перевооружение федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет", г. Томск, для создания базового центра проектирования	<u>200</u> 100*					<u>200</u> 100			2012	400	создание базового центра системного проектирования площадью ^{**} 400 кв. м
331. Реконструкция и техническое перевооружение федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования	<u>200</u> 100*							<u>200</u> 100	2013	400 ^{***}	создание базового центра системного проектирования площадью ^{**} 400 кв. м

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год				2015 год
"Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана", г. Москва, для создания базового центра проектирования												
332. Реконструкция и техническое переворужение федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессиональ- ного образования "Южный федеральный университет", г. Ростов-на- Дону, для создания базового центра проектирования	<u>200</u> 100*								<u>200</u> 100	2013	400***	создание базового центра системного проектирова- ния площадью** 400 кв. м

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе								Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год			
333. Реконструкция и техническое переворужение федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессиональ- ного образования "Новосибирский национальный исследователь- ский государственный университет", г. Новосибирск, для создания базового центра проектирования	<u>200</u> 100*						<u>100</u> 50	<u>100</u> 50	2014 - 2015	400***	создание базового центра системного проектирова- ния площадью** 400 кв. м	
334. Реконструкция и техническое переворужение федерального государственного образовательного учреждения высшего профессиональ-	<u>230</u> 115*						<u>115</u> 57,5	<u>115</u> 57,5	2014 - 2015	600***	создание базового центра системного проектирова- ния площадью** 600 кв. м	

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			

ного образования
"Санкт-
Петербургский
государственный
университет",
г. Санкт-
Петербург,
для создания
базового центра
проектирования

335. Техническое
переворужение в
целях создания
базового центра
проектирования в
федеральном
государственном
автономном
образовательном
учреждении
высшего
профессиональ-
ного образования
"Национальный
исследователь-
ский ядерный
университет
"МИФИ",
г. Москва

80

40

40

600***

2013 -
2014

создание
базового
центра
системного
проектирова-
ния площадью
**
600 кв. м

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			
336. Техническое перевооружение в целях создания базового центра проектирования в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального образования "Московский физико-технический институт (государственный университет)", г. Москва	80 *****					40	40		2013 - 2014	600 ***	создание базового центра проектирования площадью ** 600 кв. м
Итого по Минобрнауки России	<u>1318</u> 594	<u>50</u> 25	<u>48</u> 24	<u>30</u> 30		<u>200</u> 100	<u>295</u> 107,5	<u>215</u> 107,5			
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России)											
Реконструкция и техническое перевооружение действующих радиоэлектронных производств											
337. Техническое перевооружение федерального	<u>200</u> 100 *****				66,76	<u>133,24</u> 33,38	66,62		2011 - 2012	2000	создание новых производств

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации	Площадь объекта (кв. м.)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			
государственного унитарного предприятия "Производствен- ное объединение "Октябрь", г. Каменск- Уральский, Свердловская область											венных мощностей по выпуску оптоволокон- ных соединителей изделий микро- механики**
Итого по ФСТЭК России	<u>200</u> 100				<u>66,76</u> 33,38	<u>133,24</u> 66,62					
Итого по разделу II	<u>80712,25</u> 41976,79	<u>1868,71</u> 1392,7	<u>1879,48</u> 1530,71	<u>2223,3</u> 1763	<u>6066,76</u> 3033,38	<u>20311,76</u> 10155,88	<u>18056,4</u> 48988,22	<u>15141,6</u> 87530,84	<u>15164,12</u> 7582,06		

* Размеры финансирования будут уточнены после утверждения в установленном порядке проектно-сметной документации.

** Конкретный состав оборудования и работ будет определен на этапе технико-экономического обоснования.

*** Мощность объекта может быть уточнена на стадии разработки проекта.

**** Объемы скорректированы и полностью возвращены в бюджет.

***** Вопрос бюджетного финансирования (в 2013 году - в объеме 400 млн. рублей, в 2014 году - в объеме 80 млн. рублей) будет рассмотрен в ходе исполнения Федерального закона "О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" при корректировке Программы в 2013 году.

***** Объемы финансирования в 2013 году будут уточнены в ходе исполнения Федерального закона "О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" при корректировке Программы в 2013 году.

Примечания: 1. Срок получения предусмотренных настоящим приложением результатов работ соответствует году окончания их финансирования.

2. В числителе указывается общая стоимость работ, в знаменателе - размер финансирования за счет средств федерального бюджета.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к федеральной целевой программе
"Развитие электронной компонентной базы
и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 22 апреля 2013 г. № 359)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

объемов финансирования за счет средств федерального бюджета по государственному заказчику федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Всего по Программе	104663,296	5372,7	5772,01	54000	12963,38	25180	18619	16001,646	15354,56
из них:									
Минпромторг России	91115,91	4757,7	5157,21	4952,62	11940	21953,26	15538,5	13624,56	13192,06
Роскосмос	6064,5	290	320	168	430	1776	1473	824	783,5
Госкорпорация "Росатом"	5877,586	240	246,5	179,38	400	1124,12	1265	1293,586	1129
Минобрнауки России	1505,3	85	48,3	100	160	260	342,5	259,5	250
ФТЭК России	100	-	-	-	33,38	66,62	-	-	-

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Капитальные вложения - всего	41976,79	1392,7	1530,71	1763	3033,38	10155,88	8988,22	7530,84	7582,06
из них:									
Минпромторг России	37021,79	1267,7	1412,71	1695	2870	9233,26	7513,22	6403,84	6626,06
Роскосмос	2008	60	60	18	80	486	675	339,5	289,5
Госкорпорация "Росатом"	2253	40	34	20	50	270	600	680	559
Минобрнауки России	594	25	24	30	-	100	200	107,5	107,5
ФСТЭК России	100	-	-	-	33,38	66,62	-	-	-
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - всего	62686,506	3980	4241,3	3637	9930	15024,12	9630,78	8470,806	7772,5
из них:									
Минпромторг России	54094,12	3490	3744,5	3257,62	9070	12720	8025,28	7220,72	6566
Роскосмос	4056,5	230	260	150	350	1290	798	484,5	494
Госкорпорация "Росатом"	3624,59	200	212,5	159,38	350	854,12	665	613,586	570
Минобрнауки России	911,3	60	24,3	70	160	160	142,5	152	142,5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к федеральной целевой программе
"Развитие электронной компонентной базы
и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы
(в редакции постановления Правительства
Российской Федерации
от 22 апреля 2013 г. № 359)

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники"
на 2008 - 2015 годы за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Всего по Программе	175613,905	7903,837	8478,112	8267,417	20961,76	42829,41	32502,61	27847,889	26822,87
в том числе:									
федеральный бюджет	104663,296	5372,7	5772,01	5400	12963,38	25180	18619	16001,646	15354,56
внебюджетные средства	70950,609	2531,137	2706,102	2867,417	7998,38	17649,41	13883,61	11846,243	11468,31
Капитальные вложения - всего	80712,25	1868,71	1879,48	2223,3	6066,76	20311,76	18056,44	15141,68	15164,12
в том числе:									
федеральный бюджет	41976,79	1392,7	1530,71	1763	3033,38	10155,88	8988,22	7530,84	7582,06
внебюджетные средства	38735,46	476,01	348,77	460,3	3033,38	10155,88	9068,22	7610,84	7582,06
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - всего	94901,655	6035,127	6598,632	6044,117	14895	22517,65	14446,17	12706,209	11658,75

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год

в том числе:

федеральный бюджет

внебюджетные средства

62686,506	3980	4241,3	3637	9930	15024,12	9630,78	8470,806	7772,5
32215,149	2055,127	2357,332	2407,117	4965	7493,53	4815,39	4235,403	3886,25"

6. В приложении № 5 к указанной Программе:

- а) в абзаце пятнадцатом цифры "179224,366" заменить цифрами "175613,905", цифры "106844,71" заменить цифрами "104663,296", цифры "72379,66" заменить цифрами "70950,609", цифры "64554,9" заменить цифрами "66746,5", цифры "131640" заменить цифрами "125754,3";
- б) в абзаце шестнадцатом цифры "203443,4" заменить цифрами "196247,7";
- в) в абзаце семнадцатом цифры "7,9" заменить цифрой "7";
- г) в абзаце восемнадцатом цифры "1,54" заменить цифрами "1,57";
- д) таблицы 1 - 3 изложить в следующей редакции:

"Таблица 1

Исходные данные, принятые для расчета коммерческой и бюджетной эффективности реализации Федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы

(в ценах соответствующих лет, млн. рублей)

Показатели	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	За
	год	год	год	год	год	год	год	год	год	год	расчетный период

Условно-переменная часть текущих издержек производства (себестоимости) (процентов)	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	-
--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---

Годовой объем реализуемой продукции отрасли (объем продаж)	58000	70000	90000	110000	170000	210000	240000	270000	340000	420000	-
--	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---

Показатели	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	За расчетный период
Инвестиции из всех источников финансирования - всего по Программе	7903,8378478,1128267,417	20961,8	42829,41	32502,61	27847,88926822,87	-	-	-	-	-	175613,905
в том числе:											
средства федерального бюджета на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	5372,7	5772,01	5400	12963,38	25180	18619	16001,65	15354,56	-	-	104663,296
капитальные вложения и прочие нужды											
из них											
капитальные вложения	1392,7	1530,71	1763	3033,38	10155,88	8988,22	7530,84	7582,06	-	-	41976,79
внебюджетные средства на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и капитальные вложения (собственные, заемные и др.)	2531,1372706,1022867,417	7998,38	17649,41	13883,61	11846,243	11468,31	-	-	-	-	70950,609

Показатели	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	За расчетный период
налогооблагаемая база налога на имущество (среднегодовая стоимость основных промышленно- производственных фондов отрасли по остаточной стоимости)	33000	34500	36000	38000	41000	46000	54000	60000	61000	62000	-
Рентабельность реализованной продукции (процентов)	10	10	12	14	16	18	20	20	20	20	-
Амортизационные отчисления (процентов себестоимости)	3,5	3,8	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	-
Материалы (процентов себестоимости)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-
Фонд оплаты труда (процентов себестоимости)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-
Налог на имущество организаций (процентов)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-
Налог на прибыль организаций (процентов)	24	20	20	20	20	20	20	20	20	20	-

Показатели	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	За расчетный период
Налог на доходы физических лиц (процентов)	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	-
Страховые взносы (процентов)	26	26	26	34	30	30	30	30	30	30	-
Налог на добавленную стоимость (процентов)	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	-
Норма дисконта (средняя за расчетный период) (процентов)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1

**Расчет коммерческой и бюджетной эффективности реализации федеральной целевой программы
"Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы**

(в ценах соответствующих лет, млн. рублей)

Наименование показателей	Расчетный период										За расчетный период
	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	номер шага (m)										

Операционная и инвестиционная деятельность (коммерческая эффективность)

Годовой объем реализованной продукции отрасли без налога на добавленную стоимость	58000	70000	90000	110000	170000	210000	240000	270000	340000	420000	-
Себестоимость годового объема реализованной продукции отрасли	52727	63636	80357	96491	146552	177966	200000	225000	283333	350000	-
Прибыль от реализации продукции	5273	6364	9643	13509	23448	32034	40000	45000	56667	70000	-
Налогооблагаемая база налога на имущество (среднегодовая стоимость основных промышленно-производственных фондов отрасли по остаточной стоимости)	33000	34500	36000	38000	41000	46000	54000	60000	61000	62000	-

Наименование показателей	Расчетный период									За расчетный период	
	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год		2017 год
	0	1	2	3	4	5	6	7	8		9
	номер шага (m)										
Налог на имущество организаций	660	690	720	760	820	920	1080	1200	1220	1240	-
Налогооблагаемая прибыль	4587,3	5727,3	8967,9	12833,3	22744,8	31072,9	38800	43650	54966,7	67900	-
Налог на прибыль организаций	1100,9	1145,5	1793,6	2566,7	4549	6214,6	7760	8730	10993,3	13580	-
Чистая прибыль	3486,3	4581,8	7174,3	10266,7	18195,9	24858,3	31040	34920	43973,3	54320	-
Амортизационные отчисления в структуре себестоимости	1845,5	2418,2	3214,3	4342,1	7327,6	9788,1	12000	14625	19833,3	26250	-
Материальные затраты в структуре себестоимости	26363,6	31818,2	40178,6	48245,6	73275,9	88983,1	100000	112500	141666,7	175000	-
Фонд оплаты труда в структуре себестоимости	13181,8	15909,1	20089,3	24122,8	36637,9	44491,5	50000	56250	70833,3	87500	-
Налог на добавленную стоимость	4745,5	5727,3	7232,1	8684,2	13189,7	16016,9	18000	20250	25500	31500	-
Налог на доходы физических лиц	1713,6	2068,2	2611,6	3136	4762,9	5783,9	6500	7312,5	9208,3	11375	-

Наименование показателей	Расчетный период										За расчетный период
	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Страховые взносы	3427,3	4136,4	5223,2	8201,8	10991,4	13347,5	15000	16875	21250,3	26250	-
Налоги, поступающие в бюджет и внебюджетные фонды (приток в бюджет)	10546,4	12631,8	15787	20781,9	29764	36068,3	40580	45637,5	57178,3	70365	339330,2
Сальдо от операционной деятельности. Чистый доход организаций (чистая прибыль и амортизационные отчисления)	5331,8	7000	10388,6	14608,8	25523,4	34646,4	43040	49545	63806,7	80570	-
Коэффициент дисконтирования (норма дисконта E=0,1)	1	0,909	0,826	0,751	0,683	0,621	0,564	0,513	0,467	0,424	-
Сальдо от операционной деятельности с учетом дисконтирования. Чистый доход организаций с учетом дисконтирования	5331,8	6363,6	8585,6	10975,8	17432,9	21512,7	24295	25424,4	29766,3	34169,5	183857,6
Величина инвестиций из всех источников финансирования (отлоки)	7903,8	8478,1	8267,4	20961,8	42829,4	32502,6	27847,9	26822,9	-	-	175613,905

Наименование показателей	Расчетный период										За расчетный период
	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Сальдо суммарного потока от инвестиционной и операционной деятельности без дисконтирования	-2572,1	-1478,1	2121,2	-6353	-17306	2143,8	15192,1	22722,1	63806,7	80570	-
Величина инвестиций из всех источников финансирования (оттоки) с учетом дисконтирования	7903,8	7707,4	6832,6	15748,9	29253,1	20181,6	15719,4	13764,4	-	-	117111,1
Сальдо суммарного потока от инвестиционной и операционной деятельности с учетом дисконтирования	-2572,1	-1343,7	1753	-4773,1	-11820,2	1331,2	8575,6	11660	29766,3	34169,5	66746,5
Сальдо накопленного суммарного потока от инвестиционной и операционной деятельности с учетом дисконтирования (нарастающим итогом)											

Наименование показателей	Расчетный период										За расчетный период
	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Чистый дисконтированный доход	-2572,1	-3915,8	-2162,8	-6935,9	-18756,1	-17424,9	-8849,4	2810,7	32577	66746,5	-
Срок окупаемости инвестиций (период возврата) (лет)											7 лет
Индекс доходности (рентабельность инвестиций)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,57
Финансовая и операционная деятельность (бюджетная эффективность)											
Средства федерального бюджета на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, капитальные вложения и прочие нужды (отток из бюджета)	5372,7	5772,01	5400	12963,4	25180	18619	16001,6	15354,6	-	-	104663,3
Налоги, поступающие в бюджет и внебюджетные фонды	10546,4	12621,8	15787	20781,9	29764	36068,3	40580	45637,5	57178,3	70365	339330,2

Наименование показателей	Расчетный период										За расчетный период
	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Налоги, поступающие в бюджет и внебюджетные фонды с учетом дисконтирования	10546,4	11474,4	13047,1	15613,8	20329,2	22395,6	22906,4	23419,3	26674,1	29841,6	196247,7
Отток бюджетных средств	5372,7	5772	5400	12963,4	25180	18619	16001,6	15354,6	-	-	-
Отток бюджетных средств с учетом дисконтирования	5372,7	5247,3	4462,8	9739,6	17198,3	11560,9	9032,5	7879,3	-	-	70493,41
Сальдо суммарного потока от финансирования и операционной деятельности с учетом дисконтирования	5173,7	6227,1	8584,3	5874,2	3130,9	10834,6	13873,8	15539,9	26674,1	29841,6	125754,3
Чистый дисконтированный доход государства или бюджетный эффект	5173,7	11400,8	19985	25859,2	28990,1	39824,8	53698,6	69238,6	95912,7	125754,3	-
Индекс доходности бюджетных средств	2	2,2	2,9	1,6	1,2	1,9	2,5	2,9	-	-	2,8

Наименование показателей	Расчетный период										За расчетный период
	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	номер шага (m)										
Налоги, поступающие в бюджет и внебюджетные фонды с учетом дисконтирования	10546,4	11474,4	13047,1	15613,8	20329,2	22395,6	22906,4	23419,3	26674,1	29841,6	196247,7
Удельный вес средств федерального бюджета в общем объеме финансирования (степень участия государства)	0,68	0,68	0,65	0,62	0,59	0,57	0,58	0,57	-	-	0,6
Период возврата бюджетных средств (лет)											1 год
Уровень безубыточности	0,79	0,79	0,76	0,73	0,7	0,68	0,66	0,66	0,66	0,66	0,68

**Итоговые показатели эффективности реализации федеральной
целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и
радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы**

(млн. рублей)

Наименование показателей	2008 - 2017 годы
Всего инвестиций (в ценах соответствующих лет)	175613,905
в том числе:	
средства федерального бюджета	104663,3
внебюджетные средства	70950,61
Показатели коммерческой эффективности	
Чистый дисконтированный доход в 2017 году	66746,5
Срок окупаемости инвестиций по чистой прибыли организации (лет)	7 лет
Индекс доходности (рентабельность) инвестиций по чистой прибыли	1,57
Уровень безубыточности	0,68
Показатели бюджетной эффективности	
Налоги, поступающие в бюджет и внебюджетные фонды с учетом дисконтирования	196247,7
Бюджетный эффект	125754,3
Индекс доходности (рентабельность) бюджетных ассигнований по налоговым поступлениям	2,8

Наименование показателей	2008 - 2017 годы
Удельный вес средств федерального бюджета в общем объеме финансирования (степень участия государства)	0,6
Срок окупаемости бюджетных ассигнований по налоговым поступлениям (лет)	1 год".

7. В разделе "Показатели бюджетной эффективности" приложения № 6 к указанной Программе:

а) абзацы десятый и одиннадцатый изложить в следующей редакции:

"налог на имущество организаций в размере, не превышающем 2,2 процента среднегодовой стоимости основных промышленно-производственных фондов по остаточной стоимости;

налог на прибыль организаций в размере 20 процентов налогооблагаемой прибыли (прибыли от реализации за вычетом налога на имущество организаций);";

б) абзацы тринадцатый и четырнадцатый изложить в следующей редакции:

"налог на доходы физических лиц в размере 13 процентов фонда оплаты труда;

страховые взносы в размере 30 процентов фонда оплаты труда;".